ผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ อะลูมินาและทั้งสเตนคาร์ไบด์

นางสาวจิราพร บุญพอ

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ลิขลิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



EFFECTS OF ADDITIVES ON MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF ALUMINA/TUNGSTEN CARBIDE COMPOSITES

Miss Jiraporn Boonpo

สูนย์วิทยทรัพยากร

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Ceramic Technology Department of Materials Science Faculty of Science Chulalongkorn University Academic Year 2010 Copyright of Chulalongkorn University

530562

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของ
	วัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทั้งสเตนคาร์ไบด์
โดย	นางสาวจิราพร บุญพอ
สาขาวิชา	เทคโนโลยีเซรามิก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	อาจารย์ ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	อาจารย์ ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล

(ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

A รอบรี เพิ่งจาสาคา ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรธันว์ เจียมศิริเลิศ)

Ammes Marguan อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(อาจารย์ ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์)

ณ์ ฏิรู้ m (วามกรักกุล) (อาจารย์ ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร วาสนาเพียรพงศ์)

.... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(อาจารย์ ดร. จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกูล)

จิราพร บุญพอ : ผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของ วัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทั้งสเตนคาร์ไบด์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อาจารย์ ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : อาจารย์ ดร. ณัฏฐิตา ขวนเกริกกุล, 104 หน้า.

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของสารเติมแต่งเซอร์โคเนีย 2 ชนิด คือ Mo-PSZ และ Ca-PSZ ต่อสมบัติทางกายภาพและทางกล ตลอดจนโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบ อะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ การทดลองในงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษา ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่เติมและไม่เติม สารเติมแต่งและเผาผนึก ณ อุณหภูมิช่วง 1400 ถึง 1600 องศาเขลเขียล ส่วนที่สองเป็น การศึกษาผลของปริมาณลารเติมแต่ง Mg-PSZ และ Ca-PSZ ในวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทั้งสเตนคาร์ไปด์ โดยใช้ปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 0 1.5 3.0 4.5 และ 6.0 โดยน้ำหนัก จาก การทดลองพบว่าอุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส ทำให้วัสดุมีสมบัติทางกลดีที่สุดและวัสดุทุก ชนิดมีความหนาแน่นมากกว่า 95%TD อะลูมินาบริสุทธิ์มีการโตของเกรนซึ่งส่งผลให้สมบัติ ทางกลต่ำ การเสริมแรงอะลูมินาด้วยทั้งสเตนคาร์ไบด์ก่อให้เกิดการยับยั้งการโตของเกรนใน โครงสร้างจุลภาคส่งผลให้ความแข็งสูงถึง 19 กิกะพาสคัล นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อ การดัดโค้งสูงกว่าอะลูมินาบริสุทธิ์โดยมีค่าเท่ากับ 324 เมกะพาสคัล ส่วนการเบี่ยงเบนของ รอยแตกที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยส่งผลให้ความเหนียวมีค่าใกล้เคียงกันกับอะลูมินาโดยมี ความเหนียวเท่ากับ 3.8 เมกะพาสคัล.เมตร^{1/2} ลำหรับการเติมแต่งวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทั้งสเตนคาร์ไบด์ด้วย Mg-PSZ และ Ca-PSZ ส่งผลให้ความเหนียวของวัสดุขนิดนี้มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นตามปริมาณของสารเติมแต่งโดยมีความเหนียวสูงที่สุดเท่ากับ 5 เมกะพาสคัล.เมตร¹² และ 5.7 เมกะพาสคัล.เมตร^{1/2}ตามลำดับ แต่ให้ความหนาแน่น ความแข็งและความต้านทาน ต่อการดัดโค้งที่ลดลง วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์เสริมแรงด้วยเซอร์โคเนียและ เตรียมด้วยการอัดและเผาแบบธรรมดาให้ค่าความเหนียวในช่วงเดียวกันกับวัสดุตัดเนื้อพื้น อะลูมินาทางการค้า แต่สมบัติด้านอื่นๆ ยังคงจำเป็นต้องปรับปรุงต่อไป

ภาควิชา วัตดุศาสตร์	ลายมือชื่อนิสิต วิราพร บุพพผ
สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิก	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 🖉 🦛 🥎
ปีการศึกษา 2553	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม <u>หัญรีกา</u> ช _{ังนะกรกฎล}

5172246423 : MAJOR CERAMIC TECHNOLOGY KEYWORDS : CUTTING TOOL MATERIALS / CERAMIC MATRIX COMPOSITE / Al₂O₂/WC COMPOSITE / PARTIALLY STABILIZED ZIRCONIA

JIRAPORN BOONPO : EFFECS OF ADDITIVES ON MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF ALUMINA/TUNGSTEN CARBIDE COMPOSITES. THESIS ADVISOR : WANTANEE BUGGAKUPTA, Ph. D., THESIS CO-ADVISOR : NUTTHITA CHUANKRERKKUL, Ph. D., 104 pp.

The project focuses on a variation in physical and mechanical properties of the alumina/tungsten carbide composites as a presence of two type of partially stabilized zirconia additives : Mg-PSZ and Ca-PSZ. This experiment was divided in two parts. The first part was study the effect of sintering temperatures between 1400 °C and 1600 °C on the properties of the Al₂O₂/WC composites with and without additives. The effects of the Mg-PSZ and Ca-PSZ contents ranging from 0 - 6 wt% on the properties of the Al₂O₂/WC composites, sintered at 1600 °C for 2 hours were investigated in the second part. High density values up to 95%TD were achieved at 1600 °C for all materials, and provided acceptable mechanical properties. A grain growth in monolithic Al₂O₃ resulted in poor mechanical properties at this temperature. The hardness value of 19 GPa and flexural strength of 324 MPa was obtained from the Al₂O₃ reinforced with WC particles due to grain growth inhibition, whereas the fracture toughness of composites was similar to the monolithic Al2O3 because of slight crack deflection around WC particles. Compared to the non-additive composition, the presence of Mg-PSZ and Ca-PSZ enhanced the fracture toughness of the Al₂O₃/WC composites from 3.8 MPa.m^{1/2} to 5 MPa.m^{1/2} and 5.7 MPa.m^{1/2}, respectively. The Al₂O₂/WC reinforced with partially stabilized zirconia and prepared by conventional powder processing can provide a product with fracture toughness in the same range of the commercial alumina matrix cutting tools, however, other properties are still needed to be improved.

Department : Materials Science	Student's Signature
Field of Study : Ceramic Technology	Advisor's Signature
Academic Year : 2010	Co-Advisor's Signature Nuttle ta Chuander rolling

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณความช่วยเหลือทั้งในด้านวิชาการ และ การดำเนินการวิจัย จากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์ และอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล ที่ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ และช่วยชี้แนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการทำงานวิจัยและการดำเนินชีวิต

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทุกท่านที่ให้ความรู้และคำชี้แนะ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านสำหรับคำแนะนำและการตรวจแข้ไขรูปเล่ม วิทยานิพนธ์ จนทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ชิเกตากะ วาดะ ที่เอื้อเฟื้อผงอะลูมินาและผงตัวเติม ดร.กุลจิรา สุจิโรจน์ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ที่เอื้อเฟื้อผงทังสเตนคาร์ไบด์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ ที่เอื้อเฟื้อพอลิไวนิลบิวทิรอล พร้อมทั้งให้ความรู้ และคำขี้แนะในการใช้เครื่องมือต่างๆ

ขอขอบคุณ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง (ADB) ที่ ให้ทุนสนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดทั้งทุนที่ใช้ในการทำงานวิจัย

ขอขอบคุณวิรพงษ์ ครพนม เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องมือ XRD และคุณธนากร เทพามาตย์ เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องมือ SEM จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ผลการทดลอง

ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเขรามิกทุกคนที่คอยให้ กำลังใจและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ มาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณพ่อและคุณแม่ ที่ให้การอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู คอยเป็นกำลังใจ พร้อมทั้ง มอบโอกาสและประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้าเสมอมา และขอขอบคุณแรงสนับสนุนจากสมาชิกทุก คนในครอบครัวในการทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จได้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	٩٩
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	۹
กิตติกรรมประกาศ	น
สารบัญ	ป
สารบัญตาราง	រូ
สารบัญภาพ	j
คำอธิบายสัญลักษณ์และค <mark>ำย่อ</mark>	Ø
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและ <mark>ความสำคัญของปัญหา</mark>	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมแล <mark>ะงาน</mark> วิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 วัสดุตัด	4
2.1.1 ประเภทและสมบัติขอ <mark>งวัสดุตัด</mark>	4
2.1.2 วัสดุตัดเซรามิก	9
2.2 วัสดุเชิงประกอบ (Composite materials)	11
2.2.1 วัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นเซรามิก (Ceramic matrix composites, CMCs)	12
	13
	13
2.3.2 ทั้งสเตนคาร์ไบด์	14
2.3.3 การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์	16
2.4 เซอร์โคเนีย	20
2.4.1 โครงสร้างผลึกของเซอร์โคเนีย	20
2.4.2 รปแบบเสถียรของเซอร์โคเนีย	21
2.4.3 กลไกการเพิ่มความเหนียว (Transformation toughening)	25
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	27
3.1 วัตถดิบและสารเคมี	27

3.2	2 ระเบีย	บบวิธีทดลอง	. 27
	3.2.1	การออกแบบการทดลอง	. 27
	3.2.2	การเตรียมตัวอย่าง	. 28
3.3	3 การต	รวจสอบลักษณะเฉพาะของผงวัตถุดิบ	. 32
	3.3.1	การกระจายขนาดของอนุภาค (Particle size distribution)	. 32
	3.3.2	สัณฐานวิทยา (Morphology)	. 32
	3.3.3	องค์ประกอบทางเฟส (Phase content)	. 32
3.4	1 การวิเ	คราะห์สมบัติของตัวอย่าง (Characterization)	. 33
	3.4.1	ความหนาแน่นของ <mark>ตัวอย่า</mark> ง (Density)	. 33
	3.4.2	การหาองค์ประกอบทางเฟสของตัว <mark>อย่าง (Phas</mark> e content)	. 34
	3.4.3	การทดสอบความแข็งและความเหนียว (Hardness and fracture toughness).	. 34
	3.4.4	การทดสอบความต้านทานต่อการดัดโค้ง (Flexural strength)	. 36
	3.4.5	การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (Microstructure)	. 36
บทที่ 4	ผลการ	รทดลองแล <mark>ะการอภิปรายผล</mark>	. 38
4.1	1 ลักษเ	นะเฉพาะขอ <mark>งผงวัตถุด</mark> ิบ	. 38
	4.1.1	การกระจายข <mark>นาด</mark> อนุภาค	. 38
	4.1.2	สัณฐานวิทยา	. 39
	4.1.3	องค์ประกอบทางเฟส	. 40
4.2	2 ผลขอ	งอุณหภูมิต่อ <mark>สมบัติของอะลูมินาและวัสดุเชิงประ</mark> กอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์	Í
	ที่มีแต	าะไม่มีสารเติมแต่ง	. 41
	4.2.1	ความหนาแน่น	. 42
	4.2.2	องค์ประกอบทางเฟส	. 43
	4.2.3	โครงสร้างจุลภาค	. 52
	4.2.4	ความแข็ง	. 57
	4.2.5	ความเหนียว	. 59
	4.2.6	ความต้านทานต่อการดัดโค้ง	. 62
4.3	3 ผลขอ	งชนิดและปริมาณของสารเติมแต่ง Mg-PSZ และ Ca-PSZ ต่อสมบัติของ	
	วัสดุเจ้	ชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์	. 65
	4.3.1	ความหนาแน่น	. 65
	4.3.2	องค์ประกอบทางเฟส	. 66
	4.3.3	โครงสร้างจุลภาค	. 69

4.3.4 ความแข็ง	74		
4.3.5 ความเหนียว	75		
4.3.6 ความต้านทานต่อการดัดโค้ง	76		
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	77		
5.1 สรุปผลการวิจัย	77		
5.2 ข้อเสนอแนะ			
รายการอ้างอิง79			
ภาคผนวก			
ภาคผนวก ก			
ภาคผนวก ข			
ภาคผนวก ค	102		
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์			



สารบัญตาราง

1	หนา
ตารางที่ 2.1 สมบัติและการใช้งานวัสดุตัดชนิดต่างๆ	6
ตารางที่ 2.2 ช่วงของอุณหภูมิที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างของ	
วัสดุเครื่องมือ	8
ตารางที่ 2.3 สมบัติของอะลูมินาบริสุทธิ์	14
ตารางที่ 2.4 สมบัติของทั้งสเตนคาร์ไบด์แล <mark>ะไดทั้ง</mark> สเตนคาร์ไบด์	16
ตารางที่ 3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการห <mark>าองค์ประกอบทางเฟสด้</mark> วยเครื่อง X- ray Diffractometer	32
ตารางที่ 3.2 ความหนาแน่นข <mark>องอะลูมินา</mark> ทังสเตน <mark>คาร์ไบด์ M</mark> g-PSZ และ Ca-PSZ	34



ศูนย์วิทยทรัพยากร ุลหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2

สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1	การพัฒนาความเร็วรอบในการตัดสำหรับวัสดุตัดแต่ละชนิดในช่วงเวลาต่างๆ5
รูปที่ 2.2	วัสดุตัดหลักๆ ที่ใช้กันทั่วโลกในปี ค.ศ. 20056
รูปที่ 2.3	ช่วงของความต้านทานแรงดึงและความแข็งวิกเกอร์ของวัสดุตัดทางการค้า7
รูปที่ 2.4	ความแข็งขณะร้อนของวัสดุตัดชนิดต่างๆ8
รูปที่ 2.5	วัสดุตัดเซรามิกชนิดต่างๆ : C1 <mark>– อะ</mark> ลูมินา (สีขาว), C2 – อะลูมินา/
	ไททาเนียมคาร์ไบด์ (<mark>สีด้ำ), C3 – ซิลิคอนในไต</mark> รด์, CT – เซอร์เมท,
	CBN – คิวบิกโบร <mark>อนไนไตรด์</mark>
รูปที่ 2.6	การแบ่งประเภท <mark>ของวัสดุเชิงป</mark> ระกอบต [่] ามลักษณะก ^า รเสริมแรง
รูปที่ 2.7	แผนภาพกลไก <mark>การเพิ่มความเหนียวในวัสดุเชิงประกอ</mark> บเนื้อพื้นเซรามิก
	(a) การเบี่ยงเ <mark>บนของรอยแตก</mark> (b) การบีบอัดของเนื้อพื้นเนื่องจากความเค้น
	(c) การเพิ่มค <mark>วามเหนียวด้วยการเปลี่ยนเฟส และ (d)</mark> รอยแตกระดับจุลภาค
	ของเนื้อพื้น
รูปที่ 2.8	โครงสร้างของอะล <mark>ูมินา</mark> 14
รูปที่ 2.9	เฟสไดอะแกรมของ <mark>ระ</mark> บบ W – C15
รูปที่ 2.10	้ส่วนประกอบภายในห้อ <mark>งอัดขึ้นรูปด้วยความ</mark> ร้อน
รูปที่ 2.11	รอยแตกในวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทั้งสเตนคาร์ไบด์
รูปที่ 2.12	โครงสร้างผลึกของเซอร์โคเนีย (a) มอโนคลินิก (b) เททระโกนัล และ (c) ลูกบาศก์21
รูปที่ 2.13	ลักษณะโครงสร้างของรูปแบบเสถียรของเซอร์โคเนีย
รูปที่ 2.14	เฟสไดอะแกรมของ MgO - ZrO ₂ 22
รูปที่ 2.15	เฟสไดอะแกรมของ CaO – ZrO ₂ 23
รูปที่ 2.16	เฟสไดอะแกรมของ Y ₂ O ₃ - ZrO ₂ 24
รูปที่ 2.17	(a) บริเวณของความเค้นอัดที่เกิดจากการเปลี่ยนเฟส และ (b) การเกิด martensitic
	transformation บนผิวหน้าวัสดุที่ได้รับการขัดซึ่งทำให้เกิดความเค้นอัดบริเวณผิว
	ด้านหน้า
รูปที่ 2.18	การเปลี่ยนเฟสของเซอร์โคเนียซึ่งก่อให้เกิดรอยแตกระดับจุลภาครอบอนุภาค
	เซอร์โคเนีย (a) รอยแตกเคลื่อนเข้าไปยังอนุภาคและ (b) รอยแตกแยกออกเป็น
	2 ส่วน ซึ่งช่วยเพิ่มความเหนียว
รูปที่ 3.1	แผนผังงานวิจัย

รูปที่ 3.2	แผนผังงานวิจัย (ต่อ)	30
รูปที่ 3.3	เตาเผาควบคุมบรรยากาศ (High-Multi 5000, FV PHP-R-5, FRET-25)	31
รูปที่ 3.4	ตารางการเผาผนึกสารตัวอย่าง	31
รูปที่ 3.5	(a) Vickers hardness tester และ (b) การวัดขนาดของรอยกดและความยาว	
	ของรอยแตกด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง	35
รูปที่ 3.6	ภาคตัดขวางภายในตัวเรือน	35
รูปที่ 4.1	(a) การกระจายขนาดอนุภาคของผงวัตถุดิบ (b) การกระจายขนาดสะสมของ	
	อนุภาค	39
รูปที่ 4.2	ลักษณะทางสัณฐา <mark>นวิทยาของผงวัตถุดิบจากก</mark> ล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ	
	ส่องกราด (a) อะล <mark>ูมินา (b) ทั</mark> ้งสเ <mark>ต</mark> นคา <mark>ร์ไบด์ (c) M</mark> g-PSZ และ (d) Ca-PSZ	40
รูปที่ 4.3	องค์ประกอบทา <mark>งเฟสของผงวัต</mark> ถุดิบ (a) อะลูมินา (b) ทังสเตนคาร์ไบด์	
	(c) Mg-PSZ และ (d) Ca-PSZ	41
รูปที่ 4.4	ความหนาแน่ <mark>นสัมพัทธ์หลังเผา ณ อุณหภูมิต่างๆของ</mark> อะลูมินา วัสดุเชิงประกอบ	
	อะลูมินาทังส <mark>เตนคาร์ไบด์และวัสดุเชิ</mark> งป <mark>ระกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี</mark>	
	Ca-PSZ เป็นส <mark>ารเติมแต่งร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก</mark>	43
รูปที่ 4.5	องค์ประกอบทาง <mark>เฟสข</mark> องอะ <mark>ลูมินา ณ อุณหภูมิเผาผ</mark> นึก 1400 1500 และ 1600	
	องศาเซลเซียส	44
รูปที่ 4.6	องค์ประกอบทางเฟสขอ <mark>งวัสดุเชิงประกอบอ</mark> ะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์	
	ณ อุณหภูมิเผาผนึก 1400 1500 และ 1600 องศาเซลเซียส	45
รูปที่ 4.7	เฟสไดอะแกรมของ W – C ในช่วงอุณหภูมิ 700 – 4700 องศาเซลเซียส	46
รูปที่ 4.8	องค์ประกอบทางเฟสของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ	
	เป็นสารเติมแต่งร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก ณ อุณหภูมิเผาผนึก 1400 1500 และ 1600	
	องศาเซลเซียส	48
รูปที่ 4.9	โครงสร้างจุลภาคของอะลูมินา ณ อุณหภูมิเผาผนึก (a) 1400 (b) 1500 และ	
	(c) 1600 องศาเซลเซียส	54
รูปที่ 4.10	โครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีของธาตุด้วยเทคนิค EDS ของ	
	วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ ณ อุณหภูมิเผาผนึก (a) 1400	
	(b) 1500 (c) 1600 องศาเซลเซียส (d) จุดที่หาองค์ประกอบทางเคมี	
	ณ อุณหภูมิเผาผนึก 1600 องศาเซลเซียส (e) บริเวณเนื้อพื้นสีเทาและ	
	(f) บริเวณอนุภาคสีขาว	55

IJ

รูปที่ 4.11	โครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีของธาตุด้วยเทคนิค EDS ของ	
	วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งร้อยละ 6	
	โดยน้ำหนัก ณ อุณหภูมิเผาผนึก (a) 1400 (b) 1500 (c) 1600 องศาเซลเซียส	
	(d) จุดที่หาองค์ประกอบทางเคมี ณ อุณหภูมิเผาผนึก 1600 องศาเซลเซียส	
	(e) บริเวณเนื้อพื้นสีเทา (f) บริเวณอนุภาคสีขาวขนาดใหญ่และ (g) บริเวณ	
	อนุภาคสีขาวขนาดเล็ก	. 56
รูปที่ 4.12	รอยกดวิกเกอร์บนผิวของชิ้นงาน ณ อุณหภูมิเผาผนึกต่างๆ (a, d, g) อะลูมินา	
	(b, e, h) วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ และ (c, f, i)	
	วัสดุเชิงประกอบอ <mark>ะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่มี</mark> Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่ง	
	ร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	. 57
รูปที่ 4.13	ความแข็ง ณ อ <mark>ุณหภูมิต่างๆของอะลูมินา วัสดุ</mark> เชิงประกอบอะลูมินา/	
	ทังสเตนคาร์ไ <mark>บด์และวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเต</mark> นคาร์ไบด์ที่มี	
	Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	. 59
รูปที่ 4.14	ความเหนียว <mark>ณ อุณหภูมิต่างๆของอะลูมินา วัสดุ</mark> เชิงประกอบอะลูมินา/	
	ทังสเตนคาร์ไบ <mark>ด์และวัสดุ</mark> เชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี	
	Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	. 60
รูปที่ 4.15	ลักษณะของรอยแต <mark>กจากหัวกดวิกเกอร์บน</mark> ผิวของชิ้นงาน (a) อะลูมินา	
	(b) วัสดุเชิงประกอบอะลู <mark>มินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์</mark> และ (c) วัสดุเชิงประกอบ	
	อะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	
	ณ อุณหภูมิ เผาผนึก 1600 องศาเซลเซียส	. 61
รูปที่ 4.16	ความต้านทา <mark>นต่</mark> อการดัดโค้ง ณ อุณหภูมิต่างๆของอะลูมินา วัสดุเชิงประกอบ	
	อะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์และวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี	
	Ca - PSZ เป็นสารเติมแต่งร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	. 63
รูปที่ 4.17	ลักษณะรอยแตกของ (a) อะลูมินา (b) วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์	
	และ (c) วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่ง	
	้ร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก ณ อุณหภูมิเผาผนึก 1600 องศาเซลเซียส	. 64
รูปที่ 4.18	ปริมาณ Mg-PSZ และ Ca-PSZ ต่อความหนาแน่นสัมพัทธ์ก่อนเผาของ	
	วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์	. 65
รูปที่ 4.19	ปริมาณ Mg-PSZและ Ca-PSZ ต่อความหนาแน่นสัมพัทธ์หลังเผาของ	
	วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่เผา ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส	. 66

รูปที่ 4.20	ปริมาณ Mg-PSZ ต่อองค์ประกอบทางเฟสของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/	
	ทั้งสเตนคาร์ไบด์ (a) ไม่มีสารเติมแต่ง (b) 1.5 wt% (c) 3.0 wt% (d) 4.5 wt%	
	ແລະ (e) 6.0 wt%	68
รูปที่ 4.21	ปริมาณ Ca-PSZ ต่อองค์ประกอบทางเฟสของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/	
	ทั้งสเตนคาร์ไบด์ (a) ไม่มีสารเติมแต่ง (b) 1.5 wt% (c) 3.0 wt% (d) 4.5 wt% และ	
	(e) 6.0 wt%	69
รูปที่ 4.22	โครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีของธาตุด้วยเทคนิค EDS ของ	
	วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่มี Mg-PSZ เป็นสารเติมแต่ง	
	ณ อุณหภูมิเผาผน <mark>ึก 1600 องศาเซลเซียส (a)</mark> 1.5 wt% (b) 3.0 wt% (c) 4.5 wt%	
	(d) 6.0 wt% (e) <mark>จุดที่หาองค์</mark> ประกอบทางเคมี (f) บริเวณเนื้อพื้นสีเทา	
	(g) บริเวณ อนุ <mark>ภาคสีขาวขนาดใหญ่และ (h) บริเวณอ</mark> นุภาคสีขาวขนาดเล็ก	71
รูปที่ 4.23	โครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ	
	เป็นสารเติมแต่ง ณ อุณหภูมิเผาผนึก 1600 องศาเซลเซียส (a) 1.5 wt%	
	(b) 3.0 wt% (c) 4.5 wt% ແລະ (d) 6.0 wt%	73
รูปที่ 4.24	ปริมาณ Mg-P <mark>S</mark> Z และ Ca-PSZ ต่อขนาดเกรนเนื้อพื้นอะลูมินาของ	
	วัสดุเชิงประกอบ <mark>อ</mark> ะลู <mark>มินา/ทังสเตนคาร์ไบ</mark> ด์	73
รูปที่ 4.25	ปริมาณ Mg-PSZ แ <mark>ละ Ca-PSZ ต่อความแ</mark> ข็งของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/	
	ทั้งสเตนคาร์ไบด์	74
รูปที่ 4.26	ปริมาณ Mg-PSZ และ Ca-PSZ ความเหนี่ยวของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/	
	ทั้งสเตนคาร์ไบด์	75
รูปที่ 4.27	ปริมาณ Mg-PSZ และ Ca-PSZ ต่อความต้านทานต่อการดัดโค้งของ	
	วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์	76

- พู่ แอ มีท่อที่วี่พยากว่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

Ē	= ความยาวของรอยแตกเฉลี่ย (เมตร)
$ar{d}$	= ความยาวเส้นทแยงมุมของรอยกดเฉลี่ย (มิลลิเมตร)
H_V	- ค่าความแข็ง (กิกะพาสคัล)
K _C	= ค่าความเหนียว (เมกะพาสคัล.เมตร ^{1/2})
L	= ความกว้างของจุดรองรับตัวอย่าง (มิลลิเมตร)
m	= น้ำหนักของตัวอย่ <mark>างก่อนเผา (กรัม</mark>)
Р	= แรงที่ใช้กด (นิวตัน)
P_f	= ขนาดขอ <mark>งแรงกดที่ทำให้ตัว</mark> อย่า <mark>งแตกหัก (นิ</mark> วตัน)
$\rho_{\rm a}, \rho_{\rm b}, \dots$	= ความห <mark>นาแน่นจริงของสารตั้งต้น a, b, ตาม</mark> ลำดับ
	(กรัมต <mark>่อลูกบาศก์เซนติเมต</mark> ร)
$ ho_{ m bulk}$	= ความ <mark>หนาแน่นรวม (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเม</mark> ตร)
$ ho_{ m green}$	= ความ <mark>หนาแน่นก่อนเผา (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติ</mark> เมตร)
$ ho_{ m th}$	= ความห <mark>นาแน่นเชิงทฤษฎี (กรั</mark> มต่อลู <mark>กบาศก์</mark> เซนติเมตร)
$ ho_{ m water}$	= ความหน <mark>าแน่นของน้ำ (กรัมต่อลูกบาศก์</mark> เซนติเมตร)
t	= ความหนาข <mark>องตัวอย่าง (มิลลิเมตร)</mark>
V	= ปริมาตรของตัวอย่างก่อนเผา (ลูกบาศก์เซนติเมตร)
W	= ความกว้างของตัวอย่าง (มิลลิเมตร)
$W_{a}, W_{b},$	= น้ำหนักของสารตั้งต้น a, b, ตามลำดับ (กรัม)
W _{dry}	= น้ำหนักแห้งของตัวอย่าง (กรัม)
W _{sat}	= น้ำหนักเปียกของตัวอย่าง (กรัม)
W _{sus}	= น้ำหนักของตัวอย่างในน้ำ (กรัม)
W _{total}	= น้ำหนักของสารตั้งต้นทั้งหมด (กรัม)
σ_{f}	= ความต้านทานต่อการดัดโค้ง (เมกะพาสคัล)

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อาทิ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีการใช้แม่พิมพ์และชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งมักทำจากโลหะ อุตสาหกรรมโลหะ จึงเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ และในอุตสาหกรรมนี้มีขั้นตอน การตัด กลึงและไสส่วนเกินของโลหะที่ได้จากการขึ้นรูปโลหะเบื้องต้นให้ได้รูปร่างตามต้องการซึ่ง ต้องอาศัยเครื่องมือตัดที่มีความแม่นยำ รักษาความคมและความแข็งไว้ได้ ความแข็งแรงสูง ทนต่อ การเกิดออกซิเดชัน มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงความร้อนต่ำและมีการนำความร้อนที่ดีเพื่อ ปรับปรุงการผลิต⁽¹⁾

เซรามิกเป็นวัสดุตัดชนิดหนึ่งที่มีสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกลที่ดีไม่ว่าจะเป็นความแข็ง ความแข็งแรง ความทนต่อการสึกกร่อน ความทนต่อความร้อนที่เกิดจากกระบวนการตัดและเฉื่อย ต่อปฏิกิริยาทางเคมี สามารถนำมาใช้ในงานตัดโลหะหรือชิ้นงานที่มีความแข็งสูงและมีรูปร่าง ซับซ้อนได้ สามารถเพิ่มอัตราการตัด ยืดอายุในการใช้งานพร้อมทั้งลดต้นทุนการผลิต เครื่องมือตัด ที่ผลิตจากวัสดุเซรามิกจึงได้รับความนิยมแต่ความเปราะของเซรามิกทำให้ความน่าเชื่อถือใน การนำมาใช้งานค่อนข้างต่ำ การปรับปรุงสมบัติของวัสดุตัดเซรามิกเพื่อทำให้วัสดุตัดเซรามิก สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง⁽¹⁻³⁾

วัสดุตัดเซรามิกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ ซีเมนเตตคาร์ไบด์ เช่น ทังสเตนคาร์ไบด์ -โคบอลต์ ซึ่งมีข้อดีคือความแข็ง ความแข็งแรงและความเหนียวสูง แต่การมีโลหะโคบอลต์ทำหน้าที่ เป็นตัวเชื่อมประสานอนุภาคทังสเตนคาร์ไบด์อยู่นั้นก่อให้เกิดการเสียรูปอย่างถาวรที่อุณหภูมิสูง และทำให้ความแข็งแรงลดลง⁽⁴⁾ อะลูมินาเป็นวัสดุเซรามิกอีกชนิดหนึ่งที่ทนทานต่อการสึกกร่อน และมีความแข็งขณะร้อนสูง อีกทั้งมีความเสถียรทางเคมีมากกว่าเหล็กกล้าความเร็วรอบสูงและ คาร์ไบด์ จึงนิยมนำอะลูมินามาใช้งานด้านวิศวกรรมเซรามิกอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม อะลูมินาก็ยังค่อนข้างเปราะทำให้การนำอะลูมินาไปประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องการสมบัติความทน ต่อแรงกระแทก เช่น เครื่องตัดความเร็วรอบสูงนั้นเป็นไปได้ยาก การนำอะลูมินามาทำเป็น วัสดุเชิงประกอบสามารถเพิ่มความต้านทานต่อการดัดโค้งและความเหนียวได้โดยอาศัยกลไก การเบี่ยงเบนของรอยแตกพร้อมทั้งยับยั้งการโตของเกรนของอะลูมินา โดยทั่วไปวัสดุตัดเซรามิก สามารถทำให้ความเหนียวเพิ่มขึ้นโดยการกระจายของอนุภาค เส้นใยหรือวิสเกอร์ในเนื้อพื้น รวมทั้งอาศัยการเพิ่มความเหนียวด้วยการเปลี่ยนเฟส อนุภาคที่นิยมนำมาเสริมแรงในอะลูมินามัก เป็นสารประกอบคาร์ไบด์และไนไตรด์ สารประกอบคาร์ไบด์ที่มีความน่าสนใจคือทังสเตนคาร์ไบด์ เนื่องจากมีความแข็งสูง เฉื่อยต่อปฏิกิริยาทางเคมี ทนต่อการกัดกร่อน มีมอดูลัสของความยืดหยุ่น สูงและมีค่าความเหนียวสูง⁽⁵⁻⁸⁾ การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ในปัจจุบันมี หลายวิธีและการเผาผนึกแบบปราศจากแรงดันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่สูงมาก สามารถผลิตชิ้นงานได้จำนวนมากอีกทั้งมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนเหมือนวิธีอื่นๆ แต่ก็มี ข้อจำกัดคือสมบัติทางกลโดยเฉพาะความเหนียวของวัสดุเชิงประกอบชนิดนี้อาจยังด้อยกว่า การขึ้นรปด้วยวิธีอื่น

เซอร์โคเนียเป็นวัสดุเ<mark>ซรามิกอีกซ</mark>นิดหนึ่งที่มี<mark>สมบัติเด่น</mark>หลากหลายโดยเฉพาะความเหนียว ที่มีค่าสูง เซอร์โคเนียมีรูปผลึกอยู่ 3 รูปด้วยกัน โดยมีรูปผลึกเป็นมอโนคลินิก (m-ZrO₂) ที่ อุณหภูมิห้องและจะเปลี่ยนไปเป็นเททระโกนัล (t-ZrO₂) และลูกบาศก์ (c-ZrO₂) ที่อุณหภูมิสูงขึ้น การเปลี่ยนรูปผลึกนี้ทำให้เกิดขยายตัวเชิงปริมาตรประมาณร้อยละ 3-5 ซึ่งก่อให้เกิดความเครียด ้สูง ในการใช้งานโดยทั่วไปได้มีการเติมสารประกอบออกไซด์ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) อิตเทรียมออกไซด์ (Y₂O₃) <mark>แคลเซียมออกไซด์ (CaO) และซีเรีย</mark>มออกไซด์ (CeO₂)⁽⁹⁾ ในปริมาณที่ เหมาะสม การใช้งานในบา<mark>งกรณีต้องการให้เททระโกนัล</mark>เปลี่ยนเป็นมอโนคลินิกซึ่งอยู่ในสภาวะ ้กึ่งเสถียร เนื่องจากเมื่อมีแรงภ<mark>ายนอกมากระทำกับวัส</mark>ดุจะทำให้เกิดความเครียดที่ปลายรอยแตก ทำให้เททระโกนัลเปลี่ยนเฟสเป็<mark>นมอโนคลินิก ก่อให้</mark>เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรและ ้เกิดแรงอัดที่รอยแตกช่วยทำให้หยุดการโตของรอยแตกและเพิ่มความเหนียวในวัสดุซึ่งกลไกนี้ เรียกว่า การเพิ่มความเหนียวด้วยการเปลี่ยนเฟส (transformation toughening) การเติม สารประกอบออกไซด์ต่างชนิดกันและใช้ปริมาณต่างกันทำให้ได้เซอร์โคเนียที่มีลักษณะโครงสร้าง ้จุลภาคต่างกัน โดยทั่วไปการเติมแมกนีเซียมออกไซด์และแคลเซียมออกไซด์เป็นสารสร้าง ความเสถียรในเซอร์โคเนีย (Mg-PSZ และ Ca-PSZ) จะทำให้ได้โครงสร้างของเซอร์โคเนียบางส่วน เสถียรในรูปผลึกแบบเททระโกนัลแล้วกระจายตัวอยู่ในรูปผลึกลูกบาศก์ซึ่งเรียกว่า Partially Stabilized Zirconia (PSZ) โดยผลึกของเททระโกนัลนี้สามารถเปลี่ยนรูปผลึกเป็นมอโนคลินิกได้ เมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ ดังนั้นการเติม Mg-PSZ และ Ca-PSZ เข้าไปในวัสดุเชิงประกอบ อะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์อาจมีส่วนช่วยให้วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์มีสมบัติ ทางกลดีขึ้น

งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Mg-PSZ และ Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งในปริมาณต่างกัน เพื่อปรับปรุง สมบัติทางกลให้เหมาะแก่การนำไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัด

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาผลของปริมาณสารเติมแต่ง Mg-PSZ และ Ca-PSZ ต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์

1.2.2 เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิในการเผาผนึกของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ อะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

 1.3.1 เตรียมและศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Mg-PSZ และ Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งตั้งแต่ร้อยละ 1.5 3.0 4.5 และ 6.0 โดยน้ำหนัก

1.3.2 ศึกษาผลของอุณหภูมิการเผาผนึกในช่วง 1400 องศาเซลเซียส ถึง 1600
 องศาเซลเซียส ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ ที่มี
 Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งในปริมาณร้อยละ 6.0 โดยน้ำหนัก

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้วัสดุเชิงประกอบอะลูม<mark>ินาและทังสเตนคา</mark>ร์ไบด์ที่มีสมบัติทางกลดีและเหมาะสำหรับ การนำไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัด

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้ได้กล่าวถึงหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกกล่าวถึงสมบัติและประเภทของ วัสดุตัด หัวข้อที่สองกล่าวถึงวัสดุเชิงประกอบซึ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้น เซรามิก หัวข้อที่สามครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ซึ่ง กล่าวถึงสมบัติและกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบชนิดนี้ และหัวข้อสุดท้ายคือลักษณะและ กลไกการเพิ่มความเหนียวด้วยเซอร์โคเนีย

2.1 วัสดุตัด

2.1.1 ประเภทและสมบัติของวัสดุตัด^(1, 10)

วัสดุตัด (cutting tool materials) เป็นวัสดุที่ใช้เจาะหรือตัดแต่งชิ้นงาน วัสดุตัดที่ดีควรมี สมบัติที่เหมาะสมกับสภาวะการใช้กล่าวคือ

1. มีความแข็งสูงเมื่อทำงานที่อุณหภูมิสูง (hot hardness) เพื่อป้องกันการเสื่อมหรือสึก กร่อนของวัสดุ

 2. มีความต้านทานต่อการเสียรูป (deformation resistance) สูงเพื่อป้องกันการเกิด การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร (plastic deformation) ที่ขอบของวัสดุตัดภายใต้ความเครียดสูงและ อุณหภูมิสูงที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน

3. มีความเหนียว (fracture toughness) สูง เพื่อป้องกันความเสียหายจากชิ้นส่วนขนาด เล็กที่เกิดจากการตัดซึ่งอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักขณะทำงาน

4. เฉื่อยต่อปฏิกิริยาเคมี (chemical inertness) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวัสดุที่ใช้งานเพื่อ ป้องกันการทำปฏิกิริยากับชิ้นงานที่ตัดและสารช่วยหล่อเย็นขณะตัด

5. มีสภาพการนำความร้อน (thermal conductivity) ที่ดี เพื่อลดอุณหภูมิใกล้ๆกับขอบ ของวัสดุตัด (cutting edge) ลดโอกาสการบิดเบี้ยวเสียรูปของวัสดุตัดจากความร้อน

6. มีความทนทานต่อความล้า (fatigue resistance) ซึ่งจำเป็นสำหรับวัสดุที่อยู่ภายใต้ แรงกระทำแบบสลับไปมาเป็นเวลานาน

7. มีความทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน (thermal shock resistance) สูงซึ่งมีผลกับสมบัติทางกลของวัสดุตัด

8. มีความแข็งตึง (stiffness) สูงเพื่อรักษาความแม่นยำในการตัด

9. มีความลื่น (lubricity) เพียงพอหรือมีความเสียดทานต่ำเพื่อลดความเสียดทานและ ป้องกันการสึกของวัสดุตัด

โดยรวมแล้วหากแบ่งสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นออกเป็นกลุ่มใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ สมบัติทางกล (mechanical property) สมบัติทางกายภาพ (physical property) และ สมบัติทางเคมี (chemical property) สมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้เป็นสมบัติในอุดมคติของ วัสดุ กล่าวคือยังไม่มีวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียวที่มีสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นครบทุก ประการ

สำหรับสมบัติทางด้านการทนต่อการสึกหรอ (wear resistance) และความแข็งขณะร้อน นั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้วัสดุตัดมีความเร็วรอบในการตัดสูงขึ้นซึ่งมีผลต่อ ความสามารถในการผลิตชิ้นงาน จากรูปที่ 2.1 แสดงถึงการพัฒนาของชนิดของวัสดุตัดและ ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของวัสดุกับความเร็วรอบในการตัด จะเห็นว่าวัสดุตัดมีอายุการใช้งาน ยาวนานขึ้นหรือมีความเร็วรอบในการตัดสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่เกิดขึ้น ระหว่างการตัด กล่าวคือวัสดุใดที่มีความแข็งขณะร้อนสูงนั้นย่อมสามารถทนความร้อน คงรูปทรง และความคมหรือความแข็งไว้ได้ ส่งผลให้อัตราเร็วในการตัดสูงทำให้อัตราการผลิตชิ้นงานสูงขึ้น



รูปที่ 2.1 การพัฒนาความเร็วรอบในการตัดสำหรับวัสดุตัดแต่ละชนิดในช่วงเวลาต่างๆ⁽¹⁾

วัสดุตัดสามารถแบ่งออกได้หลายกลุ่ม⁽¹⁰⁾ อาทิ เหล็กกล้าความเร็วรอบสูง (high speed steels : HSS) และเหล็กกล้าความเร็วรอบสูงที่มีโคบอลต์เป็นธาตุผสมหลัก (cobalt enriched high speed steels : HSS-Co) ทั้งสเตนคาร์ไบด์ (sintered tungsten carbides, WC) เซอร์เมท (cermets) เซรามิก (อาทิ อะลูมินาและซิลิคอนไนไตรด์) super/ultra-hard materials เช่น คิวบิก โบรอนในไตรด์ (polycrystalline cubic boron nitride, PCBN) และเพชร (polycrystalline diamond, PCD) เมื่อสังเกตแผนภูมิวงกลมแสดงชนิดและปริมาณของวัสดุตัดที่ใช้กันทั่วโลกในปี

ค.ศ. 2005 ดังรูปที่ 2.2 พบว่า CVD และ PVD coated carbide tools เป็นวัสดุที่นิยมใช้กันมาก ที่สุดโดยรวมแล้วมากถึงร้อยละ 53 ส่วนสมบัติทางกลและการประยุกต์ใช้วัสดุเครื่องมือชนิดต่างๆ แสดงดังตารางที่ 2.1



รูปที่ 2.2 วัสดุตัดหลักๆ ที่ใช้กันทั่วโลกในปี ค.ศ. 2005⁽¹⁰⁾

Material	Strengths	Weaknesses	Typical Applications
HSS	Superior Shock Resistance Versatility	Poor Speed Capabilities Poor Wear Resistance	Screw Machine and Other Low-Speed Operations Interrupted Cuts, Low- Horsepower Machining
Carbide	Most Versatile Cutting Material; High Shock Resistance	Limited Speed Capabilities	Finishing to Heavy Rough- ing of Most Materials, In- cluding Irons, Steels, Ex- otics, and Plastics
Coated Carbide	High Versatility; Good Performance at Moderate Speeds	Limited to Moderate Speeds	Same as Carbide, Except with Higher Speed Capa- bilities
Cermet	High Versatility; Good Per- formance at Moderate Speeds	Low Shock Resistance: Limited to Moderate Speeds	Finishing Operations on Irons, Steels, Stainless Steels, and Aluminum Alloys
Ceramic Hot/Cold Pressed	High Abrasion Resistance; High Speed Capabilities; Versatility	Low Mechanical Shock Resistance: Low Thermal Shock Resistance	Steel Mill-Roll Resurfacing, Finishing Operations on Cast Irons and Steels
Ceramic Silicon Nitride	High Shock Resistance; High Thermal Shock Resistance	Very Limited Applications	Roughing and Finishing Operations on Cast Irons
Ceramic Whisker Reinforced	High Shock Resistance: High Thermal Shock Resistance	Limited Versatility	High-Speed Roughing and Finishing of Hardened Steels. Chilled Cast Iron. High-Nickel Superalloys
Cubic Boron Nitride	High Hot Hardness; High Strength; High Thermal Shock Resistance	Limited Performance on Materials Following: 38 RC; Limited Applica- tions; High Cost	Hardened Work Materials in 45–70 Rockwell C Range
Polycrystalline Diamond	High Abrasion Resistance; High Speed Capabilities	Limited Applications; Low Mechanical Shock Resis- tance	Roughing and Finishing Operations on Abrasive Non-Ferrous or Non- Metallic Materials

ตารางที่ 2.1 สมบัติและการใช้งานวัสดุตัดชนิดต่างๆ⁽¹¹⁾

หลักการสำคัญในการพิจารณาเลือกวัสดุตัดที่เหมาะสมคือสมบัติทางกล เช่น ความแข็ง และความเหนียวที่อุณหภูมิสูง ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งวิกเกอร์และความต้านทานแรงดึง (tensile rupture strength, TRS) ที่อุณหภูมิห้องสำหรับวัสดุตัดบางชนิดแสดงดังรูปที่ 2.3 ประกอบด้วยเส้นเฉียงซึ่งมีความแข็งเป็น 3 เท่าของความต้านทานแรงดึง วัสดุที่มีช่วงอยู่ด้านบน ของเส้นเฉียงนี้จะมีการเคลื่อนตัวแบบเหนียว (ductile flow) ก่อนแตกหักซึ่งแสดงเห็นว่าเหล็กกล้า ความเร็วรอบสูงและคาร์ไบด์ที่มีความละเอียดสูงมีบางส่วนที่มีพฤติกรรมของความเหนียวก่อนเกิด การแตกหัก ส่วนบริเวณด้านล่างของเส้นเฉียงจะเกิดการแตกแบบยืดหยุ่น (elastic fracture) วัสดุ ที่อยู่บริเวณนี้จะไม่มีพฤติกรรมของความเหนียวก่อนการแตกหัก สำหรับด้านขวามือเป็น การเปรียบเทียบช่วงของความเหนียว (K_{ic}) และความต้านทานแรงดึงของวัสดุชนิดต่างๆ พบว่า เหล็กกล้าความเร็วรอบสูง คาร์ไบด์และเซอร์เมทมีความเหนียวสูงกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ



รูปที่ 2.3 ช่วงของค<mark>วา</mark>มต้านทานแรงดึงและความแข็งวิกเก<mark>อ</mark>ร์ของวัสดุตัดทางการค้า⁽¹⁰⁾

ความแข็งขณะร้อนคือความแข็งที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ วัสดุที่มีความแข็งขณะร้อนสูง สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าวัสดุที่มีความแข็งขณะร้อนต่ำเนื่องจากมีอัตราเร็วในการตัดสูงกว่า ในรูปที่ 2.4 จะเห็นว่าความแข็งของวัสดุทุกชนิดมีลักษณะเช่นเดียวกันคือความแข็งของวัสดุมี แนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อีกทั้งยังพบว่าเซรามิกมีความแข็งขณะร้อนสูงกว่าเมื่อเทียบกับ วัสดุตัดชนิดอื่นๆ



รูปที่ 2.4 ความแข็งขณะร้อนของวัสดุตัดชนิดต่างๆ⁽¹⁾

ส่วนความเสถียรทางความร้อนหรือสมบัติของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิและ ส่งผลให้เกิดความไม่เสถียรขององค์ประกอบทางเคมีหรือโครงสร้างจุลภาค การเสื่อมสภาพและ สมบัติเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ณ อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤติ โดยทั่วไปเป็นการเกิดออกซิเดชันทำ ให้ความแข็งและความต้านทานต่อการแตกหักต่ำกว่าปกติ เกิดการเปลี่ยนเฟสและโครงสร้าง จุลภาครวมทั้งสมบัติทางกลและมอดูลัสความยืดหยุ่นตามอุณหภูมิดังแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ช่วงของอุณหภูมิที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างของ วัสดุเครื่องมือ⁽¹⁰⁾

Tool motorial	Temperature range (°C) for		
roormaterial	Oxidation	Structural change (nature)	
High speed steel	-	> 600 (over tempering)	
WC-Co carbide	> 500	> 900-950 (solution of WC in Co binder)	
Mixed carbides/cermets	> 700	-	
Ceramics	-	> 1350-1500 (intergranular liquids)	
PCBN	-	>1100-1350 (transform to hexagonal form)	
PCD	> 900	> 700 (change to graphite)	

เนื่องจากเซรามิกมีจุดหลอมเหลวสูง มีความแข็งสูง ทนต่อการสึกกร่อน เลื่อยต่อ ปฏิกิริยา และมีความแข็งขณะร้อนสูง จึงอาจกล่าวได้ว่ามีสมบัติทางกลและสมบัติทางเคมีที่ดีมาก และมีแนวโน้มในการนำข้อดีของเซรามิกไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือตัด โดยหลักสำคัญในการนำ วัสดุตัดเซรามิกมาใช้งานนั่นก็คือสามารถทนความร้อนได้ดีกว่าวัสดุตัดชนิดอื่นๆ และแม้ว่า CVD และ PVD coated carbide tools มีการใช้งานมากกว่าวัสดุตัดชนิดอื่นๆ ดังในรูปที่ 2.2 แต่สมบัติ ทางกลโดยรวมก็ยังด้อยกว่าวัสดุตัดเซรามิก⁽¹⁰⁾

2.1.2 วัสดุตัดเซรามิก^(1, 10)

วัสดุตัดเซรามิกมักถูกนำไปประยุกต์ใช้ในด้านงานกลึง (turning) และเครื่องเซาะ (milling) โลหะและโลหะผสม รวมถึงตกแต่งวัสดุที่มีความแข็งต่างๆ เซรามิกถูกนำมาใช้เป็นวัสดุตัด เนื่องจากสามารถตัดด้วยความเร็วรอบในการตัดเพิ่มขึ้นจึงสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากดังจะเห็นได้ จากรูปที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่ง สามารถประเมินจากอัตราเร็วในการตัดของวัสดุตัด การที่ความเร็วรอบในการตัดเพิ่มขึ้นส่งผลให้ เกิดความร้อนระหว่างการตัดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นสมบัติทางกลของวัสดุตัดที่อุณหภูมิสูงจึงมี ความสำคัญอย่างยิ่ง วัสดุตัดเซรามิกจึงมีช้อได้เปรียบกว่าวัสดุตัดชนิดอื่นๆ ทั้งในด้านความทนต่อ สารเคมีและสมบัติทางกล⁽¹²⁾ วัสดุเซรามิกจึงมีช้อได้เปรียบกว่าวัสดุตัดชนิดอื่นๆ ทั้งในด้านความทนต่อ

สำหรับวัสดุตัดเซรามิกมักอยู่ในรูปของวัสดุเชิงประกอบเซรามิกซึ่งประกอบด้วยเซรามิก ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มักแบ่งตามประเภทตามชนิดของเนื้อพื้น (matrix) แบ่งเป็นเนื้อพื้นอะลูมินา

และเนื้อพื้นซิลิคอนไนไตรด์ และมีตัวเสริมแรงเป็นอนุภาคหรือวิสเกอร์ของเซรามิกซนิดต่างๆ อะลูมิเนียมออกไซด์หรือเป็นที่รู้จักกันดีในทางเซรามิกคืออะลูมินา มีอะตอมที่ยึดเหนี่ยว กันด้วยพันธะไอออนิกและมีความแข็งสูงจัดเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่เหมาะกับการนำมาทำเป็นวัสดุตัด อะลูมินามีหลายรูปผลึกซึ่งจะกลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งเป็นเฟสที่เสถียรที่สุดที่อุณหภูมิสูง คือ เอกซะโกนัลในเฟสแอลฟา (α-Al₂O₃) วัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นอะลูมินา (C1 ในรูปที่ 2.5) ประกอบไปด้วยการเติมเซอร์โคเนีย ไททาเนียมคาร์ไบด์ ไททาเนียมไนไตรด์ หรือชิลิคอนคาร์ไบด์ วิสเกอร์และสามารถทำให้สมบัติทางกลของเนื้อพื้นเปลี่ยนไป วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ เซอร์โคเนีย (เซรามิกสีขาว) ประกอบด้วยเซอร์โคเนียถึงร้อยละ 10 เพื่อเพิ่มความเหนียวให้แก่วัสดุ ซึ่งมีความจำเป็นในการนำไปใช้ตัดแต่งเหล็กกล้า (steel) ส่วนอะลูมินาที่ประกอบด้วย ไททาเนียมคาร์ไบด์หรือไนไตรด์ Ti (C, N) มากถึงร้อยละ 40 (C2 ในรูปที่ 2.5) ทำให้วัสดุชนิดนี้มี ความทนต่อการขัดสีอย่างดีเยี่ยมและมักใช้ในการกลึงไสตัดเจาะเหล็กหล่อชุบผิวแข็งและ เหล็กกล้าชุบผิวแข็ง อะลูมินาที่ถูกเสริมแรงด้วยชิลิคอนคาร์ไบด์วิสเกอร์นั้นมีความเหนียวมากที่สุด และมีความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันได้มากในบรรดาวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้น อะลูมินา ซิลิคอนคาร์ไบด์วิสเกอร์ที่ถูกใช้เสริมแรงประกอบด้วยรูปร่างเป็นท่อยาว (rod-shaped fibers) หรือรูปร่างเข็มยาว (needle-shaped fibers) ในช่วงของเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1-1 ไมครอน และมีความยาว 5-100 ไมครอน (ซึ่งมีความยาวมากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 100 เท่า) การนำ ซิลิคอนคาร์ไบด์เข้ามาเสริมแรงในเนื้อพื้นเซรามิกส่งผลให้ความแข็งแรง ความเหนียว การนำ ความร้อน ความทนต่ออุณหภูมิอย่างเฉียบพลันและความทนต่อคืบที่อุณหภูมิสูงนั้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากวิสเกอร์มีความต้านทานแรงดึงมากถึง 7 กิกะพาสคัล และมีมอดูลัสความยืดหยุ่นมากถึง 550 กิกะพาสคัล⁽¹⁰⁾ ในปัจจุบันวัสดุตัดเนื้อพื้นอะลูมินาเป็นที่นิยมศึกษาเนื่องจากอะลูมินามีราคา ถูกและหาง่าย พร้อมทั้งมีความเส<mark>ถียรทางเคมีและมีสมบัติทางกลสูง</mark>



รูปที่ 2.5 วัสดุตัดเซรามิกชนิดต่างๆ : C1 – อะลูมินา (สีขาว), C2 – อะลูมินา/ไททาเนียมคาร์ไบด์ (สีดำ), C3 – ซิลิคอนไนไตรด์, CT – เซอร์เมท, CBN – คิวบิกโบรอนไนไตรด์⁽¹⁰⁾

วัสดุตัดที่มีซิลิคอนในไตรด์เป็นเนื้อพื้นประกอบด้วยซิลิคอนในไตรด์ความหนาแน่นสูงและ ใซอะลอน (silicon aluminum oxynitride, SiAION) ซึ่งเป็นสารละลายของแข็ง (solid solution) ของอะลูมินาในซิลิคอนในไตรด์ ซิลิคอนในไตรด์ความหนาแน่นสูงมีความเหนียวสูงกว่า ซีเมนเตตคาร์ไบด์ มีความแข็งแรงสูงและมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำส่งผลให้ ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันดีมาก เนื้อพื้นซิลิคอนในไตรด์สามารถรักษา ความแข็งขณะร้อนได้เป็นอย่างดี ทนต่ออุณหภูมิได้สูงกว่าซีเมนเตตคาร์ไบด์และมีความเหนียว มากกว่าเนื้อพื้นอะลูมินา เครื่องมือที่ทำด้วยวัสดุชนิดนี้ใช้ในด้านเจาะและกลึงเหล็กหล่อเทาที่ ความเร็วรอบในการตัดมากกว่า 400 เมตรต่อนาที ส่วนไซอะลอนเป็นวัสดุที่มีความเลื่อยต่อ ปฏิกิริยาทางเคมีมากกว่าซิลิคอนไนไตรด์ แต่ค่อนข้างเหนียวและทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่าง เฉียบพลันน้อยกว่าซิลิคอนไนไตรด์ อย่างไรก็ตามโครงสร้างผลึกของซิลิคอนไนไตรด์และไซอะลอน มีอะตอมยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโควาเลนต์และมีความแข็งแรงสูง ทำให้วัสดุทั้งสองชนิดมี สัมประสิทธิ์การแพร่ต่ำ (low self-diffusion coefficient) การเผาผนิกด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมเพื่อให้ ได้ชิ้นงานให้มีความหนาแน่นสูงจึงเป็นไปได้ยากและต้องใช้อุณหภูมิในการเผาผนึกสูง ทำให้มี การเติมสารที่ช่วยในการเผาผนึก (sintering aids) เช่น อะลูมินา แมกนีเซียมออกไซด์และ อิตเทรียมออกไซด์ ในซิลิคอนไนไตรด์และไซอะลอนเพื่อช่วยลดอุณหภูมิในการเผาผนึกให้ต่ำลง และได้ชิ้นงานมีความหนาแน่นสูง^(1, 13)

2.2 วัสดุเชิงประกอบ (Composite materials)⁽¹⁴⁻¹⁶⁾

วัสดุเชิงประกอบเป็นระบบของวัสดุที่ประกอบด้วยของผสมหรือเป็นการรวมกันของสารที่ องค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปทั้งในระดับจุลภาคหรือมหภาคก็ได้แต่จะต้อง ไม่ละลายเข้าด้วยกัน⁽¹⁴⁾ วัสดุเชิงประกอบประกอบขึ้นจากเฟส 2 ชนิดโดยเฟสแรก เรียกว่า เนื้อพื้น (matrix) ซึ่งอยู่ด้วยกันอย่างต่อเนื่องและล้อมรอบเฟสที่สองไว้ เฟสที่สองเรียกว่า เฟสที่กระจาย (dispersed phase) หรือตัวเสริมแรง (reinforcement) สมบัติของวัสดุเชิงประกอบที่ได้จะขึ้นอยู่ กับสมบัติและปริมาณของสารตั้งต้น สัณฐานและขนาดอนุภาคของเฟสที่กระจายตัว การกระจาย อนุภาคและการเรียงตัว⁽¹⁵⁾ สำหรับวัตถุประสงค์ของการสร้างวัสดุเชิงประกอบก็เพื่อให้ได้วัสดุที่มี สมบัติดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือให้มีลักษณะที่สำคัญบางอย่างแตกต่างไปจากสารเดิมโดยเฉพาะ อย่างยิ่งสมบัติทางกล

วัสดุต่างๆที่จัดอยู่ในพวกวัสดุเชิงประกอบนั้นมีมากมายขึ้นอยู่กับเนื้อพื้นและลักษณะของ การเสริมแรง หากแบ่งตามลักษณะของการเสริมแรงสามารถแบ่งกลุ่มได้หลักๆ 3 กลุ่ม คือ วัสดุเชิงประกอบเสริมแรงด้วยอนุ<mark>ภาค วัสดุเชิงประกอบเสริมแรง</mark>ด้วยเส้นใยและวัสดุเชิงประกอบ โครงสร้าง ในแต่ละกลุ่มเหล่านี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีกดังรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 การแบ่งประเภทของวัสดุเชิงประกอบตามลักษณะการเสริมแรง⁽¹⁵⁾

การแบ่งกลุ่มของวัสดุเชิงประกอบในปัจจุบันนี้ยังสามารถจำแนกได้ตามชนิดของเนื้อพื้น ได้แก่ วัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นพอลิเมอร์ (polymer matrix composites, PMCs) วัสดุเชิงประกอบ เนื้อพื้นโลหะ (metal matrix composites, MMCs) วัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นเซรามิก (ceramic matrix composites, CMCs) วัสดุเชิงประกอบคาร์บอน-คาร์บอน (ceramic-carbon composites, CCCs) และวัสดุเชิงประกอบแบบลูกผสม (hybrid composites) เป็นต้น⁽¹⁶⁾ งานวิจัยนี้จะขอเน้นศึกษาวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นเซรามิกเป็นหลัก

2.2.1 วัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นเซรามิก (Ceramic matrix composites, CMCs)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นวัสดุเซรามิกจัดเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดขันและการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิสูง วัสดุเซรามิกบางชนิดอาจจัดได้ว่าใกล้เคียงวัสดุใน อุดมคติที่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงและในระดับความเค้นที่รุนแรงหากวัสดุชนิดนั้นไม่มี การแตกหักแบบเปราะ ค่าความเหนียวของเซรามิกค่อนข้างต่ำในทางตรงกันข้ามโลหะส่วนใหญ่ จะมีค่าสูงกว่ามาก ความเหนียวในวัสดุเซรามิกสามารถปรับปรุงได้โดยผลิตเป็นวัสดุเชิงประกอบ เนื้อพื้นเซรามิก ซึ่งเป็นการนำเอาผงอนุภาค เส้นใยหรือวิสเกอร์ของเซรามิกซนิดหนึ่งไปฝังไว้ในเนื้อ วัสดุเซรามิกอีกชนิดหนึ่งทำให้มีการปรับปรุงสมบัติทางกล เช่น ความแข็งแรงและความเหนียวได้ ดีกว่าวัสดุเชิงประกอบที่ไม่มีการเสริมแรงโดยใช้เนื้อพื้นเซรามิก ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาระหว่าง รอยแตกที่จะขยายตัวกับอนุภาคของเฟสขนาดเล็กที่กระจายอยู่ จุดเริ่มต้นของการแตกปกติจะ เกิดขึ้นในเฟสเนื้อพื้นขณะที่รอยแตกขยายตัวหรือโตขึ้น รอยแตกจะถูกขัดขวางโดยอนุภาค เส้นใย หรือวิสเกอร์ได้หลายกลไก อาทิเช่น การเชื่อมต่อกันของรอยแตก การเบียงเบนของรอยแตก การบีบอัดของเนื้อพื้นเนื่องจากความเค้นและการเพิ่มความเหนียวด้วยการเปลี่ยนเฟส⁽¹⁶⁾ ดังรูปที่ 2.7

กลไกการเพิ่มความเหนียวที่สำคัญในวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นเซรามิก คือ การเบี่ยงเบน ของรอยแตกจากการเสริมแรงด้วยอนุภาคที่มีความแข็งสูงหรือวิสเกอร์เข้าไปช่วยปะทะกับ การแตกร้าวทำให้การแตกร้าวเกิดการวกวนมากขึ้นทำให้ต้องใช้ความเค้นสูงกว่าจึงจะแตกร้าวได้ ดังรูปที่ 2.7 (a)



รูปที่ 2.7 แผนภาพกลไกการเพิ่มความเหนียวในวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นเซรามิก (a) การเบี่ยงเบน ของรอยแตก (b) การบีบอัดของเนื้อพื้นเนื่องจากความเค้น (c) การเพิ่มความเหนียวด้วย การเปลี่ยนเฟส และ (d) รอยแตกระดับจุลภาคของเนื้อพื้น⁽¹⁶⁾

2.3 วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์

ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นวัสดุเซรามิกนิยมนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัด แต่ความเปราะของ เซรามิกทำให้มีข้อจำกัดสำคัญในการนำมาใช้งาน การปรับปรุงสมบัติทางกลของเซรามิก โดยเฉพาะความเหนียวทำได้โดยการเติมวัสดุเสริมแรงลงในเนื้อพื้นเซรามิก ซึ่งวัสดุที่นิยมใช้เป็น เนื้อพื้นคืออะลูมินาและวัสดุเสริมแรงได้แก่ เซรามิกออกไซด์ เช่น เซอร์โคเนีย และเซรามิกที่ไม่ใช่ ออกไซด์ ได้แก่ คาร์ไบด์และไนไตรด์ เช่น ไททาเนียมคาร์ไบด์ (TiC) ทังสเตนคาร์ไบด์ (WC) ในโอเบียมคาร์ไบด์ (NbC) ไททาเนียมในไตรด์ (TiN) และคาร์ไบด์ผสม (W,Ti)C เป็นต้น ที่กล่าวมา นั้นนิยมใช้เป็นตัวเสริมแรงในอะลูมินาเพื่อใช้เป็นวัสดุตัดสำหรับงานโลหะ (metal working) นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความทนทานต่อการเสียดสีและการกระจายของอนุภาคที่มีความแข็งสูงทำ ให้วัสดุมีความแข็งและความเหนียวสูงขึ้น⁽¹⁷⁾ แม้วัสดุคาร์ไบด์มีความแข็งและสัมประสิทธิ์ การขยายตัวเชิงความร้อนคล้ายคลึงกัน แต่ทังสเตนคาร์ไบด์มีมอดูลัสความยืดหยุ่นและ ความเหนียวสูงกว่าคาร์ไบด์ชนิดอื่น⁽¹⁸⁾ วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์จึงมี ความน่าสนใจในการปรับปรุงสมบัติทางกลของอะลูมินาให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานด้านวัสดุตัด

2.3.1 อะลูมินา

อะลูมินาเป็นวัสดุเซรามิกที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกทั้งในการผลิตเซรามิกดั้งเดิม และเซรามิกสมัยใหม่ เนื่องจากอะลูมินามีสมบัติเด่นหลายด้าน (ดังแสดงในตารางที่ 2.3) อาทิ จุดหลอมเหลวสูง ความแข็งสูง ความหนาแน่นต่ำ ทนต่อการสึกกร่อนและเฉื่อยต่อปฏิกิริยา จึงมี การนำมาใช้ประโยชน์ในวงกว้าง เช่น ลูกบด ผนังกรุหม้อบด อิฐทนไฟ ครูซิเบิล เครื่องมือตัดแต่ง วัสดุ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุยานยนต์ ชิ้นส่วนลดอันตรายจากกระสุน ข้อต่อกระดูกเทียม เป็นต้น (19-20)

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **ตารางที่ 2.3** สมบัติของอะลูมินาบริสุทธิ์

Properties	α -Al ₂ O ₃	reference
Density (g/cm ³)	3.98	(12)
Melting temperature (°C)	2054	(20)
Thermal expansion coefficient	8.5	(10)
(10 ⁻⁶ /K)		
Elastic modulus (GPa)	300-400	(18)
Indentation hardness (GPa)	20	(20)
Fracture toughness (MPa.m ^{1/2})	2-4	(18)
Flexural strength (MPa)	200-400	(7)

อะลูมินาที่มีความเสถียรมากที่สุดอยู่ในรูปแอลฟาอะลูมินา (**α**-Al₂O₃) ซึ่งมีโครงสร้างผลึก เป็นเฮกซะโกนัล (Hexagonal) โดยมีออกซิเจนเรียงตัวกันแบบเฮกซะโกนัลและมีอะลูมิเนียมที่มี ขนาดเล็กกว่าแทรกอยู่ในช่องออกตะฮีดรอล 2 ใน 3 ส่วนของช่องทั้งหมด⁽²⁰⁾ ดังแสดงในรูปที่ 2.8



2.3.2 ทั้งสเตนคาร์ไบด์

ทั้งสเตนคาร์ไบด์ (WC) เป็นวัสดุเซรามิกชนิดที่ไม่ใช่ออกไซด์ มีความแข็งมาก มักใช้ใน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลซึ่งเป็นโลหะแข็ง (hard metal) สำหรับการตัดและเจาะโลหะ นอกจากนี้ ยังมีการนำไปใช้ในตลับลูกปืน (bearing) แม่พิมพ์โลหะ (dies) ใบผาน (shear blades) ลูกรีด (rolls) หัวอัดและหัวแบบรีด (forging and extrusion tools) ส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ที่มี ทังสเตนคาร์ไบด์เป็นส่วนประกอบหลักมักจะเป็นวัสดุผสมระหว่างโลหะและเซรามิก (cermet) โลหะที่ใช้มักเป็นกลุ่มเหล็ก เช่น เหล็ก นิเกิล หรือโคบอลต์ ซึ่งโลหะเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ประสาน โดยปกติแล้วมักใช้โคบอลต์กับทั้งสเตนคาร์ไบด์ซึ่งเรียกว่า ซีเมนเตตคาร์ไบด์ (cemented carbide) การเติมโลหะทรานซิชันช่วยให้ทั้งสเตนคาร์ไบด์ลดอุณหภูมิในการเผาลงมา ที่อุณหภูมิประมาณ 1500 องศาเซลเซียส โดยที่ยังมีความหนาแน่นสูง⁽²¹⁾ สำหรับการผลิตผง ทั้งสเตนคาร์ไบด์นั้นสามารถพิจารณาจากเฟสไดอะแกรมของทั้งสเตน - คาร์บอน ดังรูปที่ 2.9 ซึ่ง พบว่าช่วงของ stoichiometry สำหรับทั้งสเตนคาร์ไบด์อยู่ในช่วงค่อนข้างแคบ เมื่อปริมาณของ คาร์บอนไม่พอดีกับทั้งสเตนจะเกิดคาร์บอนอิสระหรือไดทั้งสเตนคาร์ไบด์ (di-tungsten carbide : W₂C) ขึ้น โดยทั้งสองกรณีนี้ทำให้วัสดุมีสมบัติแย่ลง เมื่อเกิดไดทังสเตนคาร์ไบด์ซึ้นจะทำให้วัสดุมี ความเหนียวลดลงได้ 2 กรณี คือ (1) ไดทั้งสเตนคาร์ไบด์มีความเปราะมากกว่าทังสเตนคาร์ไบด์ การเกิดไดทั้งสเตนคาร์ไบด์ขึ้นจึงส่งผลให้ความเหนียวลดลงและ (2) ไดทังสเตนคาร์ไบด์มักทำ ปฏิกิริยากับโคบอลต์บางส่วนทำให้เกิด (W, Co)₆C ซึ่งเฟสนี้มีความเปราะจึงทำให้ความเหนียว ลดลง ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นในการควบคุมปริมาณของคาร์บอนในเฟสไดอะแกรมของ ทั้งสเตน – คาร์บอน หรือเฟสไดอะแกรมของทั้งสเตนคาร์ไบด์ – โคบอลต์ ในขณะที่คาร์บอนอิสระมี ผลกับความเหนียวไม่มากนักแต่มีผลทำให้ความแข็งแรงและความแข็งต่ำลง จึงเป็นเหตุให้มี ความต้องการให้เกิดคาร์บอนอิสระมากกว่าการเกิดไดทั้งสเตนคาร์ไบด์⁽²¹⁻²²⁾



Properties	tungsten carbide (WC)	di-tungsten carbide W ₂ C
Theoretical density (g/cm ³)	15.8	17.3
Crystal structure	Hexagonal	Hexagonal
Lattice parameters		
a (Å)	2.906	5.814
c (Å)	2.837	0.4721
Thermal expansion coefficient	5.76	6.4 [001]
(10 ⁻⁶ /K)		8.1 [100]
Thermal conductivity (W/m.K)	29.3	29.3
Elastic modulus (GPa)	737	-
Microhardness (GPa)	21.8	18.1 – 20.6
Flexural strength (MPa)	530	-
Fracture toughness (MPa.m ^{1/2})	6.0	-

ตารางที่ 2.4 สมบัติของทั้งสเตนคาร์ไบด์และไดทั้งสเตนคาร์ไบด์⁽²¹⁾

2.3.3 การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์

จากเอกสารงานวิจัยที่<mark>ผ่านมาพบว่ามีก</mark>ารขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ 4 วิธีด้วยกัน คือ

2.3.3.1 High - Energy Reactive Milling

การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ด้วยวิธีนี้ทำได้โดยการบดผสมผง ทังสเตนไตรออกไซด์ (WO₃) ผงอะลูมิเนียม (AI) และผงคาร์บอน (C) เข้าด้วยกันตามด้วยการเผา ผนึกที่อุณหภูมิสูง⁽²³⁾ การบดผสมผงวัตถุดิบนี้ทำได้โดยใช้เครื่องบดพลังงานสูง (High energy ball mill) ซึ่งทำให้ได้โครงสร้างของผงอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีลักษณะเฉพาะตามการควบคุม สภาวะในการบดอันได้แก่ ขนาดและชนิดของลูกบด ชนิดของเครื่องมือ ชนิดของหม้อบด เวลาใน การบด อัตราส่วนระหว่างลูกบดและผงวัตถุดิบ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบดผสม เชิงกลและปฏิกิริยาทางความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการบดผสม⁽²⁴⁻²⁵⁾ วิธีนี้ทำให้ได้วัสดุเชิงประกอบ ที่มีอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตรซึ่งส่งผลให้สมบัติทางกลดีกว่าวิธีแบบดั้งเดิมที่มีขนาด อนุภาคระดับไมครอน⁽²⁶⁾ แต่การควบคุมปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้เฉพาะเฟสที่ต้องการนั้นเป็น ข้อจำกัดของวิธีนี้

2.3.3.2 Pulsed Electric Current Sintering (PECS)

Pulsed Electric Current Sintering (PECS) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือ Spark Plasma Sintering (SPS) เป็นวิธีการเผาผนึกที่อัตราการเพิ่มอุณหภูมิสูงและใช้ระยะเวลาในการเผาผนึก ้สั้นกว่าวิธีการเผาผนึกแบบดั้งเดิม ซึ่งได้แก่ การอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน การเผาผนึกแบบ ปราศจากแรงดันและการอัดขึ้นรูปด้วยความดันทุกทิศทางแบบร้อน (Hot Isostatic Pressing, HIP) เป็นต้น วิธีนี้ทำให้ได้วัสดุที่มีความหนาแน่นสูงและมีสมบัติทางกลดี S. Huang และคณะ⁽²³⁾ ้ได้เตรียมวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ด้วยวิธี PECS โดยใช้อุณหภูมิการเผาผนึก ในช่วง 1250 - 1750 องศาเซลเซียส เป็น<mark>ระยะเวลา</mark> 4 นาที ที่ความดันสูงสุด 60 เมกะพาสคัล และ ้มีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 200 อง<mark>ศาเซลเซียสต่อนาที พบ</mark>ว่าความหนาแน่นของวัสดุเชิงประกอบที่ ิเตรียมด้วยวิธีนี้มีความหนาแน่นสูงมาก (98.1 - 100 %TD) ไม่ว่าจะเติมอนุภาคทั้งสเตนคาร์ไบด์ ในเนื้อพื้นอะลูมินามากถึงร้อยละ 80 โดยปริมาตร และวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้โดยวิธีนี้มี สมบัติทางกลที่ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งและความแข็งแรงสูงถึง 25.3 กิกะพาสคัล และ ตามลำดับ อย่างไรก็ตามการโตของเกรนเกิดขึ้นเมื่อเติมอนุภาค เมกะพาสคัล 1187 ทั้งสเตนคาร์ไบด์ในปริมาณที่มากกว่าร้อยละ 40 โดยปริมาตร ส่งผลให้ความแข็งแรงลดลง เล็กน้อย แต่ความแข็งแล<mark>ะความแข็งแรงก็ยังคงสูงและมีความเ</mark>หนียว (4 เมกะพาสคัล.เมตร^{1/2}) เป็นที่ยคมรับ

2.3.3.3 การอัดขึ้นรูป<mark>ด้วยความร้อน (H</mark>ot Pressing)

การขัดขึ้นรูปด้วยความร้อนเป็นวิธีขึ้นรูปโดยใช้ความร้อนและพลังงานกลทำให้ขึ้นงานเกิด ความหนาแน่น เนื่องจากพลังงานที่ใช้เป็นลักษณะแรงกดซึ่งช่วยให้อ_นุภาคสามารถเคลื่อนที่สัมผัส กันได้ดีขึ้นขณะเผาผนึกเป็นผลทำให้ชิ้นงานมีโครงสร้างสม่ำเสมอและมีความหนาแน่นสูงใกล้เคียง ทางทฤษฏี วัสดุสามารถเกิดความหนาแน่นได้โดยปราศจากการใช้สารที่ช่วยในการเผาผนึก (sintering aids) หรือใช้สารดังกล่าวในปริมาณน้อยและขนาดเกรนละเอียด ทั้งที่ไม่มีการใช้สารที่ ช่วยในการยับยั้งการโตของเกรน การอัดขึ้นรูปในทิศทางเดียวด้วยความร้อน (Uniaxial Hot Pressing, HP) เป็นกระบวนการขึ้นรูปที่นิยมใช้กันมากที่สุดทั้งในห้องทดลองและใน ภาคอุตสาหกรรม แต่ก็มีข้อจำกัดมากคือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอัดในทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง (unidirectional or bidirectional pressing) จะมีรูปร่างเป็นแผ่นจานหรือทรงกระบอกเท่านั้น ข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งก็คือความหนาของชิ้นงานและ/หรือจำนวนชิ้นงานที่สามารถอัดให้ความร้อนได้ พร้อมๆ กัน⁽²⁷⁾ เนื่องจากทังสเตนคาร์ไบด์เป็นสารที่ไม่ใช่ออกไซด์และสามารถเกิดการออกซิเดชัน ได้ง่ายเมื่อเผาในบรรยากาศปกติที่อุณหภูมิมากกว่า 500 องศาเซลเซียส⁽²²⁾ ประกอบกับการอัดขึ้น รูปด้วยความร้อนอาจต้องใช้อุณหภูมิสูง จึงมักมีการเผาที่บรรยากาศแก๊ลเฉี่อย เช่น อาร์กอนหรือ ในโตรเจน อีกทั้งใช้เตาเผาและอุปกรณ์การอัดที่ผลิตจากแกรไฟต์ แต่ที่อุณหภูมิสูงแม่พิมพ์ที่ทำ จากแกรไฟต์จะทำปฏิกิริยากับชิ้นงานเซรามิกดังนั้นจึงควรใช้สารยับยั้งปฏิกิริยา เช่น โบรอนไนไตรด์เคลือบผนังด้านในของแบบอัด⁽²¹⁾ สำหรับส่วนประกอบภายในห้องอัดขึ้นรูปด้วย ความร้อนแสดงดังรูปที่ 2.10 วัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์ที่เตรียมโดยวิธีนี้มักใช้ อุณหภูมิในการเผาผนึกที่ 1450 - 1650 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 - 60 นาที



รูปที่ 2.10 ส่วนประกอบภายในห้องอั<mark>ดขึ้นรูป</mark>ด้วยความร้อน⁽²⁷⁾

W. Acchar และคณะ⁽⁷⁻⁸⁾ ได้เตรียมวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์ซึ่งอัด ขึ้นรูปด้วยความร้อนที่ความดัน 100 เมกะพาสคัล อุณหภูมิ 1650 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที นอกจากนี้ยังอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนที่ความดัน 20 เมกะพาสคัล อุณหภูมิ 1450 องศาเซลเซียสในความดันบรรยากาศอาร์กอน พบว่าวัสดุชนิดนี้มีค่าความแข็งอยู่ในช่วง 16-19 กิกะพาสคัล และมีค่าความเหนียวสูงที่สุดเท่ากับ 7.1 เมกะพาสคัล.เมตร^{1/2}เมื่อเติม ทังสเตนคาร์ไบด์ร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก ส่วน L. Wang และคณะ⁽⁵⁻⁶⁾ ได้เตรียมวัสดุชนิดนี้โดยอัด ขึ้นรูปด้วยความร้อนที่ความดันบรรยากาศ 12 เมกะพาสคัล อุณหภูมิ 1450 องศาเซลเซียสและ 1550 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง พบว่าวัสดุเชิงประกอบมีสมบัติทางกลและมีสมบัติ ทางความร้อนดีขึ้น ซึ่งทำให้วัสดุเชิงประกอบสามารถทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน เพิ่มขึ้นอีก 70 องศาเซลเซียส และมีความเหนียวและความแข็งแรงเท่ากับ 5.13 เมกะพาสคัล. เมตร^{1/2}และ 580 เมกะพาสคัล ตามลำดับ

งานวิจัยของ W. Acchar และ L. Wang มีความสอดคล้องกันกล่าวคือ ทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่ กระจายอย่างสม่ำเสมออยู่ในเนื้อพื้นอะลูมินาทำให้ขนาดเกรนของอะลูมินาลดลงและอนุภาค ทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่มีอยู่ไปขัดขวางการขยายตัวของรอยแตก ทำให้รอยแตกเบี่ยงเบนไปจากเดิม (ดังรูปที่ 2.11) ทำให้แรงขับดันที่ทำให้เกิดรอยแตกที่ปลายรอยแตกอ่อนแรงลง ซึ่งกลไกนี้ช่วย เพิ่มความเหนียวและความแข็งแรงของวัสดุเชิงประกอบชนิดนี้



รูปที่ 2.11 รอ<mark>ยแตกในวัสดุ</mark>เชิงประกอบอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์⁽⁵⁾

2.3.3.4 การเผาผนึกแบบปราศจากแรงดัน (Pressureless Sintering)

การเผาผนึกด้วยวิธีนี้ส่งผลให้สมบัติทางกลของวัสดุไม่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการอัดขึ้นรูป ด้วยความร้อน อย่างไรก็ตามการผลิตวัสดุด้วยวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ทำให้การเตรียม วัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์ด้วยวิธีการเผาผนึกแบบปราศจากแรงดันยังคงมี ความน่าสนใจ W. Acchar และคณะ⁽⁷⁾ ได้เติม Y₂O₃ ร้อยละ 3 โดยน้ำหนักในวัสดุเชิงประกอบ อะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีผงทังสเตนคาร์ไบด์ร้อยละ 5 10 20 และ 30 โดยน้ำหนัก ทำ การเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1650 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาที ในความดันบรรยากาศ อาร์กอน พบว่าการเผาผนึกแบบปราศจากแรงดันทำให้วัสดุเชิงประกอบมีความหนาแน่นต่ำซึ่ง ส่งผลให้ความแข็งและความเหนียวต่ำ ส่วนการเติม Y₂O₃ แม้จะเพิ่มความหนาแน่นของ วัสดุเชิงประกอบได้มากกว่า 95 %TD แต่ความแข็งและความเหนียวก็ยังไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเฟล ของอิตเทรียมอะลูมินัมการ์เนต (3Y₂O₃.5AI₂O₃ : YAG) หลงเหลืออยู่ซึ่งไปลดความแข็งแรงของ พันธะระหว่างเกรนของอะลูมินากับทังสเตนคาร์ไบด์ ส่วนการเติมทังสเตนคาร์ไบด์ในปริมาณที่ มากขึ้นทำให้ขนาดเกรนของอะลูมินาเล็กลง สำหรับวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่ ขึ้นรูปด้วยวิธีนี้ปริมาณของทังสเตนคาร์ไบด์ที่เหมาะสมอยู่ที่ร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ซึ่งให้ความแข็ง และความเหนียวสูงที่สุด ส่วนการเติม Y₂O₃ปริมาณของทังสเตนคาร์ไบด์ที่เหมาะสมอยู่ที่ร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก

การเผาวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์โดยปราศจากแรงดันเพื่อใช้เป็น วัสดุตัดยังมีข้อจำกัดในการใช้งานเนื่องจากสมบัติทางกลมีค่าค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามเมื่อ เปรียบเทียบการผลิตวัสดุเชิงประกอบด้วยวิธีนี้กับวิธีอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าวิธีนี้มีค่าใช้จ่าย ในการผลิตไม่สูงมาก สามารถผลิตชิ้นงานได้จำนวนมาก อีกทั้งมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน เหมือนวิธีอื่นๆ ส่วนการปรับปรุงสมบัติทางกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหนียวและความแข็งแรง ให้เพียงพอต่อการนำไปใช้งานเป็นเรื่องที่ต้องทำการศึกษาต่อไป ซึ่งวัสดุโดยทั่วไปนิยมเติม เซอร์โคเนียเพื่อเพิ่มความเหนียวโดยอาศัยการเปลี่ยนเฟส (transformation toughening) ดังจะ กล่าวในหัวข้อต่อไป

2.4 เซอร์โคเนีย

2.4.1 โครงสร้างผลึกของเซอร์โคเนีย

เซอร์โคเนียเป็นวัสดุเซรามิกอีกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถพบได้ตามธรรมชาติ เซอร์โคเนียที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยทั่วไปจะพบอยู่ในรูปแร่แบดดีเลไอต์ (Baddeleyite : ZrO₂) หรือเซอร์คอน (ZrSiO₄) ซึ่งมักจะมีปริมาณของ Hafnium Oxide เจือปนอยู่เล็กน้อย เมื่อแยกสิ่งเจือปนออกจาก แบดดีเลไอต์แล้วได้เซอร์โคเนียบริสุทธิ์มากถึงร้อยละ 80-90

เซอร์โคเนียมีสมบัติเด่นหลายประการ เช่น ความหนาแน่นสูง การนำความร้อนต่ำ ทนต่อ การกัดกร่อน มีความแข็งแล<mark>ะมีความเหนียวสูง เซอร์โคเนียบริสุทธิ์</mark>มีรูปผลึกอยู่ 3 รูปผลึกด้วยกัน^{(20,} ²⁸⁾ คือ มอโนคลินิก (monoclinic : m-ZrO₂) เททระโกนัล (tetragonal : t-ZrO₂) และ ลูกบาศก์ (cubic : c-ZrO₂) ดังรูปที่ 2.12 แต่ละรูปผลึกจะเสถียร (stable) ที่อุณหภูมิแตกต่างกันไป รูปผลึกแบบมอโนคลินิกจะเสถียรที่อุณหภูมิห้องจนถึงอุณหภูมิ 1170 องศาเซลเซียสและจะเกิด การเปลี่ยนรูปผลึกเป็นเททระโกนัลที่ช่วงอุณหภูมิ 1170 – 2370 องศาเซลเซียส รูปผลึกแบบ ลูกบาศก์มีความเสถียรที่ช่วงอุณหภูมิ 2370 – 2680 องศาเซลเซียส ก่อนหลอมเหลว มอโนคลินิก สามารถเปลี่ยนรูปผลึกไปเป็นเททระโกนัลและลูกบาศก์ที่อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งผลของการเปลี่ยน โครงสร้างนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร 3 - 5 เปอร์เซ็นต์ โดยผลของการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวก่อให้เกิดความเค้น (internal stress) สูงและเกิดรอยแตกของเซอร์โคเนียบริสุทธิ์ขณะเย็น ตัวจากอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังส่งผลให้มอดูลัสความยืดหยุ่นและความแข็งแรงลดลง⁽²⁹⁾ ทำให้ เซอร์โคเนียบริสุทธิ์ไม่สามารถใช้เป็นวัสดุทนไฟโดยตรงได้ อย่างไรก็ดีผลของการเปลี่ยนแปลง ้ปริมาตรดังกล่าวนี้กลับเป็นจุดเด่นของเซอร์โคเนีย กล่าวคือสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดย การเติมสารบางตัวที่เรียกว่า สารสร้างความเสถียร เมื่อเติมสารดังกล่าวแล้วเซอร์โคเนียจะสามารถ ้คงรูปผลึกที่อุณหภูมิสูง ณ อุณหภูมิห้องและนำมาใช้งานที่อุณหภูมิปกติและมีสมบัติพิเศษที่ ้สำคัญมากประการหนึ่งคือความเหนียวซึ่งเซรามิกซนิดอื่นไม่มี



รูปที่ 2.12 โครงสร้างผลึกของเซอร์โคเนีย (a) มอโนคลินิก (b) เททระโกนัล และ (c) ลูกบาศก์⁽³⁰⁾

2.4.2 รูปแบบเสถียรของเซ<mark>อร์โคเนีย</mark>

สารสร้างความเสถียรบางตัวถูกเติมเข้าไปเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายเนื่องจาก การเปลี่ยนรูปผลึก โดยสารที่นิยมใช้โดยทั่วไปมักเป็นสารประกอบออกไซด์ เช่น แมกนีเซียม ออกไซด์ (MgO) อิตเทรียมออกไซด์ (Y₂O₃) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) สแกนเดียมออกไซด์ (Sc₂O₃) อิตเทอเบียมออกไซด์ (Yb₂O₃) ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) และซีเซียมออกไซด์ (CeO₂)^(9. 28. 31) เป็นต้น เมื่อเติมเข้าไปในเซอร์โคเนียในปริมาณที่เหมาะสม สารดังกล่าวนี้จะทำให้ โครงสร้างของเซอร์โคเนียเสถียรในรูปผลึกแบบเททระโกนัลหรือลูกบาศก์ การเติมสารสร้าง ความเสถียรที่ต่างชนิดและปริมาณที่ต่างกันจะทำให้ได้โครงสร้างจุลภาคที่ต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่ง ลักษณะความแตกต่างของโครงสร้างจุลภาคได้เป็น 3 ลักษณะ (ดังรูปที่ 2.13) คือ Partially Stabilized Zircinia (PSZ), Tetragonal Zirconia Polycrystals (TZP) และ Zirconia – Toughened Ceramics (ZTCs)



c.Yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystalline (Y-TZP)

รูปที่ 2.13 ลักษณะโครงสร้างของรูปแบบเสถียรของเซอร์โคเนีย⁽³²⁾
2.4.2.1 Partially Stabilized Zirconia (PSZ)

PSZ คือลักษณะของเซอร์โคเนียที่บางส่วนเสถียรในรูปผลึกเททระโกนัลแล้วกระจายอยู่ใน รูปผลึกแบบลูกบาศก์ โดยทั่วไปการทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะนี้จะใช้ MgO หรือ CaO เป็น สารสร้างความเสถียร โดยทั่วไปแล้ว Mg-PSZ ในทางอุตสาหกรรมมีการใช้ปริมาณของ MgO ในช่วง 8 – 10 mol% หากพิจารณาจากเฟสไดอะแกรมในระบบของ ZrO₂ และ MgO ดังรูปที่ 2.14 เมื่อพิจารณาในช่วง MgO น้อยกว่า 8 mol% จะพบว่าต้องใช้อุณหภูมิสูงในการเกิดสารละลาย ของแข็งอย่างสม่ำเสมอในรูปผลึกลูกบาศก์ หากทำให้สารละลายของแข็งนี้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว (quench) มาอยู่ในบริเวณที่เกิดสารละลายของแข็งรูปผลึกลูกบาศก์และรูปผลึกเททระโกนัลใน บริเวณนี้จะเกิดนิวเคลียสของสารละลายแข็งรูปผลึกเททระโกนัลซึ่งสามารถควบคุมขนาดของ นิวเคลียสได้ โดยการควบคุมอัตราการลดอุณหภูมิจากช่วงอุณหภูมิดังกล่าวมาที่อุณหภูมิห้อง กระบวนการดังกล่าวนี้จะได้ PSZ ผลึกของเททระโกนัลนี้สามารถเปลี่ยนรูปเป็นมอโนคลินิก เซอร์โคเนียได้เมื่อมีแรงภายนอกมากระทำจึงเป็นกระบวนการการเกิดความเหนียวที่สำคัญ กระบวนการหนึ่ง ดังจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป ส่วนช่วง MgO มากว่า 10 mol% มีการเกิด สารละลายของแข็งไม่มากพอที่จะเกิดการเพิ่มความเหนียวด้วยการเปลี่ยนเฟล⁽³¹⁾



รูปที่ 2.14 เฟสไดอะแกรมของ MgO – ZrO₂⁽³¹⁾

แคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็นสารประกอบออกไซด์ชนิดหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อทำให้เกิด สารละลาย ของแข็งในเซอร์โคเนีย เมื่อพิจารณาเฟสไดอะแกรมในระบบของ CaO – ZrO₂ ดังรูปที่ 2.15 พบว่ามีช่วงที่น่าสนใจด้วยกัน 3 ช่วง คือ ช่วงที่ปริมาณ CaO น้อยกว่า 6 mol% ที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 2000 องศาเซลเซียส จะเกิดสารละลายของแข็งมอโนคลินิกกับ CaZr₄O₉ ในช่วงที่ปริมาณ CaO อยู่ระหว่าง 6 – 17 mol% โดยประมาณ ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1140 องศาเซลเซียส จะเกิด สารละลายของแข็งลูกบาศก์และเททระโกนัล (PSZ) เมื่อทำให้เกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว เททระโกนัลจะเปลี่ยนเป็นมอโนคลินิกในผลึกลูกบาศก์ที่กึ่งเสถียร หากเกิดการเย็นตัวอย่างช้าๆ ในช่วงอุณหภูมิ 1000 – 1140 องศาเซลเซียส จะเกิดสารละลายของแข็งเททระโกนัล นอกจากนี้ที่ อุณหภูมิในการเย็นตัวต่ำกว่า 1000 องศาเซลเซียส ก่อให้เกิด martensitic transformation ของ สารละลายของแข็งเททระโกนัลไปเป็นมอโนคลินิก ในช่วงปริมาณของ CaO ที่ก่อให้เกิดผลึก ลูกบาศก์นั้นเรียกว่า fully stabilized zirconia โดยทั่วไปแล้วผลึกลูกบาศก์นี้อยู่ในสภาวะกึ่งเสถียร การเผาแข่ (aging) ที่อุณหภูมิสูงกว่า 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานสามารถทำให้เปลี่ยนรูป ผลึกได้^(28, 33)



รูปที่ 2.15 เฟสไดอะแกรมของ CaO – ZrO₂⁽³⁰⁾

2.4.2.2 Tetragonal Zirconia Polycrystals (TZPs)

TZP คือ เซอร์โคเนียที่เสถียรอยู่ในรูปผลึกเททระโกนัลทั้งหมด โดยทั่วไปจะเกิดจากการใช้ Y₂O₃ เป็นสารสร้างความเสถียร หากพิจารณาเฟสไดอะแกรมในระบบของ Y₂O₃ - ZrO₂ในช่วง 0 – 5 mol% ของ Y₂O₃ จะพบว่าที่ช่วงอุณหภูมิประมาณ 1300 - 1650 องศาเซลเซียส เซอร์โคเนียจะ อยู่ในรูปผลึกเททระโกนัลเกือบทั้งหมด ซึ่งหากทำให้เซอร์โคเนียที่อยู่ในสภาพดังกล่าวเย็นตัวอย่าง รวดเร็วมาที่อุณหภูมิห้องจะได้เซอร์โคเนียที่อยู่ในรูป TZP ดังรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.16 เฟสไดอะแกรมของ Y₂O₃ - ZrO₂⁽²⁰⁾

2.4.2.3 Zirconia – Toughened Ceramics (ZTCs)

ZTCs คือรูปผลึกเททระโกนัลหรือมอโนคลินิคของเซอร์โคเนียที่มีความละเอียดระดับ ไมครอนกระจายอยู่ในเนื้อพื้นอื่นที่ไม่ใช่เซอร์โคเนีย เช่น อะลูมินาและมัลไลต์ หากเซอร์โคเนีย กระจายอยู่ในเนื้อพื้นอะลูมินาโดยทั่วไปเรียกว่า Zirconia toughened alumina (ZTA) ส่วน เซอร์โคเนียที่กระจายอยู่ในเนื้อพื้นมัลไลต์เรียกว่า Zirconia toughened mullite (ZTM) การเปลี่ยน รูปผลึกของเซอร์โคเนียในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาค ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและตำแหน่งที่ อนุภาคเซอร์โคเนียกระจายอยู่ (ตามขอบเกรนหรือในเกรนของเนื้อพื้น)⁽³²⁾ สำหรับ ZTA ทำให้ได้ วัสดุที่มีความเหนียวและความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมี ความเฉื่อยต่อปฏิกิริยาสูงแต่ส่งผลให้ความแข็งและความทนต่อการสึกหรอลดลงเมื่อเทียบ กับอะลูมินา⁽³⁴⁻³⁵⁾ ส่วนวัสดุ ZTM มีความแข็ง ความเหนียวและความต้านทานการดัดโค้ง ณ อุณหภูมิห้องสูงกว่ามัลไลต์⁽³⁶⁾ แต่มีความทนต่อการสึกหรอลดลงเช่นเดียวกัน

2.4.3 กลไกการเพิ่มความเหนียว (Transformation toughening)

กลไกการเพิ่มความเหนียวของเซอร์โคเนียโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) การเพิ่ม ความเหนียวโดยการเปลี่ยนเฟสเป็นเททระโกนัลในเซอร์โคเนีย (stress induced transformation toughening) และ (2) การเพิ่มความเหนียวโดยการเกิดรอยแตกระดับจุลภาค (microcracking)⁽²⁹⁾

ดังที่กล่าวมาข้างต้นการเพิ่มความเสถียรของเซอร์โคเนียให้มีผลึกเททระโกนัลซึ่งอยู่ใน สภาวะกึ่งเสถียรกระจายอยู่ในผลึกลูกบาศก์ เมื่อวัสดุถูกกระทำด้วยความเค้น (stress) อาจอยู่ใน รูปของแรงกระแทก (impact) แรงขัดสี (wear) หรือจากการทุบตี (attack) เททระโกนัลนี้จะรับ พลังงานเอาไว้ โดยเอามาใช้สำหรับการเปลี่ยนโครงสร้างเป็น มอโนคลินิกซึ่งเป็นเฟสที่เสถียรกว่า เททระโกนัล การเปลี่ยนโครงสร้างนี้จะเกิดเฉพาะบริเวณที่ถูกแรงกระทำและเกิดการเปลี่ยนแปลง ปริมาตร ทำให้เกิดความเค้นอัด (compressive strain) ขึ้นรอบๆ ผลึกมอโนคลินิกดังรูปที่ 2.17 เมื่อมีรอยแตกและผ่านบริเวณที่มีความเค้นอัดจะทำให้รอยแตกต้องใช้พลังงานมากในการ เคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการแตกผ่านบริเวณนั้นมีความยากยิ่งขึ้นเนื่องจาก เกิดแรงกดบริเวณปลายของรอยแตก ทำให้วัสดุสามารถต้านทานการแตกหักได้ดียิ่งขึ้น ความเหนียวและความแข็งแรงสูงขึ้น หากเททระโกนัลมีขนาดเล็กพอเมื่อเกิดการเย็นตัวหลัง การเผาก็สามารถเกิดเฟสเททระโกนัลกึ่งเสถียรได้เช่นกัน^(28, 33, 37)



รูปที่ 2.17 (a) บริเวณของความเค้นอัดที่เกิดจากการเปลี่ยนเฟส และ (b) การเกิด martensitic transformation บนผิวหน้าวัสดุที่ได้รับการขัดซึ่งทำให้เกิดความเค้นอัดบริเวณผิว ด้านหน้า⁽³⁷⁾

ช่วงขนาดอนุภาควิกฤติ (critical particle size) ของเซอร์โคเนียก็มีความสำคัญใน การเปลี่ยนเฟสและการเกิดความเหนียว หากมีขนาดเล็กกว่าขนาดวิกฤติก็จะไม่เกิดการเปลี่ยน เฟส หากมีขนาดใหญ่กว่าขนาดวิกฤติการเปลี่ยนเฟสจะเกิดขึ้นเอง (spontaneous transform) ขนาดวิกฤตินี้ขึ้นอยู่กับเนื้อพื้นและองค์ประกอบของเซอร์โคเนีย เช่น สารสร้างความเสถียรหรือ chemical free energy⁽³³⁾

กระบวนการเย็นตัวหลังการเผาสามารถทำให้วัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นเซรามิกที่มีอนุภาค ของเซอร์โคเนียกระจายอยู่เกิดการเปลี่ยนเฟสซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดรอยแตกระดับจุลภาคเนื่องจาก เนื้อพื้นที่อยู่โดยรอบอนุภาคของเซอร์โคเนียต้านการขยายตัวของเซอร์โคเนียทำให้เกิดความเค้น เกิดขึ้นบริเวณนั้น การเกิดรอยแตกระดับจุลภาคสามารถลดความเค้นที่เกิดขึ้นนี้ได้ดังรูปที่ 2.18 เมื่อชิ้นงานเกิดรอยแตกและรอยแตกนั้นผ่านมาถึงอนุภาคของเซอร์โคเนียที่มีการเปลี่ยนเฟส รอยแตกจะเกิดการเบี่ยงเบนไปและความเค้นที่อยู่ปลายรอยแตกจะถูกรอยแตกระดับจุลภาค ดูดกลืนพลังงานหรือกระจายพลังงานของรอยแตกดังรูปที่ 2.18 (b) โดยรอยแตกระดับจุลภาค ขยายออกจากอนุภาคที่เกิดการเปลี่ยนเฟสตามทิศทางของแนวเกรนทำให้ความเหนียวของ เซรามิกเพิ่มขึ้น ขนาดของอนุภาคต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะทำให้ เกิดการเปลี่ยนเฟสแต่ทำให้ เกิดรอยแตกระดับจุลภาคในปริมาณจำกัด ซึ่งสามารถควบคุมได้โดยระยะเวลาในการเผาหรือ สภาวะการเผาแซ่ (ageing condition)



รูปที่ 2.18 การเปลี่ยนเฟสของเซอร์โคเนียซึ่งก่อให้เกิดรอยแตกระดับจุลภาครอบอนุภาค เซอร์โคเนีย (a) รอยแตกเคลื่อนเข้าไปยังอนุภาคและ (b) รอยแตกแยกออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งช่วยเพิ่มความเหนียว⁽³³⁾

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้ทำการอัดขึ้นรูปอะลูมินาและวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Mg-PSZ และ Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งร้อยละ 1.5 3.0 4.5 และ 6.0 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ และทำ การเผาผนึกแบบปราศจากแรงดัน ณ อุณหภูมิ 1400 – 1600 องศาเซลเซียส ซึ่งบทนี้ได้กล่าวถึง วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง เงื่อนไขและตัวแปรในการทดลอง เทคนิคการเตรียม ตัวอย่าง การวัดสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล รวมทั้งการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ซึ่ง สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 วัตถุดิบและสารเค<mark>ม</mark>ี

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทดลองนี้ คือ ผงอะลูมินา (สูตรเคมี Al₂O₃) เกรด AKP30 จาก บริษัท Sumitomo chemical ประเทศญี่ปุ่น เป็นอะลูมินาที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 99.99 โดยน้ำหนัก (มีขนาดอนุภาค 0.3 ไมครอน) และมีพื้นที่ผิวจำเพาะ 5-10 ตารางเมตรต่อกรัม⁽³⁸⁾ และ ใช้ผงทังสเตนคาร์ไบด์ (สูตรเคมี WC) จากบริษัท ATI Alldyne ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับสารเติมแต่งที่ใช้ คือ ผงเซอร์โคเนียกึ่งเสถียร (Partially Stabilized Zirconia, PSZ) 2 ชนิด ได้แก่ Mg-PSZ และ Ca-PSZ จากบริษัท Fukushima ประเทศญี่ปุ่น ส่วนตัวเชื่อมประสาน ที่ใช้คือ พอลิไวนิลบิวทิรอล (PVB) จากบริษัท Wako Pure Chemical ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีน้ำหนัก โมเลกุล 630 รวมทั้งใช้เอทานอล (สูตรเคมี C₆H₆O) ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.9 โดยปริมาตร จาก บริษัท J. T. Baker ประเทศมาเลเซีย เป็นตัวกลางที่ใช้ในการบดผสมผงวัตถุดิบ

3.2 ระเบียบวิธีทดลอง

3.2.1 การออกแบบการทดลอง

สำหรับการทดลองในงานวิจัยนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ การทดลองตอนที่ 1 เป็น การทดลองเพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ทำให้วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Mg-PSZ หรือ Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่ง มีสมบัติทางกลเหมาะสมที่สุดต่อการใช้งาน โดยเลือก ตัวอย่างที่มีอัตราส่วนระหว่างอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์ร้อยละ 90 : 10 โดยน้ำหนัก และใช้ เซอร์โคเนียเจือปนในเนื้อส่วนผสมร้อยละ 6.0 โดยน้ำหนัก และทำการเผาผนึกในช่วงอุณหภูมิ 1400 – 1600 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 3.1 การทดลองตอนที่ 2 เป็นการทดลองเพื่อหาอัตราส่วนของสารเติมแต่ง Mg-PSZ และ Ca-PSZ ต่ออะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีสมบัติทางกลเหมาะสมที่สุดต่อการใช้งาน โดยมี อัตราส่วนระหว่างอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์ร้อยละ 90 : 10 โดยน้ำหนัก และใช้เซอร์โคเนีย เจือปนในเนื้อส่วนผสมตั้งแต่ร้อยละ 0 1.5 3.0 4.5 และ 6.0 โดยน้ำหนัก และทำการเผาผนึกที่ อุณหภูมิที่ได้จากการทดลองตอนที่ 1 ดังรูปที่ 3.2

3.2.2 การเตรียมตัวอย่าง

เตรียมส่วนผสมผงวัตถุดิบและบดผสมผงวัตถุดิบในเอทานอลให้เข้ากันด้วยลูกบด
 อะลูมินาเป็นเวลา 4 ชั่วโมง

2) คัดแยกลูกบดออกจากวัตถุดิบและอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส

 3) นำวัตถุดิบที่แห้งแล้วไปบดและร่อนด้วยตะแกรงร่อน 100 เมช ส่วนการเตรียมผง สำหรับอัดขึ้นรูปเพื่อวัดความต้านทานต่อการดัดโค้งทำได้โดยละลายพอลิไวนิลบิวทิรอลกับ เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก หลังจากนั้นผสมผงวัตถุดิบที่ร่อนแล้วกับสารละลาย พอลิไวนิลบิวทิรอลร้อยละ10 โดยน้ำหนักของส่วนผสม หลังจากนั้นนำไปร่อนด้วยตะแกรงร่อนอีก ครั้ง

4) ขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแบบไฮดรอลิกโดยใช้ความดัน 30 เมกะพาสคัล และใช้แม่พิมพ์ ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร ส่วนการอัดขึ้นรูปเพื่อนำไปวัดความต้านทานต่อ การดัดโค้งใช้แม่พิมพ์รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 36 มิลลิเมตร × 10 มิลลิเมตร

5) นำตัวอย่างที่ผ่านการอัดขึ้นรูปแล้วอบให้แห้งและใส่ในแม่แบบแกรไฟต์ที่เคลือบด้วย โบรอนไนไตรด์ แล้วนำไปเผาในเตาแกรไฟต์ที่ควบคุมบรรยากาศอาร์กอน (ดังแสดงในรูปที่ 3.3) โดยใช้อุณหภูมิการเผาในช่วง 1400 – 1600 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง สำหรับ การทดลองตอนที่ 2 ทำโดยเปลี่ยนอุณหภูมิในการเผาผนึกเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมและได้จาก การทดลองตอนที่ 1 ซึ่งมีระดับอุณหภูมิ ช่วงเวลาและบรรยากาศในการเผาผนึกสารตัวอย่างดังรูป ที่ 3.4

6) ทำการวิเคราะห์สมบัติของตัวอย่างหลังเผา ได้แก่ องค์ประกอบทางเฟส ความหนาแน่น ความแข็ง ความเหนียว ความต้านทานต่อการดัดโค้งและโครงสร้างจุลภาค



รูปที่ 3.1 แผนผังงานวิจัย



รูปที่ 3.2 แผนผังงานวิจัย (ต่อ)







3.3 การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของผงวัตถุดิบ

3.3.1 การกระจายขนาดของอนุภาค (Particle size distribution)

ทำการตรวจสอบการกระจายขนาดอนุภาคของผงอะลูมินา ผงทังสเตนคาร์ไบด์ ผง Mg-PSZ และผง Ca-PSZ โดยนำผงตัวอย่างมาทำการกระจายตัวในน้ำกลั่นและใช้เทคนิค Laser Light Scattering (Particle Size Analyzer, Mastersizer 2000, Malvern)

3.3.2 สัณฐานวิทยา (Morphology)

ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผงอะลูมินา ผงทังสเตนคาร์ไบด์ ผง Mg-PSZ และผง Ca-PSZ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) (JSM-6480LV, JEOL) สำหรับการเตรียมตัวอย่างทำโดยติดเทปกาวคาร์บอน ด้านบนของก้านวางตัวอย่าง และโรยผงตัวอย่างให้กระจายลงบนด้านหน้าเทปกาวคาร์บอนบางๆ จากนั้นใช้ลูกยางเป่าลมและบัดฝุ่นของเศษผงตัวอย่างที่ไม่ยึดติดบนก้านวางตัวอย่างออก ทำ การฉาบผิวด้วยทองเพื่อทำให้เกิดการนำไฟฟ้า จากนั้นจึงนำเข้ากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราดและใช้ความต่างศักย์ 20 กิโลโวลต์

3.3.3 องค์ประกอบทางเฟส (Phase content)

ตรวจสอบองค์ประกอบทางเฟสของผงอะลูมินา ผงทังสเตนคาร์ไบด์ ผง Mg-PSZ และผง Ca-PSZ โดยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ด้วยเครื่อง X-ray Diffractometer (D8 Advanced, Bruker) สำหรับการเตรียมสารตัวอย่างทำได้โดยบดผงตัวอย่างให้ละเอียด หลังจาก นั้นนำผงตัวอย่างใส่ลงในกรอบใส่ผงตัวอย่างแล้วใช้แผ่นกระจกสไลด์กดผงตัวอย่างที่อยู่ในกรอบ ให้เรียบแน่นและกระจายเต็มกรอบใส่ผงตัวอย่าง เสร็จแล้วนำไปตรวจหาองค์ประกอบทางเฟสโดย มีตัวแปรที่ใช้ในการทดลองดังตารางที่ 3.1

Scan angle (degree)	20-80		
Scan rate (°/point)	0.02		
Temperature (°C)	25 (Room temperature)		
Target	Cu K $_{\alpha}$ (λ = 1.54060 Å)		
Filter	Ni		
Generator voltage (kV)	40		
Generator current (mA)	40		

ตารางที่ 3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการหาองค์ประกอบทางเฟสด้วยเครื่อง X- ray Diffractometer

3.4 การวิเคราะห์สมบัติของตัวอย่าง (Characterization)

3.4.1 ความหนาแน่นของตัวอย่าง (Density)

3.4.1.1 ความหนาแน่นของตัวอย่างก่อนเผา (Green density)

ความหนาแน่นของตัวอย่างก่อนเผา (ρ_{green}) สามารถหาได้โดยการชั่งน้ำหนักของตัวอย่าง (*m*) หลังจากขึ้นรูปด้วยการอัดและทำการวัดขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางและความหนาของตัวอย่าง ด้วยเวอร์เนีย หลังจากนั้นนำค่าที่วัดได้มาทำการคำนวณปริมาตร (*V*) และความหนาแน่นดัง สมการ (3.1)

Green density
$$\left(\rho_{green}\right) = \frac{m}{V}$$
 (3.1)

3.4.1.2 ความหนาแน่นของตัวอย่างหลังเผา (As – sintered density)

ความหนาแน่นหลังเผาของตัวอย่างหรือความหนาแน่นรวม (bulk density, *ρ*_{bulk}) ใช้ หลักการแทนที่ของของเหลว (Archimedes' method) โดยคำนวณความหนาแน่นรวมจากน้ำหนัก ที่ชั่งได้ตาม ASTM : Designation C830-93⁽³⁹⁻⁴⁰⁾ และคำนวณความหนาแน่นเชิงทฤษฎีจากกฎ ของผสม (Rule-of-mixtures) แล้วคำนวณความหนาแน่นสัมพันธ์จากความหนาแน่นรวมและ ความหนาแน่นเชิงทฤษฎี

้สำหรับวิธีการหาความหนา<mark>แน่นรวมโดยใช้หลัก</mark>อาร์คิมีดิสทำดังนี้

1) นำตัวอย่างที่วางบนจานเพาะเชื้อ และน้ำกลั่นที่ใส่ในปีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิเมตร ไป วางลงในเครื่องดูดอากาศโดยหันปากบีกเกอร์ให้ตรงกับจานเพาะเชื้อ

2) เปิดเครื่องดูดอากาศ แล้วสังเกตเข็มวัดความดันว่าลดลงหรือไม่ เมื่อความดันลดลงให้ จับเวลาเพื่อดูดอากาศเป็นเวลา 30 นาที เพื่อกำจัดอากาศที่อยู่ในรูพรุนเปิด เมื่อครบ 30 นาทีแล้ว เทน้ำกลั่นในบีกเกอร์ลงในจานเพาะเชื้อให้ท่วมตัวอย่างแล้วดูดอากาศอีก 45 นาที เพื่อให้น้ำเข้าไป แทนที่อากาศในรูพรุนเปิด

 นำตัวอย่างมาชั่งน้ำหนักเปียก (W_{sat}) และน้ำหนักของตัวอย่างในน้ำ (W_{sus}) ด้วย เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง แล้วนำตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นชั่งน้ำหนักแห้งของตัวอย่าง (W_{dry}) ด้วยเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง

4) คำนวณความหนาแน่นรวม (*W_{total}*) ความหนาแน่นเชิงทฤษฎี (ρ_{th}) และ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (%TD) ดังสมการ (3.2) - (3.4) ตามลำดับ

Bulk density
$$(\rho_{bulk}) = \frac{W_{dry}}{W_{sat} - W_{sus}} \times \rho_{water}$$
 (3.2)

Theoretical density
$$(\rho_{th}) = \frac{W_{total}}{\left(\frac{W_a}{\rho_a} + \frac{W_b}{\rho_b} + \cdots\right)}$$
 (3.3)

Relative density (%TD) =
$$\frac{\rho_{bulk}}{\rho_{th}} \times 100$$
 (3.4)

ความหนาแน่นของอะลูมินา ทั้งสเตนคาร์ไบด์ Mg-PSZ และ Ca-PSZ ที่ใช้ใน การทดลองนี้แสดงดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ความหนาแน่นขอ<mark>งอะลูมินา ทังสเตนคาร์ไบด์</mark> Mg-PSZ และ Ca-PSZ

วัตถุดิบ	ความหนาแน่น (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)
อะลูมินา	3.97 ^(27, 41)
ทั้งสเตนคาร์ไบด์	15.8 ⁽²⁷⁾
Mg-PSZ	5.71 ⁽⁹⁾ (3 wt% MgO, 97 wt% ZrO ₂)
Ca-PSZ	5.75 ⁽⁹⁾ (3 wt% CaO, 97 wt% ZrO ₂)

3.4.2 การหาองค์ประกอบทางเฟสของตัวอย่าง (Phase content)

การหาองค์ประกอบทางเฟสของตัวอย่างหลังเผาทำได้โดยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของ รังสีเอ็กซ์ ด้วยเครื่อง X-ray Diffractometer เช่นเดียวกับหัวข้อที่ 3.3.3

3.4.3 การทดสอบความแข็งและความเหนียว (Hardness and fracture toughness)

ความแข็งและความเหนียว ใช้เทคนิคการกดด้วยหัวกดวิกเกอร์สโดยใช้เครื่อง Vickers hardness tester (HV-50A, Laizhou Huayin) ดังแสดงในรูปที่ 3.5 (a) และใช้แรงกด 10 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 15 วินาที หลังจากนั้นทำการคำนวณหาความแข็งของตัวอย่างโดยวัดเส้นทแยงมุม ของรอยกด (d₁ และ d₂) บนตัวอย่างตาม ASTM : Designation C 1327-03⁽⁴²⁾ และคำนวณหา ความเหนียวของตัวอย่างโดยวัดความยาวของรอยแตก (c)⁽⁴³⁾ ดังรูปที่ 3.5 (b)



รูปที่ 3.5 (a) Vickers hardness tester และ (b) การวัดขนาดของรอยกดและความยาวของ รอยแตกด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง

การเตรียมตัวอย่างก่อนทำการวัดความแข็งและความเหนียวสามารถเตรียมได้ดังขั้นตอน ต่อไปนี้

 ทำตัวเรือนเพื่อให้สะดวกในการถือจับ โดยการทาวาสลีนบนผิวหน้าของกระจกและ ท่อพีวีซีซึ่งใช้เป็นแบบหล่อเรือนจับชิ้นงาน หลังจากนั้นนำท่อพีวีซีวางบนกระจกและทำการอุด บริเวณรอยต่อด้วยดินน้ำมัน วางตัวอย่างบนกระจกบริเวณด้านในของท่อพีวีซี แล้วนำเรซินอิพอกซี ที่ผสมกับสารช่วยในการแข็งตัวพร้อมกับผงอะลูมินาเทลงในท่อพีวีซี ดังรูปที่ 3.6 รอให้ เรซินอิพอกซีแข็ง 24 ชั่วโมง จนสามารถนำออกจากแบบได้



รูปที่ 3.6 ภาคตัดขวางภายในตัวเรือน

เตรียมผิวของตัวอย่างด้วยการขัดผิวตัวอย่างให้เรียบ โดยขัดหยาบด้วยกระดาษทราย
 เบอร์ 120 240 600 1200 และ 2500 ในการเปลี่ยนเบอร์ของกระดาษทรายทุกครั้งทำการล้าง
 อนุภาคที่จับเกาะผิวหน้าตัวอย่างออกด้วยเครื่องสั่นสะเทือนคลื่นความถี่สูง

 3) ขัดละเอียดด้วยผงเพชรขนาด 3 ไมครอนและ 1 ไมครอน ตามลำดับ บนผ้าสักหลาด และล้างอนุภาคที่จับเกาะผิวหน้าตัวอย่างออกด้วยเครื่องสั่นสะเทือนคลื่นความถี่สูง

4) เช็ดผิวหน้าตัวอย่างให้แห้งและเช็ดด้วยด้วยเอทานอล

5) นำตัวอย่างไปกดเพื่อวัดความแข็งและความเหนียวด้วยหัวกดวิกเกอร์สโดยใช้แรงกด 10 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 15 วินาที

6) วัดเส้นทแยงมุมของรอยกดและความยาวของรอยแตกที่เกิดขึ้นบนผิวตัวอย่างดังรูปที่
 3.3 (b) หาค่าเฉลี่ยเส้นทแยงมุม (d̄) และความยาวรอยแตกเฉลี่ย (c̄) แล้วคำนวณหาความแข็ง
 (H_V) และความเหนียว (K_C) ของตัวอย่าง ตามสมการ (3.5)⁽⁴²⁾ และ (3.6)⁽⁴³⁾ ตามลำดับ

$$Hardness(H_V) = 1.8544 \times \left(\frac{P}{\bar{d}^2}\right)$$
(3.5)

Fracture toughness
$$(K_c) = 0.0726 \left(\frac{P}{\bar{c}^{3/2}}\right)$$
 (3.6)

3.4.4 การทดสอบความต้านทานต่อการดัดโค้ง (Flexural strength)

ความต้านทานต่อการดัดโค้งของวัสดุวัดด้วยวิธีการทดสอบแรงดัดโค้งแบบ 3 จุด ตาม ASTM : Designation C 1161-02c⁽⁴⁴⁾ โดยใช้เครื่อง Universal testing machine (5882, Instron) โดยมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างดังนี้

1) ตัดตัวอย่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง × หนา × ยาว ประมาณ 4 มิลลิเมตร × 3 มิลลิเมตร × 29 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องตัดใบตัดเพชร (Isomet 1000, บริษัท เจ็บเซ่นแอนด์เจนเซ่น)

2) ขัดชิ้นงานให้ได้ระนาบด้วยจานขัดเพชรเบอร์ 170

3) ล้างอนุภาคที่จับเกาะผิวหน้าตัวอย่างออกด้วยเครื่องสั่นสะเทือนคลื่นความถี่สูง

4) นำตัวอย่างไปทดสอบโดยมีตัวแปรในการทดสอบดังดังต่อไปนี้

ความกว้างของจุดรองรับตัวอย่าง (<i>L</i>)	= 20 มิลลิเมตร
ความเร็วในการกดดัดโค้ง	= 0.2 มิลลิเมตรต่อนาที
จำนวนตัวอย่าง	= 5 ชิ้นขึ้นไป
อุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ	= อุณหภูมิห้อง

บันทึกค่าความหนา (t) และความกว้างของชิ้นงาน (W) ตลอดจนค่าแรงกระทำ (P_f) ที่ได้ ขณะชิ้นงานแตกหักและคำนวณความต้านทานต่อการดัดโค้ง (σ_f) ดังสมการ (3.7)

Flexural strength
$$(\sigma_{\rm f}) = \frac{3P_f L}{2wt^2}$$
 (3.7)

3.4.5 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (Microstructure)

การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ใช้เทคนิคการส่องกราดของอิเล็กตรอนด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (JSM-6480LV, JEOL) ก่อนตรวจโครงสร้างจุลภาคต้องนำ ตัวอย่างที่ผ่านการขัดหยาบและขัดละเอียดออกจากตัวเรือนและกัดผิวด้วยความร้อน (thermal etching) ณ อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเผาผนึก 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 15 นาที ใน บรรยากาศอาร์กอน หลังจากนั้นนำตัวอย่างติดเข้ากับก้านวางตัวอย่างโดยใช้เทปกาวคาร์บอนหรือ เทปกาวทองแดงเป็นสารยึดติดตัวอย่างลงบนแผ่นหน้าของก้านวางตัวอย่าง หลังจากนั้นทำ การฉาบผิวของตัวอย่างด้วยทองเพื่อทำให้เกิดการนำไฟฟ้าแล้วนำเข้าเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด เพื่อทำการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค สำหรับขนาดเกรนของเนื้อพื้นสามารถหาได้ โดยวิธี lineal intercept ตาม ASTM : Designation E 112 – 96⁽⁴⁵⁾



ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 4 ผลการทดลองและการอภิปรายผล

สำหรับผลการทดลองในงานวิจัยนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งกล่าวถึง การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของผงวัตถุดิบ ส่วนที่สองครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับผลของอุณหภูมิ ต่อสมบัติของอะลูมินาและวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีและไม่มีสารเติมแต่ง และส่วนสุดท้ายกล่าวถึงผลของปริมาณของสารเติมแต่ง Mg-PSZ และ Ca-PSZ ต่อสมบัติของ วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ ดังจะกล่าวถึงรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้

4.1 ลักษณะเฉพาะของผ<mark>งวัตถุดิบ</mark>

4.1.1 การกระจาย<mark>ขนาดอนุภาค</mark>

การกระจายขนาดอนุภาคของผงวัตถุดิบแสดงดังรูปที่ 4.1 พบว่า ผงอะลูมินามีช่วง การกระจายขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 0.3 – 182 ไมครอน โดยมีช่วงของการกระจายขนาดอนุภาค ในช่วงกว้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยที่ปริมาณสะสมร้อยละ 50 (d₅₀) มีค่าเท่ากับ 3.7 ไมครอน การกระจายขนาดอนุภาคของอะลูมินาในการทดลองนี้มีขนาดใหญ่กว่าค่าที่ได้จาก บริษัทผู้ผลิตซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยร้อยละ 50 เท่ากับ 0.3 ไมครอน⁽⁴⁰⁾ อาจเนื่องมาจาก การทดลองนี้มีการเกาะตัวกันของอนุภาค (agglomerates)

ผงทั้งสเตนคาร์ไบด์มีช่วงการกระจายขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 0.6 - 104.7 ไมครอน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยที่ปริมาณสะสมร้อยละ 50 มีค่าเท่ากับ 2.0 ไมครอน และมีลักษณะ การกระจายขนาดอนุภาคในช่วงแคบ

ฝง Mg-PSZ มีช่วงการกระจายขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 0.3 - 240 ไมครอน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยที่ปริมาณสะสมร้อยละ 50 มีค่าประมาณ 2.5 ไมครอน และมีลักษณะ การกระจายขนาดอนุภาคในช่วงกว้าง

ผง Ca-PSZ มีช่วงการกระจายขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 0.3 - 30.2 ไมครอน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยที่ปริมาณสะสมร้อยละ 50 (d₅₀) มีค่าประมาณ 2.0 ไมครอน และมีลักษณะ การกระจายขนาดอนุภาคในช่วงกว้าง





4.1.2 สัณฐานวิทยา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผงอะลูมินา ทังสเตนคาร์ไบด์ Mg-PSZ และ Ca-PSZ สังเกตได้ด้วยภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดดังแสดงในรูปที่ 4.2 พบว่าผง อะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์มีรูปร่างค่อนข้างกลมและสม่ำเสมอ ผงวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดนี้มีขนาด เล็กกว่า 2 ไมครอน นอกจากนี้ยังพบว่าอะลูมินามีขนาดอนุภาคเล็กใกล้เคียงกันกับขนาดที่วัดได้ จากบริษัทผู้ผลิตและผงอะลูมินามีการเกาะตัวกันของอนุภาคซึ่งสอดคล้องกับการกระจายขนาด อนุภาคที่วัดด้วยหลักการหักเหของรังสีตกกระทบบนอนุภาคของวัสดุ (laser light scattering) ส่วนทังสเตนคาร์ไบด์มีขนาดใกล้เคียงกันกับการกระจายขนาดอนุภาคที่วัดด้วยหลักการหักเห ของรังสีตกกระทบบนอนุภาคของวัสดุ สำหรับผง Mg-PSZ และ Ca-PSZ มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ มี ขนาดอนุภาคเล็กกระจายปนอยู่กับอนุภาคขนาดใหญ่และส่วนใหญ่มีขนาดของอนุภาคเล็กกว่า 5 ไมครอน ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับการกระจายตัวของอนุภาคที่วัดได้ด้วยหลักการหักเหของรังสี ตกกระทบบนอนุภาคของวัสดุและยังพบว่าเกิดการเกาะตัวกันของอนุภาคขนาดเล็กบนอนุภาค ขนาดใหญ่



รูปที่ 4.2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผงวัตถุดิบจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (a) อะลูมินา (b) ทั้งสเตนคาร์ไบด์ (c) Mg-PSZ และ (d) Ca-PSZ

4.1.3 องค์ประกอบทางเฟส

จากการตรวจสอบองค์ประกอบทางเฟสของผงวัตถุดิบด้วยเครื่อง XRD (รูปที่ 4.3) พบว่า ผงอะลูมินามีเฟสของแอลฟาอะลูมินา (**α**—Al₂O₃, JCPDS หมายเลข 01-082-1467) เพียงเฟส เดียว ซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบรอมโบฮีดรอล ผงทังสเตนคาร์ไบด์พบเฟสของทังสเตนคาร์ไบด์ (WC, JCPDS หมายเลข 03-065-4539) เพียงเฟสเดียวและมีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนัล ส่วนผง Mg-PSZ มี 3 เฟส คือ เซอร์โคเนียในรูปผลึกแบบลูกบาศก์ (c-ZrO₂, JCPDS หมายเลข 00-007-0337) เททระโกนัล (t-ZrO₂, JCPDS หมายเลข 01-080-2155) และมอโนคลินิก (m-ZrO₂, JCPDS หมายเลข 01-089-9066) โดยมีพีคของเททระโกนัลซ้อนทับกันกับพีคของลูกบาศก์เซอร์โคเนีย สำหรับผง Ca-PSZ มีเฟสของเททระโกนัลเซอร์โคเนีย (t-ZrO₂, JCPDS หมายเลข 01-080-2155) เพียงเฟสเดียว (รายละเอียดของเฟสแต่ละชนิดแสดงในภาคผนวก ข)





4.2 ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติของอะลูมินาและวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่มีและไม่มีสารเติมแต่ง

ในหัวข้อนี้ได้เปรียบเทียบอะลูมินา วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์และ วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งในปริมาณร้อยละ 6 โดย น้ำหนัก ณ อุณหภูมิเผาผนึก 1400 1500 และ 1600 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เนื่องจากสารเติมแต่ง Ca-PSZ ในปริมาณร้อยละ 6 โดยน้ำหนักมีความเหนียวและความต้านทานต่อการดัดโค้งสูงเมื่อ เปรียบเทียบกับสารเติมแต่ง Mg-PSZ ในปริมาณที่เท่ากันซึ่งจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ 4.3

4.2.1 ความหนาแน่น

ความหนาแน่นของอะลูมินา วัสดุเซิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่ไม่มีและมี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่ง พบว่าความหนาแน่นของวัสดุทั้ง 3 ชนิดเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิเผาผนึกดัง แสดงในรูปที่ 4.4 การทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้ผงอะลูมินาขนาดละเอียดทำให้ได้อะลูมินาหลัง การเผาผนึกที่มีความหนาแน่นสูง (ความหนาแน่นสัมพัทธ์มากกว่า 94%TD) แม้อุณหภูมิการเผา ต่ำกว่า 1600 องศาเซลเซียส นอกจากนั้นยังพบว่าอุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่สูง เพียงพอในการทำให้อะลูมินามีความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงถึง 99.2 %TD ซึ่งมีความหนาแน่น ใกล้เคียงกันกับการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน ณ อุณหภูมิ 1450 องศาเซลเซียส และ 1550 องศาเซลเซียส^(6,8) ส่วนการเผาผนึกที่อุณหภูมิสูงกว่า 1600 องศาเซลเซียส นายเปาว์ ณ นคร และ คณะ⁽³⁸⁾ พบว่าเกิดการ over firing ซึ่งส่งผลให้อะลูมินามีความหนาแน่นลดลง ดังนั้นอุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส จึงเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเผาผนึกอะลูมินาเกรด AKP30

เมื่อสังเกตกราฟความหนาแน่นสัมพัทธ์ของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ พบว่ามีความหนาแน่นลดลงเมื่อเทียบกับอะลูมินาเนื่องจากอนุภาคของทังสเตนคาร์ไบด์ไปยับยั้ง การโตของเกรนและทำให้การแพร่ของมวลข้ามขอบเกรนลดลง⁽⁷⁾ การเผาวัสดุเชิงประกอบชนิดนี้ให้ มีความหนาแน่นสูงจึงต้องใช้อุณหภูมิสูงขึ้น ส่วนการเติมแต่งวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ด้วย Ca-PSZ ทำให้ความหนาแน่นลดลงเช่นเดียวกันและพบว่าที่อุณหภูมิต่ำกว่า 1600 องศาเซลเซียส วัสดุเชิงประกอบทั้ง 2 ชนิดมีความหนาแน่นต่ำมาก โดยปกติแล้วการเผา ผนึกแบบปราศจากแรงดันของวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นเชรามิกต้องการอุณหภูมิในการเผาผนึกที่ สูงกว่าวัสดุเซรามิกเนื้อเดียวหรือมีเฟสของเหลวในการเผาผนึก เนื่องจากการยับยังการโตของเกรน (pinning effect) ของอนุภาคละเอียดที่กระจายอยู่ทำการขัดขวางการเคลื่อนที่ของขอบเกรนและ การแพร่ของมวล จึงทำให้กระบวนการเพิ่มความหนาแน่นของวัสดุเซิงประกอบเกิดความล่าช้าและ ทำให้ความแข็งลดลง⁽⁴⁶⁾ อย่างไรก็ตาม ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส พบว่าความหนาแน่น สัมพัทธ์ของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์มีค่าเท่ากับ 99 %TD ซึ่งนับว่าใกล้เคียง กับอะลูมินา ส่วนวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งมีค่า ความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ 98.2 %TD ซึ่งนับว่าความหนาแน่นยังคงสูง



รูปที่ 4.4 ความหนาแน่นสัมพัทธ์หลังเผา ณ อุณหภูมิต่างๆของอะลูมินา วัสดุเชิงประกอบ อะลูมินาทังสเตนคาร์ไบด์และวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก

4.2.2 องค์ประกอบท<mark>างเฟ</mark>ส

การเผาผนึก ณ อุณหภูมิ 1400 – 1600 องศาเซลเซียส พบว่าองค์ประกอบทางเฟสของ อะลูมินาหลังการเผาทั้ง 3 อุณหภูมิมีเพียงเฟสของแอลฟาอะลูมินา (JCPDS หมายเลข 01-081-2267) ดังรูปที่ 4.5 ซึ่งเป็นเฟสชนิดเดียวกันกับผงวัตถุดิบแสดงให้เห็นว่าอะลูมินามีความเสถียร ทางเคมีทุกอุณหภูมิ

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.5 องค์ประกอบทางเฟสของอะลูม<mark>ินา ณ อุณหภูมิเผาผ</mark>นึก 1400 1500 และ 1600 องศาเซลเซียส

สำหรับการเผาผนึกวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ ณ อุณหภูมิ 1400 และ 1500 องศาเซลเซียส พบเฟสของแอลฟาอะลูมินาและทั้งสเตนคาร์ไบด์ (WC, JCPDS หมายเลข 03-065-4539) เพียง 2 เฟส (รูปที่ 4.6) ซึ่งเป็นเฟสเดียวกันกับผงวัตถุดิบและผงแกรนูลก่อนเผา แสดงให้เห็นว่าอะลูมินาและทั้งสเตนคาร์ไบด์มีความเสถียรทางเคมีและไม่ทำปฏิกิริยาซึ่งกันและ กัน ณ อุณหภูมิต่ำกว่า 1600 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิการเผาผนึกที่ 1600 องศาเซลเซียสพบ เฟสของแอลฟาอะลูมินา ทั้งสเตนคาร์ไบด์และไดทั้งสเตนคาร์ไบด์ (W₂C, JCPDS หมายเลข 03-065-3896) พร้อมทั้งเดลตาทังสเตนบอไรด์ (δ-WB, JCPDS หมายเลข 00-006-0635) และ แกมมาไดทั้งสเตนบอไรด์ (γ-W₂B, JCPDS หมายเลข 01-073-1767) เฟสของไดทังสเตนคาร์ไบด์ เดลตาทังสเตนบอไรด์ (α, w₂B, JCPDS หมายเลข 01-073-1767) เฟสของไดทังสเตนคาร์ไบด์ เดลตาทังสเตนบอไรด์และแกมมาไดทังสเตนบอไรด์นี้เป็นเฟสที่เกิดขึ้นหลังการเผา ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าการเผาผนึกทั้งสเตนคาร์ไบด์ในการทดลองนี้สามารถเกิด non-stoichiometric ได้แม้ทำการเผา ในบรรยากาศอาร์กอน ส่วนการเคลือบแผ่นรองแกรไฟต์ด้วยโบรอนไนไตรด์เพื่อป้องกันการทำ ปฏิกิริยาระหว่างแผ่นรองแกรไฟต์กับชิ้นงานที่อุณหภูมิสูงกลับทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่าง ทั้งสเตนคาร์ไบด์ในชิ้นงานกับโบรอนไนไตรด์ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป



รูปที่ 4.6 องค์ประกอบทางเฟสของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ ณ อุณหภูมิ เผาผนึก 1400 1500 และ 1600 องศาเซลเซียส

จากเฟลไดอะแกรมของทั่งสเตน – คาร์บอน (รูปที่ 4.7) ณ อุณหภูมิประมาณ 1600 องศาเซลเซียล เมื่ออัตราส่วนของทั่งสเตนและคาร์บอนเท่ากันจะอยู่ในระบบสมดุลหรือเกิด ทังสเตนคาร์ไบด์และมีช่วงของการเกิดสมดุลค่อนข้างแคบ อย่างไรก็ตามอัตราส่วนของคาร์บอน ต่อทังสเตนเท่ากับ 1 : 2 โดยอะตอมสามารถเกิดไดทังสเตนคาร์ไบด์ในบรรยากาศอาร์กอนได้ พร้อมๆ กันกับทังสเตนคาร์ไบด์เมื่อมีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว (บริเวณด้านขวาของ เฟลไดอะแกรม) ไดทังสเตนคาร์ไบด์เมื่อมีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว (บริเวณด้านขวาของ เฟลไดอะแกรม) ไดทังสเตนคาร์ไบด์เป็นสารประกอบที่ค่อนข้างเป็น non-stoichiometric (WC, เมื่อ x อยู่ระหว่าง 0.35 และ 0.50) และเฟสของไดทังสเตนคาร์ไบด์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้สมบัติ ทางด้านความแข็งต่ำกว่าเฟสของทังสเตนคาร์ไบด์ 30 เปอร์เซ็นต์⁴⁷⁾ ส่วนมากคาร์ไบด์และไนไตรด์ ของโลหะทรานซิชันมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในชั้น d (d-group transition metals) สำหรับ คาร์ไบด์ที่เป็นโลหะทรานซิชันและมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในกลุ่ม d นั้น carbide – forming power มีแนวโน้มลดลงตามการจัดเรียงอิเล็กตรอนในกลุ่ม 4d (Ti, Zr และ Hf) ถึงกลุ่ม 6d (Cr, Mo และ W) กลุ่มที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในชั้น 4d จะเกิดเพียงมอโนคาร์ไบด์ (MC, เมื่อ M คือ โลหะทรานซิชัน) ในขณะที่เฟสของไดคาร์ไบด์ (M₂C) เริ่มปรากฏขึ้นในกลุ่มที่มีการจัดเรียง อิเล็กตรอนในชั้น 5d (V, Nb และ Ta) พร้อมกับมอโนคาร์ไบด์ จึงคาดการณ์ได้ว่าไดคาร์ไบด์มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากโลหะทรานซิชันที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในชั้น 5d ถึง 6d ดังนั้นในกลณีระบบ ของแทนทาลัม - คาร์บอน จะเกิดมอโนคาร์ไบด์ (TaC) ขณะที่กรณีของระบบทังสเตน – คาร์บอน เกิดไดทังสเตนคาร์ไบด์ ณ อุณหภูมิการเผา 1600 องศาเซลเซียส⁽⁴⁷⁾ ดังนั้นอัตราการเพิ่ม อุณหภูมิที่รวดเร็วในการทดลองนี้ ประกอบกับทังสเตนเป็นโลหะทรานซิชันที่มีการจัดเรียง อิเล็กตรอนในกลุ่ม 6d อีกทั้งช่วงของทังสเตนคาร์ไบด์ ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส ในระบบ ทังสเตน – คาร์บอน (รูปที่ 4.7) มีช่วงที่ค่อนข้างแคบ ในการทดลองนี้จึงพบเฟสของ ไดทังสเตนคาร์ไบด์ ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.7 เฟสไดอะแกรมของ W – C ในช่วงอุณหภูมิ 700 – 4700 องศาเซลเซียส⁽⁴⁷⁾

การเปลี่ยนแปลงเฟสของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียสแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนของอะลูมินาซึ่งไม่มี การเปลี่ยนแปลงเฟสหรือทำปฏิกิริยากับส่วนผสมอื่นในชิ้นงานเป็นสารประกอบใหม่เกิดขึ้นดัง แสดงในรูปที่ 4.5 ส่วนที่สองคือทังสเตนคาร์ไบด์ซึ่งมีการเปลี่ยนเฟสและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน และกันกับโบรอนไนไตรด์ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็วสามารถทำให้ ทังสเตนคาร์ไบด์เกิดการสูญเสียอะตอมของคาร์บอนได้^(17, 23, 47) และก่อให้เกิดเฟสของ ทังสเตนคาร์ไบด์และไดทังสเตนคาร์ไบด์ที่อุณหภูมิมากกว่า 1255 องศาเซลเซียส^(17,47) ดังสมการที่ (4.1) และไดทังสเตนคาร์ไบด์นี้สามารถสลายตัวเป็นทังสเตนคาร์ไบด์และทังสเตนที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 1250 องศาเซลเซียสตามสมการที่ (4.2)^(17,47)

$$3WC \to WC + W_2C + C \tag{4.1}$$

$$W_2 C \to W C + W \tag{4.2}$$

ส่วนการเพิ่มอุณหภูมิอย่างช้าๆ นั้นทำให้เกิดทังสเตนคาร์ไบด์ร่วมกับคาร์บอนอิสระ จำนวนเล็กน้อย^(17, 47) ดังด้านซ้ายของเฟสไดอะแกรม F. Oliveira และคณะ⁽⁴⁷⁾ พบว่าผิวด้านบน ของชิ้นงานมีเฟสของทังสเตนคาร์ไบด์พร้อมกับไดทังสเตนคาร์ไบด์เนื่องจากอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ อย่างรวดเร็ว ส่วนด้านล่างของชิ้นงานมีเพียงเฟสของทังสเตนคาร์ไบด์ซึ่งอาจมีอัตราการเพิ่ม อุณหภูมิช้ากว่าด้านบนของชิ้นงาน

สำหรับการทดลองนี้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิอยู่ที่ 15 องศาเซลเซียส/นาที ซึ่งก่อให้เกิดเฟส ของไดทังสเตนคาร์ไบด์ขึ้นและสอดคล้องกับการเผาผนึกวัสดุเชิงประกอบเซอร์โคเนีย (7 mol.% CaO-ZrO₂)/ทังสเตนคาร์ไบด์ของ N. Moskala และ W. Pyda⁽⁴⁸⁾ ซึ่งเตรียมชิ้นงานด้วย การเผาผนึกแบบปราศจากแรงดันโดยใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิเท่ากับ 15 องศาเซลเซียส/นาที และมีอัตราการเย็นตัวอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส/นาที ดังนั้นการทดลองนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าปฏิกิริยา ที่เกิดขึ้นเกิดค่อนไปทางด้านขวาของเฟสไดอะแกรม การเกิดปฏิกิริยาของทังสเตนคาร์ไบด์จึงเกิด จากสมการที่ (4.1)

สำหรับการเกิดเฟสของทั้งสเตนบอไรด์และไดทั้งสเตนบอไรด์สามารถเกิดจากปฏิกิริยา ของโบรอนไนไตรด์กับทั้งสเตนคาร์ไบด์หรือไดทั้งสเตนคาร์ไบด์ เนื่องจากอุณหภูมินี้มีเฟสของ ไดทั้งสเตนคาร์ไบด์เกิดขึ้นซึ่งต่างจากอุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส และ 1500 องศาเซลเซียส จึง สันนิษฐานได้ว่าเฟสของไดทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของทั้งสเตนคาร์ไบด์ได้เข้า ไปทำปฏิกิริยากับโบรอนไนไตรด์บางส่วน ดังสมการที่ (4.3)

$$3W_2C + 4BN \rightarrow 2WB + 2W_2B + 3C + 2N_2(g)$$
 (4.3)

เมื่อพิจารณาปฏิกิริยาทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงานที่ประกอบด้วยอะลูมินาและ ทังสเตนคาร์ไบด์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระบบ จะได้ว่า

$$Al_2O_3 + 12WC + 4BN \rightarrow Al_2O_3 + 4WC + W_2C + 2WB + 2W_2B + 7C + 2N_2(g)$$
(4.4)

เมื่อทำการเผาผงแกรนูลอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส จึง เกิดเฟสของอะลูมินา ทั้งสเตนคาร์ไบด์ ไดทั้งสเตนคาร์ไบด์ ทั้งสเตนบอไรด์และไดทั้งสเตนบอไรด์ ส่วนคาร์บอนไม่พบในการทดลองนี้อาจเกิดจากมีปริมาณของคาร์บอนที่เกิดขึ้นมีน้อยหรือคาร์บอน นี้อาจอยู่ในสถานะแก๊ส

สำหรับการเติม Ca-PSZ ร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก ในวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ พบว่าการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียสพบเฟสของแอลฟาอะลูมินา ทังสเตนคาร์ไบด์ มอโนคลินิกเซอร์โคเนีย (m-ZrO₂) เททระโกนัลเซอร์โคเนีย (t-ZrO₂) และ ZrO ดัง รูปที่ 4.8 ซึ่งเฟสของมอโนคลินิกนี้เกิดขึ้นหลังจากการเผาอาจเนื่องมาจากเฟสของเททระโกนัลเป็น เฟสที่ไม่เสถียรเมื่อเกิดการเย็นตัวหลังจากการเผาทำให้เททระโกนัลบางส่วนเปลี่ยนเฟสเป็น มอโนคลินิกที่มีความเสถียรมากกว่า ส่วนการเผาผนึกที่อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้พีคของเซอร์โคเนีย ทั้งเททระโกนัลเซอร์โคเนียและมอโนคลินิกลดลง พีคของ ZrO กลับสูงขึ้นแสดงว่าเซอร์โคเนียมี การเปลี่ยนเฟสไปเป็น ZrO ที่อุณหภูมิสูง โดยสันนิษฐานว่ามอโนคลินิกเซอร์โคเนียเกิดการเปลี่ยน เฟสเป็น ZrO เนื่องจาก ZrO เกิดจากการสูญเสียออกซิเจนของเซอร์โคเนียจึงทำให้ปริมาตรของ ZrO (98.98 ลูกบาศก์อังสตรอม, ตารางที่ ข - 10) ลดลงจากมอโนคลินิกเซอร์โคเนีย (139.49-140.52 ลูกบาศก์อังสตรอม, ตารางที่ ข - 11 และ ตารางที่ ข - 12) ส่วนเททระโกนัลเซอร์โคเนียไม่ สามารถเปลี่ยนเป็น ZrO ได้เนื่องจากเททระโกนัลเซอร์โคเนียมีปริมาตร (66.72-67.04 ลูกบาศก์ อังสตรอม, ตารางที่ ข - 13 และ ตารางที่ ข - 14) ซึ่งน้อยกว่า ZrO นอกจากนี้ยังพบว่าแกมมา ใดทังสเตนบอไรด์เริ่มปรากฏเด่นชัด ณ อุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียส ส่วนเฟสของทังสเตน (W) และโบรอนไนไตรด์ (BN) เริ่มปรากฏเด่นชัด ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส เฟสของ ไดทังสเตนคาร์ไบด์เริ่มปรากฏเช่นเดียวกันกับวัสดูเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์



รูปที่ 4.8 องค์ประกอบทางเฟสของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็น สารเติมแต่งร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก ณ อุณหภูมิเผาผนึก 1400 1500 และ 1600 องศาเซลเซียส

การเกิดเฟสต่างๆ ของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็น สารเติมแต่ง ณ อุณหภูมิต่างๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้

(ก) <u>ณ อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส</u>

อะลูมินามีความเสถียรทางเคมีจึงไม่ทำปฏิกิริยากับสารชนิดอื่นทุกอุณหภูมิเพราะฉะนั้น สารที่ได้จึงยังคงเป็นอะลูมินา ส่วนทังสเตนคาร์ไบด์ไม่เกิดการสลายตัวเป็นไดทังสเตนคาร์ไบด์ เช่นกันกับวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์และพบว่าไม่มีการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง โบรอนไนไตรด์กับชิ้นงานจึงไม่พบเฟสของทังสเตนบอไรด์และไดทังสเตนบอไรด์ ส่วนการเกิด ZrO สันนิษฐานว่าเกิดจากทังสเตนคาร์ไบด์บางส่วนมีการทำปฏิกิริยากับเซอร์โคเนียบางส่วนเกิดเป็น ZrO และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และยังคงเหลือเฟสของทังสเตนคาร์ไบด์และเซอร์โคเนีย บางส่วนอยู่ในชิ้นงาน

การเกิด ZrO เป็นการเกิด oxygen nonstoichiometry ของเซอร์โคเนีย (ZrO_{2-x}) ซึ่งเกิด จากการเผาที่ความดันออกซิเจนต่ำๆ⁽⁴⁸⁾ และออกซิเจนที่หายไปจะไปทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเกิด เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งคาร์บอนนี้อาจเกิดจากแผ่นรองแกรไฟต์ บรรยากาศในเตาเผาหรือ การสลายตัวของทังสเตนคาร์ไบด์เป็นไดทังสเตนคาร์ไบด์⁽⁴⁸⁾ เมื่อพิจารณาทั้ง 3 กรณีน่าจะตัด 2 กรณีแรกออกได้เนื่องจากชิ้นงานไม่ได้สัมผัสกับแผ่นรองแกรไฟต์โดยตรงเพราะมีการเคลือบ โบรอนในไตรด์บนแผ่นรองแกรไฟต์ก่อนวางชิ้นงาน ดังนั้นกระบวนการเกิด ZrO จึงเกิดจาก ปฏิกิริยาระหว่างเซอร์โคเนียกับคาร์บอนที่แพร่มาจากทั้งสเตนคาร์ไบด์หรือไดทังสเตนคาร์ไบด์ โดยตรง ในการทดลองนี้เราสามารถนำสมการที่ (4.5) และ สมการที่ (4.6) ซึ่งเป็นสมการการเกิด oxygen nonstoichiometry ของเซอร์โคเนีย ในงานวิจัยของ N. Moskala และ W. Pyda⁽⁴⁸⁾ มา ประยุกต์ใช้ในการทดลองของเราได้ดังสมการที่ (4.7)

$$ZrO_{2-x} + 2yWC \rightarrow yW_2C + ZrO_{2-x-y} + yCO(g)$$

$$\tag{4.5}$$

$$ZrO_{2-x} + yW_2C \rightarrow 2yW + ZrO_{2-x-y} + yCO(g)$$

$$\tag{4.6}$$

ณ อุณหภูมินี้ทั้งสเตนคาร์ไบด์ไม่เกิดการสลายตัวเป็นเฟสไดทั้งสเตนคาร์ไบด์ ดังนั้น สารตั้งต้นในการเกิดปฏิกิริยาจึงเป็นทั้งสเตนคาร์ไบด์ ในกรณีนี้จึงเกิด ZrO คล้ายกันกับสมการที่ (4.5) ปฏิกิริยาระหว่างทั้งสเตนคาร์ไบด์และเซอร์โคเนียจึงเป็นดังสมการที่ (4.7)

ส่วนที่ทำปฏิกิริยา :
$$2WC + ZrO_2 \rightarrow W_2C + ZrO + CO(g)$$
 (4.7)

ส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาระหว่างกัน :
$$WC + ZrO_2 \rightarrow WC + ZrO_2$$
 (4.8)

ปฏิกิริยารวม ณ อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียสเป็นไปตามสมการ (4.9) $Al_2O_3 + 3WC + 2ZrO_2 \rightarrow Al_2O_3 + WC + W_2C + ZrO_2 + ZrO + CO(g)$ (4.9) ดังนั้นที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส จึงพบเฟสของอะลูมินา ทังสเตนคาร์ไบด์ เซอร์โคเนียและ ZrO ส่วนไดทังสเตนคาร์ไบด์ที่เกิดขึ้นอาจมีปริมาณน้อยมากจึงไม่สามารถตรวจ พบในการทดลองนี้

(ข) <u>ณ อุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียส</u>

อะลูมินาคงความเสถียรทางเคมีเช่นเดิม แต่ทั้งสเตนคาร์ไบด์บางส่วนมีการทำปฏิกิริยากับ เซอร์โคเนียบางส่วน ดังสมการที่ (4.10)

$$3WC + 2ZrO_2 \rightarrow WC + W_2C + ZrO_2 + ZrO + CO(g)$$
 (4.10)

และไดทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่เกิดขึ้นในสมการที่ (4.10) สามารถทำปฏิกิริยากับโบรอนไนไตรด์ ได้อย่างสมบูรณ์ ดังสมการที่ (4.11)

$$2W_2C + 2BN \to 2W_2B + 2C + N_2(g) \tag{4.11}$$

ปฏิกิริยารวม ณ อุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียส จึงเป็นไปตามสมการที่ (4.12) $Al_2O_3 + 6WC + 4ZrO_2 + 2BN \rightarrow Al_2O_3 + 2WC + 2ZrO_2 + 2ZrO + 2W_2B + 2C + 2CO(g) + N_2(g)$ (4.12)

ดังนั้นที่อุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียส จึงพบเฟสของอะลูมินา ทังสเตนคาร์ไบด์ เซอร์โคเนีย ZrO และไดทังสเตนบอไรด์ ส่วนคาร์บอนที่เกิดขึ้นอาจมีปริมาณน้อย และจาก การทดลองพบว่าพีคของ ZrO มีพีคที่สูงมาก ส่วนพีคของมอโนคลินิกเซอร์โคเนียลงจนแทบมองไม่ เห็นเมื่อเทียบกับอุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส จึงเป็นการยืนยันว่ามอโนคลินิกเซอร์โคเนียมี การเปลี่ยนเป็น ZrO โดยทำปฏิกิริยากับทังสเตนคาร์ไบด์และเกิดไดทังสเตนคาร์ไบด์ขึ้น ส่วน ไดทังสเตนคาร์ไบด์ที่เกิดขึ้นนี้ทำปฏิกิริยากับโบรอนไนไตร์ดจนหมดและเกิดเฟสของ ไดทังสเตนคาร์ไบด์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

(ค) <u>ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส</u>

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ว่าเกิดการสูญเสีย คาร์บอนในทังสเตนคาร์ไบด์ และไดทังสเตนคาร์ไบด์บางส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นโลหะทังสเตนได้ เนื่องจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ณ อุณหภูมิต่ำกว่า 1255 องศาเซลเซียส ดังสมการที่ (4.2) ซึ่ง เกิดขึ้นได้เพียงบางส่วนและเหลือเฟสของไดทังสเตนคาร์ไบด์ ปฏิกิริยาของทังสเตนคาร์ไบด์ ณ อุณหภูมินี้จึงเป็นดังสมการที่ (4.13) ณ อุณหภูมินี้ทังสเตนคาร์ไบด์บางส่วนมีการทำปฏิกิริยากับ เซอร์โคเนียบางส่วนดังสมการที่ (4.10) และไดทังสเตนคาร์ไบด์ที่เกิดขึ้นในสมการที่ (4.10) สามารถทำปฏิกิริยากับโบรอนไนไตรด์ได้บางส่วน ดังสมการที่ (4.14) ปฏิกิริยารวมของทั้งสเตนคาร์ไบด์

$$6WC \rightarrow 3WC + W_2C + W + 2C \tag{4.13}$$

ปฏิกิริยาระหว่างไดทั้งสเตนคาร์ไบด์และโบรอนไนไตรด์

$$3W_2C + 3BN \rightarrow W_2C + BN + 2W_2B + 2C + N_2(g)$$
 (4.14)

ปฏิกิริยารวม ณ อุณหภูมินี้จึงเป็นดังสมการที่ (4.15) $Al_2O_3 + 15WC + 6ZrO_2 + 3BN \rightarrow Al_2O_3 + 6WC + 2W_2C + W + BN + 2W_2B + 3ZrO_2 + 3ZrO_2 + 3ZrO + 4C + 3CO(g) + N_2(g)$ (4.15)

ดังนั้นที่อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส จึงพบเฟสของอะลูมินา ทังสเตนคาร์ไบด์ ไดทังสเตนคาร์ไบด์ ทังสเตน โบรอนไนไตรด์ ไดทังสเตนบอไรด์ เซอร์โคเนียและ ZrO ส่วนคาร์บอน ที่เกิดขึ้นไม่สามารถวัดได้ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ แต่ในการทดลองนี้พบคาร์บอน ด้วยเทคนิค EDS เมื่อสังเกตผลการทดลองดังรูปที่ 4.8 พบว่าพีคของทังสเตนคาร์ไบด์ลดลงอย่าง เห็นได้ชัด ซึ่งเกิดจาก 2 สาเหตุหลักๆ คือ

(1) เกิดสลายตัวของทั้งสเตนคาร์ไบด์ไปเป็นไดทั้งสเตนคาร์ไบด์มากขึ้นดังจะเห็นได้ว่าพีค ของไดทั้งสเตนคาร์ไบด์ปรากฏชัดเจนและมีพีคสูง ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส ซึ่ง ไดทั้งสเตนคาร์ไบด์นี้บางส่วนไปทำปฏิกิริยากับโบรอนไนไตรด์เกิดไดโบรอนไนไตรด์ดังปรากฏใน ผลการทดลอง แต่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้เกิดไม่หมดจึงเหลือพีคของโบรอนไนไตรด์อยู่ด้วยและ ไดทั้งสเตนคาร์ไบด์ส่วนหนึ่งเกิดโลหะทั้งสเตนขณะเย็นตัวอย่างรวดเร็วจึงปรากฏพีคของโลหะ ทั้งสเตนขึ้น

(2) ทั้งสเตนคาร์ไบด์บางส่วนทำปฏิกิกิริยากับมอโนคลินิกเซอร์โคเนีย เกิดเป็น ไดทั้งสเตนคาร์ไบด์ ZrO และคาร์บอนมอนออกไซด์ขึ้น ทำให้เฟสของไดทั้งสเตนคาร์ไบด์เพิ่มขึ้น

การเติม Ca-PSZ ในวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์พบว่าเกิดแก๊ส คาร์บอนมอนออกไซด์ขึ้นทุกอุณหภูมิ ซึ่งการเผาด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิสูงทำให้ คาร์บอนมอนออกไซด์ยังคงเหลืออยู่ในชิ้นงานซึ่งกลายเป็นรูพรุนและส่งผลให้ความหนาแน่นลดลง การเกิดรูพรุนมากขึ้นอาจส่งผลให้ความเหนียวเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากรูพรุนทำการยับยั้งการเคลื่อนที่ ของรอยแตก^(7, 49) และการเกิด ZrO นี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเกิดการเปลี่ยนเฟสลดลงเมื่อ อุณหภูมิสูงขึ้น

4.2.3 โครงสร้างจุลภาค

รูปที่ 4.9 4.10 และ 4.11 แสดงโครงสร้างจุลภาคของอะลูมินา วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์และวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่ง ร้อยละ 6 โดยน้ำหนักตามลำดับ พบว่าการเผาผนึก ณ อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส เกิด การเผาผนึกไม่สมบูรณ์สังเกตได้จากโครงสร้างจุลภาค (รูปที่ 4.9 (a) 4.10 (a) และ 4.11 (a)) ที่มี รูพรุนจำนวนมากและไม่สามารถเห็นของเกรนได้ชัดเจนสอดคล้องกับค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่ ค่อนข้างต่ำเพียง 75 %TD แต่เมื่ออุณหภูมิในการเผาผนึกสูงขึ้นทำให้ขนาดเกรนใหญ่ขึ้นและ จำนวนรูพรุนลดลง นอกจากนี้ยังสามารถเห็นขอบเกรนชัดมากขึ้น สำหรับโครงสร้างจุลภาคของ อะลูมินาพบว่ามีการโตของเกรนอย่างรวดเร็ว ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส (รูปที่ 4.9 (c)) ทำ ให้โครงสร้างจุลภาคของอะลูมินามีขนาดเกรนค่อนข้างใหญ่และมีเกรนขนาดเล็กปะปนอยู่กับเกรน ขนาดใหญ่

โครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ด้วยกันและองค์ประกอบทางเคมีของทั้งสองบริเวณนี้สามารถยืนยันได้ด้วยเทคนิค EDS ดังรูปที่ 4.10 (d)-(f) ส่วนที่เป็นพื้นสีดำ (spectrum 1) ประกอบด้วยอาตุอะลูมิเนียมและออกซิเจนซึ่งเป็น สารประกอบอะลูมินาและส่วนที่เป็นจุดสีขาว (spectrum 2) ประกอบด้วยอะลูมิเนียม ออกซิเจน ทังสเตนและคาร์บอนซึ่งอาจรวมกันเป็นอะลูมินา ทังสเตนคาร์ไบด์ ไดทังสเตนคาร์ไบด์หรือ ทังสเตน อนุภาคสีขาวนี้กระจายอย่างสุ่มในเนื้อพื้นอะลูมินาค่อนข้างสม่ำเสมอและมักกระจายอยู่ ที่ขอบเกรนและบางทีกระจายอย่างสุ่มในเนื้อพื้นอะลูมินาค่อนข้างสม่ำเสมอและมักกระจายอยู่ ข่อบเกรนและบางทีกระจายอยู่ที่จุดที่เกรนมาบรรจบกัน นอกจากนี้ยังมีอนุภาคบางส่วนกระจาย อยู่ในเนื้อพื้นอะลูมินา ในการทดลองนี้อนุภาคของทังสเตนคาร์ไบด์ทำการขัดขวางการแพร่ของ มวลและยับยั้งการโตของเกรนของเนื้อพื้นอะลูมินาส่งผลให้ขนาดเกรนของวัสดุเชิงประกอบชนิดนี้ (รูปที่ 4.10 (c)) มีขนาดลดลงเมื่อเทียบกับอะลูมินา (รูปที่ 4.9 (c)) ณ อุณหภูมิเดียวกันและสังเกต ได้ว่าวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์มีปริมาณรูพรุนมากกว่าอะลูมินาซึ่งสอดคล้องกับ การลดลงของความหนาแน่นในหัวข้อ 4.2.1

สำหรับการเติมแต่งวัสดุเซิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ด้วย Ca-PSZ ทำให้ขนาด เกรนมีขนาดเพิ่มขึ้น (รูปที่ 4.11) อาจเนื่องมาจากอนุภาคของเซอร์โคเนียมีความแข็งน้อยกว่า อนุภาคทั้งสเตนคาร์ไบด์ อนุภาคที่มีความแข็งมากสามารถขัดขวางการแพร่ของมวลและยับยั้ง การโตของเกรนได้ดีกว่าอนุภาคที่มีความแข็งน้อยกว่า การลดปริมาณทั้งสเตนคาร์ไบด์และเพิ่ม ปริมาณของเซอร์โคเนียจึงมีผลทำให้ขนาดเกรนมีขนาดใหญ่กว่าวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทั้งสเตนคาร์ไบด์ แต่อย่างไรก็ตามขนาดเกรนนี้ก็ยังมีขนาดเล็กกว่าอะลูมินาดังแสดงในตารางที่ 4.1 สำหรับองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็น สารเติมแต่งด้วยเทคนิค EDS พบว่ามีคาร์บอนกระจายอยู่ในบนผิวเนื้อพื้นอะลูมินาและอนุภาค เซอร์โคเนียดังรูปที่ 4.11 (e) และรูปที่ 4.11 (f) ซึ่งสอดคล้องกับการคำนวณสมการเคมีดังสมการ ที่(4.16) ซึ่งคาดว่ามีคาร์บอนเกิดขึ้นจากการสลายตัวของทังสเตนคาร์ไบด์และการทำปฏิกิริยา ระหว่างไดทังสเตนคาร์ไบด์กับโบรอนไนไตรด์ ส่วนจุดสีขาวขนาดใหญ่เป็นอนุภาคของเซอร์โคเนีย หรือ ZrO

ในการเผาผนึกแบบปราศจากแรงดันความหนาแน่นของเซรามิกเพิ่มขึ้นได้ด้วยการหดตัว ของรูพรุนเปิดและเกิดการแพร่ของขอบเกรน ขณะที่รูพรุนเปิดกระจายอยู่ในโครงสร้างสามารถ ขัดขวางการเคลื่อนที่ของขอบเกรนและลดประสิทธิภาพการโตของเกรนได้เช่นเดียวกันกับกรณีของ การมีอนุภาคกระจายอยู่ในเนื้อพื้น⁽⁵⁰⁾ รูพรุนจึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการยับยั้งการโตของเกรนใน โครงสร้างจุลภาคนี้ สำหรับการทดลองนี้ไม่พบธาตุโบรอนด้วยเทคนิค EDS จึงยากที่จะกล่าวได้ว่า สมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีและไม่มี Ca-PSZ เป็นสารเติม แต่งมีความสัมพันธ์กับเฟสของโบรอนไนไตรด์ ทังสเตนบอไรด์และไดทังสเตนบอไรด์อย่างไร

ตารางที่ 4.1 ขนาดเกรนของเนื้อพื้นอะลูมินา วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์และ วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่ง ณ อุณหภุมิ ต่างๆ

Temperature (°C)	Average grain size (µm)		
Materials	1400 °C	1500 °C	1600 °C
Al ₂ O ₃	1 Allerson	1.60 ± 0.28	3.64 ± 0.71
Al ₂ O ₃ /WC	-	0.91 ± 0.13	1.41 ± 0.24
Al ₂ O ₃ /WC + 6 wt% Ca-PSZ	-	1.10 ± 0.15	2.88 ± 0.75

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย







รูปที่ 4.9 โครงสร้างจุลภาคของอะลูมินา ณ อุณหภูมิเผาผนึก (a) 1400 (b) 1500 และ (c) 1600 องศาเซลเซียส





รูปที่ 4.10 โครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีของธาตุด้วยเทคนิค EDS ของ วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ ณ อุณหภูมิเผาผนึก (a) 1400 (b) 1500 (c) 1600 องศาเซลเซียส (d) จุดที่หาองค์ประกอบทางเคมี ณ อุณหภูมิ เผาผนึก 1600 องศาเซลเซียส (e) บริเวณเนื้อพื้นสีเทาและ (f) บริเวณอนุภาคสีขาว



ร**ูปที่ 4.11** โครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีของธาตุด้วยเทคนิค EDS ของ วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก ณ อุณหภูมิเผาผนึก (a) 1400 (b) 1500 (c) 1600 องศาเซลเซียส (d) จุดที่หาองค์ประกอบทางเคมี ณ อุณหภูมิเผาผนึก 1600 องศาเซลเซียส (e) บริเวณเนื้อพื้นสีเทา (f) บริเวณอนุภาคสีขาวขนาดใหญ่และ (g) บริเวณอนุภาค สีขาวขนาดเล็ก

4.2.4 ความแข็ง

ความแข็งสามารถวัดได้จากรอยกดบนผิวของชิ้นงาน ซึ่งลักษณะของรอยกดใน การทดลองนี้ไม่มีการเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรที่ขอบของรอบกดแต่สามารถเห็นการแตกตาม มุมของรอยกดในทุกกรณี เมื่อสังเกตขนาดของรอยกดบนพื้นผิวของชิ้นงานในรูปที่ 4.12 พบว่ารอย กดมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อมีการเสริมแรงด้วยทังสเตนคาร์ไบด์และมีสารเติมแต่ง Ca-PSZ ส่วน การเพิ่มอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้รอยกดมีขนาดเล็กลงทุกส่วนผสม



รูปที่ 4.12 รอยกดวิกเกอร์บนผิวของซิ้นงาน ณ อุณหภูมิเผาผนึกต่างๆ (a, d, g) อะลูมินา (b, e, h) วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ และ (c, f, i) วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก

ความแข็งของวัสดุเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการเผาผนึกเพิ่มขึ้นดังรูปที่ 4.13 และพบว่า ความแข็งของอะลูมินามีการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแข็งของอะลูมินามี การเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ส่วนความแข็งของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีและไม่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิใน การเผาผนึกเพิ่มขึ้น ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ19.05 กิกะพาสคัล ซึ่งสูงกว่าอะลูมินา (16.85 กิกะพาสคัล) ทั้งนี้
เนื่องจากทั้งสเตนคาร์ไบด์ซึ่งมีความแข็งกว่าอะลูมินาไปขวางการโตของเกรนของอะลูมินาทำให้ ขนาดเกรนของวัสดุชนิดนี้มีขนาดเล็กกว่าอะลูมินาจึงทำให้ความแข็งสูง^(23, 50) นอกจากนี้ ความหนาแน่นของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ยังใกล้เคียงกับอะลูมินา แม้เฟสของ ไดทั้งสเตนคาร์ไบด์จะทำให้ความแข็งลดลงไปบ้าง แต่ในงานวิจัยนี้พบเฟสของไดทั้งสเตนคาร์ไบด์ เพียงเล็กน้อยและไม่ส่งผลต่อความแข็งของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์มากนัก

สำหรับการเติม Ca-PSZ ส่งผลให้ความแข็งลดลงเนื่องจากอนุภาคของเซอร์โคเนียมี ความแข็ง (ประมาณ 12 กิกะพาสคัล⁽³⁴⁾) น้อยกว่าอะลูมินา (18 – 20 กิกะพาสคัล⁽¹⁸⁾) และ ทังสเตนคาร์ไบด์ (18 - 24 กิกะพาสคัล⁽¹⁸⁾) การลดปริมาณของอนุภาคทั้งสเตนคาร์ไบด์และใส่ อนุภาคของ Ca-PSZ เพิ่มขึ้นประกอบกับขนาดของเกรนที่ใหญ่ขึ้นรวมทั้งปริมาณรูพรุนที่มากกว่า วัสดุเซิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์จึงทำให้วัสดุชนิดนี้มีความแข็งลดลง ส่วนปริมาณของ ไดทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่เพิ่มขึ้นก็อาจส่งผลให้ความแข็งของวัสดุชนิดนี้ลดลงได้เช่นกัน

วัสดุเซิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส จาก การทดลองนี้มีความแข็งและความหนาแน่นใกล้เคียงกันกับงานวิจัยของ W. Acchar และคณะ⁽⁸⁾ ซึ่งทำการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน ณ อุณหภูมิ 1450 องศาเซลเซียส ด้วยความดัน 20 เมกะพาสคัล แต่ความเหนียวที่ได้จากการทดลองด้วยวิธีนี้ยังมีค่าน้อยกว่าการอัดขึ้นรูปด้วย ความร้อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ด้วยวิธีเผาผนึก ด้วยบรรยากาศปกติต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าวิธีการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนเพื่อให้ได้วัสดุที่มี ความหนาแน่นและความแข็งสูงเทียบเท่ากับวัสดุเชิงประกอบที่ทำการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน



ร**ูปที่ 4.13** ความแข็ง ณ อุณหภูมิต่างๆของอะลูมินา วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์และวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็น สารเติมแต่งร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก

4.2.5 ความเหนียว

ความเหนียวของอะลูมินา วัสดุเซิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็น สารเติมแต่งและไม่มีสารเติมแต่งแสดงดังรูปที่ 4.14 จะเห็นว่าความเหนียวของอะลูมินา ณ อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส มีค่าสูงที่สุดและความเหนียวลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึง 1600 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เกิดจากอุณหภูมิสูงทำให้ขนาดเกรนของอะลูมินามีขนาดใหญ่และทำให้วัสดุที่ ได้มีความเปราะมากขึ้นความเหนียวจึงลดลงที่อุณหภูมิสูง ส่วนวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์มีความเหนียวเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิเนื่องจากอุณหภูมิสูงความหนาแน่นของวัสดุ เพิ่มขึ้นอีกทั้งวัสดุเชิงประกอบนี้มีการเบี่ยงเบนของรอยแตกเกิดขึ้นเมื่อรอยแตกเจอกับอนุภาค ทังสเตนคาร์ไบด์ซึ่งมีความแซ็งสูงดังรูปที่ 4.15 (b) แต่เนื่องจากอุณหภูมิสูงความหนาแน่นของวัสดุ เพิ่มขึ้นอีกทั้งวัสดุเชิงประกอบนี้มีการเบี่ยงเบนของรอยแตกเกิดขึ้นเมื่อรอยแตกเจอกับอนุภาค ทังสเตนคาร์ไบด์ซึ่งมีความแซ็งสูงดังรูปที่ 4.15 (b) แต่เนื่องจากอนุภาคของทังสเตนคาร์ไบด์มีไม่มาก นักจึงทำให้ความเหนียวที่ได้ (3.86 เมกะพาสคัล.เมตร^{1/2}) สูงกว่าอะลูมินาที่ไม่มีตัวเสริมแรง (3.78 เมกะพาสคัล.เมตร^{1/2}) เพียงเล็กน้อยหรือมีความเหนียวแทบไม่แตกต่างกัน ส่วนการเติม สารเติมแต่ง Ca-PSZ เข้าไปในปริมาณน้อยทำให้ความเหนียวเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะโครงสร้างจุลภาคมีการเปลี่ยนรูปร่างของเกรนให้มีขนาดยาวขึ้น ซึ่งต่างจาก โครงสร้างจุลภาคของอะลูมินาและวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีลักษณะของ เกรนเกือบเท่ากันทุกด้าน (isotropic grains) เมื่อรอยแตกเคลื่อนที่ไปเจอกับขอบเกรนที่เปลี่ยน ทิศทางการวางตัวทำให้รอยแตกเกิดการเปลี่ยนทิศทางและอ่อนแรงลง จึงทำให้วัสดุเชิงประกอบ อะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งมีความเหนียวเพิ่มขึ้น สำหรับการทดลองนี้ การเพิ่มความเหนียวโดยการเปลี่ยนเฟสมีผลน้อยเนื่องจากมอโนคลินิกเซอร์โคเนียบางส่วน เปลี่ยนเป็น ZrO จึงอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยหลักในการเพิ่มความเหนียวของวัสดุชนิดนี้คือการเปลี่ยน ทิศทางของรอยแตกเนื่องจากการเปลี่ยนรูปร่างของเกรน



รูปที่ 4.14 ความเหนียว ณ อุณหภูมิต่างๆของอะลูมินา วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์และวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็น สารเติมแต่งร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก

รอยแตกจากหัวกดวิกเกอร์ของอะลูมินา วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่ไม่มี และมี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่ง มีลักษณะการแตกทั้งการแตกตามขอบเกรน (intergranular fracture mode) และการแตกแบบผ่าเกรน (transgranular fracture mode) ดังแสดงในรูปที่ 4.15 (a)-(c) นอกจากนี้ยังพบว่าการเบี่ยงเบนของรอยแตกเนื่องจากอนุภาคของทังเตนคาร์ไบด์มีเพียง เล็กน้อยดังรูปที่ 4.15 (b) อาจเนื่องมาจากขนาดของอนุภาคมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะไปขัดขวาง รอยแตกและทำให้รอยแตกเบี่ยงเบนไปจากเดิม ส่งผลให้ความเหนียวของวัสดุเชิงประกอบชนิดนี้ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนรูปร่างของเกรนที่เปลี่ยนไปของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งพบว่ามีส่วนทำให้ทิศทางของรอยแตกเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังพบว่าการเกาะตัวกันของอนุภาคเซอร์โคเนียทำให้รอยแตกสามารถเคลื่อนที่ผ่าน อนุภาคเซอร์โคเนียได้ดังรูปที่ 4.15 (c) การเกิดการเกาะตัวกันของอนุภาคเซอร์โคเนียสามารถทำ ให้เกิดอันตรกิริยาที่รอยต่อระหว่างเซอร์โคเนีย/เซอร์โคเนียและเซอร์โคเนีย/อะลูมินา⁽⁵¹⁾ ซึ่งเป็น สาเหตุให้เกิดตำหนิในโครงสร้างได้และมีผลต่อความต้านทานต่อการดัดโค้งของวัสดุ

ลักษณะรอยแตกตามขอบเกรนอาจเนื่องมาจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างขอบเกรนน้อย การแตกในลักษณะนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางของรอยแตกไปตามขอบเกรน การทำให้รอยแตก เคลื่อนที่จึงต้องใช้พลังงานมากขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มความเหนียวให้แก่วัสดุ ส่วนลักษณะรอยแตก แบบผ่าเกรนเกิดจากการที่วัสดุสองชนิดมีการขยายตัวทางความร้อนต่างกันทำให้เกิดความเค้นอัด บริเวณขอบเกรนของเนื้อพื้นขณะเย็นตัวซึ่งเป็นกลไกการเพิ่มความเหนียวและบังคับให้ การเคลื่อนที่ของรอยแตกในเนื้อพื้นไม่สามารถเกิดขึ้นตามขอบเกรน จึงเป็นสาเหตุให้ลักษณะ การแตกของวัสดุเปลี่ยนจากการแตกตามขอบเกรนเป็นการแตกแบบผ่าเกรน ซึ่งต้องการพลังงาน ในการทำให้วัสดุแตกหักเพิ่มขึ้น กลไกการแตกแบบผ่าเกรนนี้จึงทำให้วัสดุมีความเหนียวและ ความต้านทานต่อการดัดโค้งมากขึ้น^(18, 52-54)



ร**ูปที่ 4.15** ลักษณะของรอยแตกจากหัวกดวิกเกอร์บนผิวของชิ้นงาน (a) อะลูมินา (b) วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ และ (c) วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก ณ อุณหภูมิ เผาผนึก 1600 องศาเซลเซียส

4.2.6 ความต้านทานต่อการดัดโค้ง

ความต้านทานต่อการดัดโค้งของอะลูมินาที่ อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียสมีค่าค่อนข้าง สูงและสูงที่สุดที่อุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียสดังรูปที่ 4.16 เนื่องจากปริมาณรูพรุนของอะลูมินา ค่อยๆลดลงและขนาดเกรนค่อนข้างสม่ำเสมอจึงทำให้ความต้านทานต่อการดัดโค้งสูงขึ้นซึ่ง สอดคล้องกับการทดลองของนายเปาว์ ณ นคร และคณะ⁽⁴⁰⁾ แต่ที่อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส ความต้านทานต่อการดัดโค้งของอะลูมินาลดลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้เนื่องจากชิ้นงานส่วนใหญ่มีเกิด รอยแยกตัวในชิ้นงาน (lamination) ซึ่งเป็นตำหนิอย่างหนึ่งในวัสดุ อีกทั้งการโตของเกรนก็มีส่วนใน การลดความทนต่อการดัดโค้งของอะลูมินาได้เช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการเกิด รอยแยกตัวในชิ้นงานกับปริมาณรูพรุนของตัวอย่าง พบว่าการเกิดรอยแยกตัวของชิ้นงานส่งผลให้ ความต้านทานต่อการดัดโค้งลดลงมากกว่ารูพรุน ดังนั้นอะลูมินาที่อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส จึงมีความต้านทานต่อการดัดโค้งต่ากว่าอะลูมินาที่อุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียสแม้ว่าที่ 1500 องศาเซลเซียส จะมีปริมาณรูพรุนมากกว่าก็ตาม (ซึ่งมีปริมาณรูพรุนมากกว่าเพียงเล็กน้อย)

วัสดุเซิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด้ไม่มีและมีการเติม Ca-PSZ มีความต้านทาน ต่อการดัดโค้งเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องจากปริมาณรูพรุนของวัสดุน้อยลงที่อุณหภูมิ สูงขึ้น ประกอบกับชิ้นงานส่วนใหญ่ไม่เกิดรอยแยกตัวในชิ้นงานเหมือนกรณีของอะลูมินา ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส วัสดุเชิงประกอบที่ไม่มีสารเติมแต่งจึงมีความต้านทานต่อการดัด โค้งมากกว่าวัสดุที่ใส่สารเติมแต่ง เนื่องจากการไม่ใส่สารเติมแต่งทำให้วัสดุมีความหนาแน่นสูงซึ่ง เป็นการลดตำหนิในชิ้นงานอีกทั้งขนาดเกรนของเนื้อพื้นมีขนาดเล็กทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง เนื้อพื้นดีขึ้น⁽⁶⁾ ส่วนการใส่สารเติมแต่งแม้จะมีความเหนียวสูงก็ตาม ความหนาแน่นที่ลดลงพร้อม ทั้งขนาดเกรนที่ใหญ่ขึ้นอาจทำให้ความต้านทานต่อการดัดโค้งลดลงได้





ลักษณะรอยแตกจากการทดสอบความต้านทานต่อการดัดโค้งของวัสดุชนิดต่างๆ ที่ทำ การเผาผนึก ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส สามารถสังเกตได้จากภาพ SEM ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อะลูมินาและวัสดุเซิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ (รูปที่ 4.17 (a) และ 4.17 (b)) มีลักษณะ การแตกหักทั้งแบบตามขอบเกรนและแบบผ่าเกรน ซึ่งการแตกหักของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ในการทดลองนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ L. Wang และคณะ⁽⁵⁾ ส่วนการเติม Ca-PSZ ไม่สามารถสังเกตเห็นได้แน่ชัด ลักษณะการแตกแบบผ่าเกรนและการแตกแบบตามขอบเกรน นี้มีการใช้ปริมาณของพลังงานแตกต่างกัน โดยการแตกตามขอบเกรนจะใช้พลังงานน้อยกว่าส่วน การแตกแบบผ่าเกรนจะใช้พลังงานมากกว่าในการทำให้วัสดุแตกหัก นั่นคือวัสดุจะมีการแตกหักได้ ยากยิ่งขึ้นถ้ามีลักษณะการแตกแบบผ่าเกรนร่วมด้วย ดังนั้นลักษณะการแตกของวัสดุเชิงประกอบ อะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์จึงสอดคล้องกับความต้านทานต่อการดัดโค้ง





รูปที่ 4.17 ลักษณะรอยแตกของ (a) อะลูมินา (b) วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ และ (c) วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่ง ร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก ณ อุณหภูมิเผาผนึก 1600 องศาเซลเซียส

4.3 ผลของชนิดและปริมาณของสารเติมแต่ง Mg-PSZ และ Ca-PSZ ต่อสมบัติของ วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์

ในหัวข้อนี้ได้ทำการเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่ ไม่มีสารเติมแต่งและวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีสารเติมแต่ง Mg-PSZ และ Ca-PSZ โดยศึกษาปริมาณของสารเติมแต่งร้อยละ 1.5 3.0 4.5 และ 6.0 โดยน้ำหนัก ณ อุณหภูมิ เผาผนึก 1600 องศาเซลเซียส

4.3.1 ความหนาแน่น

4.3.1.1 ความหน<mark>าแน่นก่อนเ</mark>ผา

จากการทดลองพบว่าการเติม Mg-PSZ และ Ca-PSZ ในวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ทำให้ความหนาแน่นก่อนเผาลดลง การเพิ่มปริมาณของสารเติมแต่งมากขึ้นส่งผล ให้ความหนาแน่นก่อนเผาของวัสดุเชิงประกอบลดลงอาจเนื่องมาจากเซอร์โคเนียมีรูปร่างของ อนุภาคที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งทำให้ packing density ของชิ้นงานลดลง ดังรูปที่ 4.18



รูปที่ 4.18 ปริมาณ Mg-PSZ และ Ca-PSZ ต่อความหนาแน่นสัมพัทธ์ก่อนเผาของ วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์

4.3.1.2 ความหนาแน่นหลังเผา

การเติมแต่งวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ด้วย Mg-PSZ และCa-PSZ พบว่า ความหนาแน่นหลังเผาของวัสดุเชิงประกอบลดลงเมื่อปริมาณของสารเติมแต่งมีมากขึ้น การเติม Ca-PSZ ส่งผลให้ความหนาแน่นหลังเผาลดลงเพียงเล็กน้อยดังรูปที่ 4.19 การลดลงของ ความหนาแน่นอาจเกิดจากอัตราการเพิ่มอุณหภูมิสูงจึงทำให้กระบวนการไล่รูพรุนในโครงสร้าง ของวัสดุระหว่างการเผาเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ และพบว่าความหนาแน่นก่อนเผามีผลต่อ ความหนาแน่นหลังเผา หากความหนาแน่นก่อนเผาน้อยซึ่งหมายความว่าปริมาณรูพรุนในชิ้นงาน มีมากจะส่งผลให้ความหนาแน่นหลังเผามีความหนาแน่นน้อยเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จาก ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นสังเผามีความหนาแน่นน้อยเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จาก กวามสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นสังเผามีความหนาแน่นน้อยเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จาก กวามสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นสังเผามีความหนาแน่นให้มีความหนาแน่นสูงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งใน การกำหนดความหนาแน่นหลังเผา โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของวัสดุนั้นๆ





4.3.2 องค์ประกอบทางเฟส

องค์ประกอบทางเฟสของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังเตนคาร์ไบด์ที่มี Mg-PSZ และ Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่ง ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส แสดงดังรูปที่ 4.20 และรูปที่ 4.21 ตามลำดับ สารเติมแต่งทั้งสองแสดงองค์ประกอบทางเฟสที่เหมือนกันคือ เฟสของแอลฟาอะลูมินา ทังสเตนคาร์ไบด์ ไดทังสเตนคาร์ไบด์ ทังสเตน มอโนคลินิกเซอร์โคเนีย เททระโกนัลเซอร์โคเนีย ZrO โบรอนไนไตรด์และแกมมาไดทังสเตนบอไรด์ สารเติมแต่ง Mg-PSZ พบเฟสของเดลตา ทังสเตนบอไรด์และไม่พบเฟสของแมกนีเซียมออกไซด์ นอกจากนี้ยังพบว่าเฟสของลูกบาศก์ เซอร์โคเนียเปลี่ยนเป็นเททระโกนัลทั้งหมดจึงไม่พบเฟสของลูกบาศก์เซอร์โคเนีย ส่วนสารเติมแต่ง Ca-PSZ ไม่พบเฟสของเดลตาทังสเตนบอไรด์แต่พบเฟสของแคลเซียมออกไซด์ที่ปริมาณสารเติม แต่งร้อยละ 3.0 โดยน้ำหนัก การเกิดเฟสมอโนคลินิกเซอร์โคเนียในวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งอาจเนื่องมาจากการเย็นตัวหลังจากการเผาทำให้ เฟสของเททระโกนัลเซอร์โคเนียเปลี่ยนเป็นเฟสมอโนคลินิกบางส่วน สำหรับพีคของอะลูมินาและ ทังสเตนคาร์ไบด์มีความสูงของพีคลดลงเมื่อปริมาณสารเติมแต่งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณของ อะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์มีปริมาณน้อยลงตามปริมาณของสารเติมแต่งที่เพิ่มขึ้น ส่วนเฟสของ ZrO เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างเซอร์โคเนียและทังสเตนคาร์ไบด์ สำหรับการอธิบายการเกิด เฟสต่างๆ ของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็นสารเติมแต่งได้อธิบาย แล้วในหัวข้อ 4.2.2 และการเกิดเฟสต่างๆ เมื่อมีสารเติมแต่ง Mg-PSZ สามารถอธิบายได้ เช่นเดียวกันกับสารเติมแต่ง Ca-PSZ แต่เฟสของเดลตาทังสเตนบอไรด์ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจาก การทำปฏิกิริยาระหว่างไดทังสเตนคาร์ไบด์และใบรอนไนไตรด์ไม่เหมือนกันกับ Ca-PSZ ซึ่งส่วนที่ ทำปฏิกิริยาอาจเกิดขึ้นได้ดังสมการที่ (4.16)

$$3W_2C + 4BN \rightarrow 2WB + 2W_2B + 3C + 2N_2(g)$$
 (4.16)

ปฏิกิริยารวม ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส จึงเป็นดังสมการที่ (4.18) $Al_2O_3 + 18WC + 8ZrO_2 + 5BN \rightarrow Al_2O_3 + 7WC + 2W_2C + W + +2WB + 2W_2B + BN + 4ZrO_2 + 4ZrO_2 + 4ZrO + 5C + 4CO(g) + 2N_2(g)$ (4.18)

ดังนั้นที่อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส จึงพบเฟลของอะลูมินา ทังสเตนคาร์ไบด์ ไดทังสเตนคาร์ไบด์ ทังสเตน ทังสเตนบอไรด์ ไดทังสเตนบอไรด์ โบรอนไนไตรด์ เซอร์โคเนียและ ZrO ส่วนคาร์บอนไม่สามารถวัดได้ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ แต่ในการทดลองนี้พบ คาร์บอนด้วยเทคนิค EDS เช่นกันกับการเติมแต่งด้วย Ca-PSZ ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.2.2 สำหรับการเกิดไดทังสเตนคาร์ไบด์ของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์และการหายไป ของเฟสทังสเตนบอไรด์ในวัสดุที่มีสารเติมแต่ง Ca-PSZ ได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ 4.2.2 เมื่อสังเกต รูปที่ 4.20 และรูปที่ 4.21 พบว่าปริมาณสารเติมแต่งที่มากขึ้นส่งผลให้เกิดมอโนคลินิกมากขึ้นและ ทำปฏิกิริยากับทังสเตนคาร์ไบด์ได้มากขึ้น จึงทำให้พีคของ ZrO สูงขึ้นและเป็นการลด ประสิทธิภาพในการเพิ่มความเหนียวด้วยการเปลี่ยนเฟส เมื่อเปรียบเทียบสารเติมแต่ง Mg-PSZ และ Ca-PSZ พบว่าการเติม Mg-PSZ ปริมาณ มากขึ้นส่งผลให้ทังสเตนคาร์ไบด์สลายตัวได้มากกว่าการเติม Ca-PSZ ซึ่งสังเกตได้ว่าพีคของ ทังสเตนคาร์ไบด์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนพีคของ ZrO และไดทังสเตนบอไรด์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเกิดคาร์บอนมอนออกไซด์และแก๊สไนไตรเจนมากขึ้นเมื่อทำการเติม Mg-PSZ ในปริมาณมาก การเผาด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิสูงอาจทำให้คาร์บอนมอนออกไซด์ยังคง เหลืออยู่ในชิ้นงานและกลายเป็นรูพรุน^(7, 49) จึงส่งผลให้ความหนาแน่นลดลง ดังนั้นโครงสร้าง จุลภาคของวัสดุเชิงประกอบที่มี Mg-PSZ เป็นสารเติมแต่งจึงมีปริมาณปริมาณรูพรุนในโครงสร้าง จุลภาคมากกว่าการเติม Ca-PSZ ซึ่งสอดคล้องกับความหนาแน่นที่วัดได้ในการทดลองนี้ การเกิด รูพรุนมากขึ้นอาจส่งผลให้ความเหนียวเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากรูพรุนทำการยับยั้งการเคลื่อนที่ของ รอยแตก



ร**ูปที่ 4.20** ปริมาณ Mg-PSZ ต่อองค์ประกอบทางเฟสของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ (a) ไม่มีสารเติมแต่ง (b) 1.5 wt% (c) 3.0 wt% (d) 4.5 wt% และ (e) 6.0 wt%



ร**ูปที่ 4.21** ปริมาณ Ca-PSZ ต่อองค์ประกอบทางเฟสของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ (a) ไม่มีสารเติมแต่ง (b) 1.5 wt% (c) 3.0 wt% (d) 4.5 wt% และ (e) 6.0 wt%

4.3.3 โครงสร้างจุลภาค

จากการศึกษาลักษณะผิวของขึ้นงานที่ผ่านการขัดเงาและกัดผิวด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียส ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าการเติม Mg-PSZ ใน วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ ทำให้ได้โครงสร้างจุลภาคดังรูปที่ 4.22 ซึ่ง ประกอบด้วยเนื้อพื้นสีเทาคืออะลูมินาและจุดสีขาวคืออนุภาคทังสเตนคาร์ไบด์และเซอร์โคเนีย กระจายอยู่ตามขอบเกรนหรือจุดที่เกรนมาบรรจบกัน จุดสีขาวนี้ไม่สามารถแยกความแตกต่าง ระหว่างทังสเตนคาร์ไบด์และ Mg-PSZ ได้อย่างชัดเจนแต่สามารถตรวจองค์ประกอบทางเคมีได้ ด้วยเทคนิค EDS สำหรับการเติม Mg-PSZ ทำให้ลักษณะของโครงสร้างจุลภาคของ วัสดุเชิงประกอบไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือรูปร่างของเกรนยังคงเหมือนเดิมและมีขนาดเกรนของ เนื้อพื้นไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่ไม่มี สารเติมแต่งโดยขนาดเกรนของวัสดุเชิงประกอบที่มีการเติม Mg-PSZ มีค่าไม่เกิน 1.8 ไมครอน ดัง รูปที่ 4.24 แต่การเติม Mg-PSZ ส่งผลให้รูพรุนในโครงสร้างมากขึ้น โดยพบว่าปริมาณรูพรุนใน โครงสร้างจุลภาคสอดคล้องกับความหนาแน่นหลังเผา การหาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค EDS ของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Mg-PSZ เป็นสารเติมแต่งประกอบด้วยส่วนที่ศึกษา 3 ส่วนด้วยกัน คือ สเปกตรัมแรกเป็นส่วนของเนื้อพื้นสีดำ สเปกตรัมที่สองเป็นส่วนของจุดสีขาวขนาดใหญ่ และ สเปกตรัมที่สามเป็นจุดสีขาวขนาดเล็กดังรูปที่ 4.24 โดยองค์ประกอบทางเคมีของแต่ละส่วนแสดง ดังรูปที่ 4.22 (f) - (h) ตามลำดับ จะเห็นว่าส่วนที่เป็นเนื้อพื้นสีดำเป็นเนื้อพื้นของอะลูมินาและมี คาร์บอนกระจายอยู่บนเนื้อพื้นอะลูมินา ดังจะเห็นว่ามีพีคเล็กๆ ของคาร์บอนปรากฏอยู่ในรูปที่ 4.22 (f) ซึ่งเป็นการสนับสนุนสมมุติฐานของการเกิดไดทังสเตนคาร์ไบด์หลังจากการเผาซึ่งได้กล่าว ไว้ว่าทังสเตนคาร์ไบด์บางส่วนเกิดการสลายตัวกลายเป็นไดทังสเตนคาร์ไบด์และคาร์บอนตาม สมการที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 4.2.2 และ 4.3.2 ส่วนจุดสีขาวขนาดใหญ่นั้นเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ ใดทังสเตนคาร์ไบด์หรือทังสเตน และจุดสีขาวขนาดเล็กเป็นเซอร์โคเนียหรือ ZrO สำหรับพีคของ ทองแดงที่ปรากฏในรูป 4.22 (f-h) เกิดจากการฉาบทองบนผิวตัวอย่างเพื่อให้เกิดการนำไฟฟ้า ส่วนรอยแตกที่สังเกตเห็นในรูป 4.22 (a) นั้นเป็นรอยแตกที่เกิดจากการกดวัดความแข็งด้วยหัวกด วิกเกอร์และพบว่ามีการแตกแบบตามขอบเกรนและแตกแบบผ่าเกรน



รูปที่ 4.22 โครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีของธาตุด้วยเทคนิค EDS ของ วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Mg-PSZ เป็นสารเติมแต่ง ณ อุณหภูมิเผาผนึก 1600 องศาเซลเซียส (a)1.5 wt% (b) 3.0 wt% (c) 4.5 wt% (d) 6.0 wt% (e) จุดที่หาองค์ประกอบทางเคมี (f) บริเวณเนื้อพื้นสีเทา (g) บริเวณ อนุภาคสีขาวขนาดใหญ่และ (h) บริเวณอนุภาคสีขาวขนาดเล็ก

้สำหรับการเติม Ca-PSZ ในวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์พบว่าโครงสร้าง ้จุลภาคของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์เปลี่ยนไปจากเดิม โดย Ca-PSZ ทำให้เกรน มีลักษณะการโตในแนวยาวมากขึ้นและมีขนาดเกรนเล็กและขนาดใหญ่ปะปนกันดังรูปที่ 4.24 การเพิ่มปริมาณของ Ca-PSZ ส่งผลให้ขนาดเกรนมีแนวโน้มใหญ่ขึ้นดังรูปที่ 4.25 โดยปริมาณของ Ca-PSZ ร้อยละ 6 โดยน้ำหนักมีขนาดของเกรนมากถึง 2.9 ไมครอน ซึ่งเล็กกว่าอะลูมินา (3.64 ไมครอน) เพียงเล็กน้อย การเติม Ca-PSZ มากกว่าร้อยละ 4.5 โดยน้ำหนักพบว่าเกิดการเกาะตัว กันของเซอร์โคเนีย ความหนาแน่นของชิ้นงานที่ผ่านการเผาผนึกลดลงตามปริมาณของ เซอร์โคเนีย การลดลงอาจเกิดจากการเกาะตัวกันของผงเซอร์โคเนียซึ่งไม่สามารถทำลายได้ขณะ ้กระบวนการเตรียมผง การเกาะตั<mark>วกันนี้ส่งผลให้ขนาดเก</mark>รนของเนื้อพื้นอะลูมินามีขนาดใหญ่หรือ หยาบขึ้นตามปริมาณของเซอร์โคเนียที่เพิ่มขึ้น⁽⁵³⁾ การเพิ่มปริมาณของ Ca-PSZ อาจทำให้พลังงาน ที่รอยต่อระหว่างผิวหน้า (interface) ของอะลูมินาที่กระจายอยู่แตกต่างกันซึ่งทำให้อัตราการโต ของเกรนเปลี่ยนไป เกิดเกรนที่ไม่มีความสมมาตรและเกิดการโตของเกรนที่ยาวขึ้น ทำให้พลังงานที่ ใช้ในการแตกเพิ่มขึ้นโดยเกิดการเบี่ยงเบนของรอยแตกดังรูปที่ 4.15 (c) ซึ่งเพิ่มความต้านทาน รอยแตกและเพิ่มความเหนียว⁽⁵⁵⁾ การเติมแต่งวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ด้วย Mg-PSZ และ Ca-PSZ นี้พบ<mark>ว่ากลไกการเพิ่มความเหนียวด้วยการ</mark>เปลี่ยนเฟสนี้มีน้อย อาจเนื่องจาก การเปลี่ยนมอโนคลินิกเซอร์โคเนียเป็น ZrO



รูปที่ 4.23 โครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี Ca-PSZ เป็น สารเติมแต่ง ณ อุณหภูมิเผาผนึก 1600 องศาเซลเซียส (a) 1.5 wt% (b) 3.0 wt% (c) 4.5 wt% และ (d) 6.0 wt%



รูปที่ 4.24 ปริมาณ Mg-PSZ และ Ca-PSZ ต่อขนาดเกรนเนื้อพื้นอะลูมินาของวัสดุเชิงประกอบ อะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์

4.3.4 ความแข็ง

จากการทดลองพบว่าปริมาณสารแต่งที่มากขึ้นส่งผลให้วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งลดลง การลดลงของความแข็งนี้อาจเนื่องมาจากอนุภาคของ เซอร์โคเนียที่เติมเข้าไปมีความแข็งน้อยกว่าอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์ อีกทั้งขนาดเกรนใน โครงสร้างจุลภาคมีขนาดใหญ่กว่าขนาดเกรนในโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ จากรูปที่ 4.25 จะเห็นว่าการเติม Mg-PSZ ส่งผลให้ความแข็งของ วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ลดลงไม่มากนักอาจเนื่องมาจากลักษณะทางโครงสร้าง ที่ได้รวมทั้งขนาดเกรนในโครงสร้างจุลภาคไม่แตกต่างจากวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์ โดยมีความแข็งอยู่ในช่วง 16.71 – 17.84 กิกะพาสคัล ส่วนการเติม Ca-PSZ ใน วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ส่งผลให้ความแข็งลดลงและลดลงมากกว่าการเติม Mg-PSZ ทั้งนี้เนื่องจากขนาดเกรนของเนื้อพื้นเมื่อมีการเติม Ca-PSZ มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ ชัดซึ่งส่งผลให้ความแข็งลดลงและมีความแข็งอยู่ในช่วง 14.49 – 16.36 กิกะพาสคัล



รูปที่ 4.25 ปริมาณ Mg-PSZ และ Ca-PSZ ต่อความแข็งของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทังสเตนคาร์ไบด์

4.3.5 ความเหนียว

การเติม Mg-PSZ และ Ca-PSZ ในวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์พบว่า ความเหนียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณของสารเติมแต่งดังรูปที่ 4.26 โดยการเติม Mg-PSZ ้ส่งผลให้ความเหนียวของวัสดุเชิงประกอบ (4.29 – 5.07 เมกะพาสคัล.เมตร^{1/2}) เพิ่มขึ้นไม่มากนัก อาจเนื่องมาจากลักษณะของโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก นัก การเพิ่มความเหนียวของวัสดุชนิดนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณรูพรุนที่เพิ่มขึ้นเพราะรูพรุน สามารถดูดซับพลังงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีแรงภายนอกมากระทำกับชิ้นงานทำให้มีความเค้น ้เกิดขึ้นภายในเนื้อวัสดุและความเค้น<mark>จะวิ่งไปปะทะกับ</mark>รูพรุนทำให้พลังงานที่ปลายของรอยแตกนั้น ลดลงได้ เมื่อจำนวนรูพรุนมีม<mark>ากทำให้วัสดุมีความเหนียว</mark>สูงและในทางตรงกันข้ามเมื่อจำนวน รูพรุนมีน้อยก็ดูดซับพลังงา<mark>นได้น้อยทำใ</mark>ห้วัส<mark>ด</mark>ุมี<mark>ความเหนียว</mark>ต่ำ ส่วนการเพิ่มความเหนียวด้วย การเปลี่ยนเฟสอาจมีส่วนช่วยให้ความเหนียวเพิ่มขึ้นไม่มากนัก สำหรับการเพิ่มความเหนียวโดย การเติมปริมาณ Ca-PSZ ที่มากขึ้นอาจเกิดเนื่องจากลักษณะของเกรนที่เปลี่ยนไปทำให้ การเคลื่อนที่ของรอยแตกเคลื่อนที่ได้ยากยิ่งขึ้นจึงทำให้วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ ที่มีการเติม Ca-PSZ เข้าไปมีความเหนียวสูงขึ้น (4.25 – 5.67 เมกะพาสคัล.เมตร^{1/2}) การเพิ่ม ้ความเหนียวด้วยการเพิ่มรูพรุ<mark>นในกรณีของ Ca-P</mark>SZ <mark>น่าจะ</mark>มีผลน้อยมากเนื่องจากความหนาแน่น ของวัสดุเชิงประกอบที่ได้ไม่เปลี่ยนแปล<mark>งมากนัก อีกทั้งโครงสร้า</mark>งจุลภาคยังแสดงให้เห็นว่าปริมาณ รูพรุนนั้นมีปริมาณน้อย



รูปที่ 4.26 ปริมาณ Mg-PSZ และ Ca-PSZ ความเหนียวของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทั้งสเตนคาร์ไบด์

4.3.6 ความต้านทานต่อการดัดโค้ง

จากรูปที่ 4.27 พบว่าการเติม Mg-PSZ และ Ca-PSZ ส่งผลต่อความต้านทานต่อการดัด โค้งของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ โดยความต้านทานต่อการดัดโค้งมีแนวโน้ม ลดลงตามปริมาณสารเติมแต่งที่มากขึ้น การเติม Mg-PSZ ส่งผลให้ความต้านทานต่อการดัดโค้ง ลดลงมากกว่า Ca-PSZ ทั้งนี้เนื่องจากวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่เติมแต่งด้วย Mg-PSZ มีปริมาณรูพรุนเพิ่มขึ้น การเพิ่มความต้านทานต่อการดัดโค้งทำได้โดยการลดขนาด วิกฤติของตำหนิและลดตำหนิบนผิวของวัสดุลง⁽⁵³⁾ รูพรุนที่เกิดมากขึ้นในโครงสร้างนี้จึงเป็นการเพิ่ม ตำหนิในชิ้นงานจึงส่งผลให้ความต้านทานต่อการดัดโค้งลดลง ส่วนการเติม Ca-PSZ แม้เกิด การเกาะตัวกันของอนุภาคเซอร์โคเนียและเกรนของเนื้อพื้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้ ความต้านทานต่อการดัดโค้งลดลง แต่ปริมาณรูพรุนในโครงสร้างเพิ่มขึ้นไม่มากนักจึงทำให้ ความต้านทานต่อการดัดโค้งลดลง แต่ปริมาณรูพรุนในโครงสร้างเพิ่มขึ้นไม่มากนักจึงทำให้ ความต้านทานต่อการดัดโค้งลดลงจากวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์เพียงเล็กน้อย ซึ่งการเติม Ca-PSZ ในวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ทำให้วัสดุมีความต้านทานต่อ การดัดโค้งอยู่ในช่วง 270 – 340 เมกะพาสคัล และวัสดุที่มีการเติม Mg-PSZ มีความต้านทานต่อ การดัดโค้งอยู่ในช่วง 200 – 300 เมกะพาสคัล



รูปที่ 4.27 ปริมาณ Mg-PSZ และ Ca-PSZ ต่อความต้านทานต่อการดัดโค้งของวัสดุเชิงประกอบ อะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาผลของอุณหภูมิและสารเติมแต่ง Mg-PSZ และ Ca-PSZ ต่อ โครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ รวมทั้งเปรียบเทียบ สมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์กับอะลูมินา เพื่อนำวัสดุเชิงประกอบชนิดนี้ ไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัดต่อไป สำหรับงานวิจัยนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 การเผาผนึกที่อุณหภูมิสูงขึ้นช่วยเพิ่มความหนาแน่นและปรับปรุงสมบัติทางกลให้แก่ อะลูมินาและวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ การเติม Ca-PSZ ในวัสดุเชิงประกอบ อะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ก็ให้ผลเช่นเดียวกัน

2) การเผาผนึกอะลูมินา ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส ก่อให้เกิดการโตของเกรน อะลูมินา ส่งผลให้ความเหนียวและความแข็งแรงของอะลูมินาลดลง ส่วนการเสริมแรงด้วยอนุภาค ทั้งสเตนคาร์ไบด์เกิดการยับยั้งการโตของเกรนซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งและความต้านทานต่อ การดัดโค้งให้แก่วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์

3) การเกิดเฟสของ ZrO จากการเติม Mg-PSZ และ Ca-PSZ ในวัสดุเซิงประกอบ อะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์และเผาผนึก ณ อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส ทำให้ลดปริมาณ การเกิดมอโนคลินิกเซอร์โคเนียทำให้การเพิ่มความเหนียวด้วยการเปลี่ยนเฟสมีประสิทธิภาพลดลง

4) การเติมแต่งวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ด้วย Mg-PSZ ในปริมาณมาก ขึ้นทำให้รูพรุนในโครงสร้างจุลภาคมากขึ้นและการเกิดรูพรุนเป็นกลไกหลักในการเพิ่มความเหนียว แต่ลดความต้านทานต่อการดัดโค้งในวัสดุชนิดนี้ ส่วนความแข็งของวัสดุเชิงประกอบชนิดนี้มี ความแข็งน้อยกว่าวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์เนื่องจากขนาดเกรนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามความแข็งและความต้านทานต่อการดัดโค้งของวัสดุชนิดนี้ยังมากกว่าอะลูมินา

5) การเติมแต่งวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ด้วย Ca-PSZ ในปริมาณมาก ขึ้นทำให้ขนาดเกรนของเนื้อพื้นโตและมีลักษณะยาวขึ้นส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนของรอยแตกใน วัสดุเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มความเหนียวในวัสดุชนิดนี้ แต่การโตของเกรนนี้ส่งผลให้ ความแข็งและความต้านทานต่อการดัดโค้งของวัสดุลดลง การเกาะตัวกันของเซอร์โคเนียเป็นอีก ปัจจัยหนึ่งในการทำให้ความต้านทานต่อการดัดโค้งลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามความต้านทานต่อ การดัดโค้งของวัสดุชนิดนี้ยังสูงกว่าอะลูมินา 6) การเติมแต่งวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทั้งสเตนคาร์ไบด์ด้วย Ca-PSZ เหมาะแก่ การนำไปใช้งานมากกว่าการเติมแต่งด้วย Mg-PSZ แต่การนำวัสดุเชิงประกอบชนิดนี้ไปใช้เป็น วัสดุตัดในการใช้งานจริงยังต้องทำการปรับปรุงความแข็งของวัสดุชนิดนี้ให้มากขึ้น

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 การควบคุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างการเผาวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ ทั้งสเตนคาร์ไบด์ควรทำให้ดีกว่านี้ เนื่องจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับสมบัติของวัสดุ

5.2.2 ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเฟสต่างๆ โดยกระบวนการทาง อุณหพลวัต (thermodynamics) พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสที่เกิดขึ้นกับสมบัติ ทางกลและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีและไม่มี สารเติมแต่ง

5.2.3 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาสมบัติทางด้านความทนต่อการขูดขีด การขยายตัว ทางความร้อน ความทนต่อการสึกกร่อนและความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันของ วัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์ เนื่องจากสมบัติทั้งเหล่านี้มีความสำคัญในการนำวัสดุ ที่ได้ไปใช้งานจริงในการนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุตัด

รายการอ้างอิง

- (1) Whitney, E. D. <u>Ceramic cutting tools : Materials, development, and performance</u>. United States of America: Noyes Publications, 1994.
- (2) Like, Q., Xikun, L., Guanming, Q., Weimin, M., Yanbin, S. and Huadong, Y. Study on toughness mechanism of ceramic cutting tools. <u>Journal of Rare Earths</u> 25 (2007): 309-316.
- (3) Kumar, A. S., Durai, A. R. and Sornakumar, T. Wear behaviour of alumina based ceramic cutting tools on machining steels. <u>Tribology International</u> 39 (2006): 191-197.
- (4) Acchar, W., Gomes, U. U., Kaysser, W. A. and Goring, J. Strength degradation of a tungsten carbide-cobalt composite at elevated temperatures. <u>Materials</u> <u>Characterization</u> 43 (1999): 27-32.
- (5) Wang, L., Shi, J. L., Hua, Z. L., Gao, J. H. and Yan, D. S. The influence of addition of WC particles on mechanical properties of alumina-matrix composite. <u>Materials</u> <u>Letters</u> 50 (2001): 179-182.
- (6) Wang, L., Shi, J. L., Gao, J. H. and Yan, D. S. Influence of tungsten carbide particles on resistance of alumina matrix ceramics to thermal shock. <u>Journal of the</u> <u>European Ceramic Society</u> 21 (2001): 1213-1217.
- (7) Acchar, W., Martinelli, A. E., Vieira, F. A. and Cairo, C. A. A. Sintering behaviour of alumina-tungsten carbide composites. <u>Materials Science and Engineering A</u> 284 (2000): 84-87.
- (8) Acchar, W., Cairo, C. A. and Segadaes, A. M. Effect of tungsten carbide additions on the microstructure and properties of hot-pressed alumina. <u>Materials Science and</u> <u>Engineering A</u> 406 (2005): 74-77.
- (9) Wittig, D., Glauche, A., Aneziris, C. G., Minghetti, T., Schelle, C., Graule, T. and Kuebler, J. Activated pressureless melt infiltration of zirconia-based metal matrix composites. <u>Materials Science and Engineering A</u> 488 (2008): 580-585.
- (10) Grzesik, W. <u>Advanced machining processes of metallic materials</u>. London: Elsevier, 2008.

- (11) Schwartz, M. M. <u>Composite materials, Volume II : Processing, fabrication, and</u> <u>applications</u>. New Jersey: Prentice Hall PTR, 1997.
- (12) Kitiwan, M. <u>Preparation of Al₂O₃-TiC composites using microwave energy</u>. Master's Thesis, Department of Materials Science, Graduate School, Chulalongkorn University, 2004.
- (13) Wangmooklang, N. <u>Improvement of mechanical properties of Si₃N₄ using low cost materials and processes</u>. Doctoral dissertation, Department of Materials Science, Graduate School, Chulalongkorn University, 2006.
- (14) แม้น อมรสิทธิ์ และสมชัย อั<mark>ครทิวา. <u>วัสดุวิศวกรรม</u>. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ท้อป, 2549.</mark>
- (15) สุวันชัย พงษ์กิจวัฒน์ และคนอื่นๆ. <u>วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมพื้นฐาน</u>. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ท้อป, 2548.
- (16) Schwartz, M. M. <u>Composite materials, Volume I : Properties, nondestructive testing</u> <u>and repair</u>. New Jersey: Prentice Hall PTR, 1997.
- (17) Acchar, W., Schwarze, D. and Greil, P. Sintering of AI_2O_3 -NbC composites using TiO₂ and MnO additives: preliminary results. <u>Materials Science and Engineering</u> <u>A</u> 351 (2003): 299-303.
- (18) Acchar, W. and Segadaes, A. M. Properties of sintered alumina reinforced with niobium carbide. <u>International Journal of Refractory Metals and Hard Materials</u> 27 (2009): 427-430.
- (19) Carter, C. B. and Norton, M. G. <u>Ceramic materials : Science and engineering</u>. New York ; London: Springer, 2007.
- (20) อนุรัตน์ ภูวานคำ. <u>การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา-มูลไลท์-เซอร์โคเนีย สำหรับงานทาง</u> <u>วิศวกรรม</u>. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี, 2548.
- (21) Weimer, A. W. <u>Carbide, nitride and boride materials synthesis and processing</u>.United States of America: Chapman & Hall, 1997.
- (22) <u>Tungsten carbide</u>[Online]. Available from: <u>http://en.wikipedia.org/wiki/Tungsten</u> <u>carbide</u> [2009,July 23]
- (23) Huang, S., Vanmeensel, K., Van Der Biest, O. and Vleugels, J. Pulsed electric current sintering and characterization of ultrafine Al₂O₃–WC composites. <u>Materials Science and Engineering A</u> 527 (2010): 584-589.

- (24) Luangthanarak, H. and Kangwantrakool, S., Synthesis of SiC nanoparticles by mechanical alloying, The 12th National Graduate Research Conference, CGAU and Khon Kaen University, 2009, 487-493.
- (25) Pallone, E. M. J. A., Martin, D. R., Tomasi, R. and Filho, W. J. B. Al₂O₃-WC synthesis by high-energy reactive milling. <u>Materials Science and Engineering A</u> 464 (2007): 47-51.
- (26) Sakaki, M., Bafghi, M. S., Khaki, J. V., Zhang, Q. and Saito, F. Control of carbon loss during synthesis of WC powder through ball milling of WO₃–C–2AI mixture. <u>Journal of Alloys and Compounds</u> 486 (2009): 486-491.
- (27) วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา. เครื่องมือวิจัยทางวัสดุศาสตร์ : ทฤษฎีและหลักการทำงานเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
- (28) พืชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ. การเตรียมสเตบิไลซ์เซอร์โคเนียโดยวิธีการตกตะกอนร่วม. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- (29) Hemra, K. <u>High strength materials : Alumina-zirconia composite using low cost raw</u> <u>powder</u>. Master's Thesis, Department of Materials Science, Graduate School, Chulalongkorn University, 2003.
- (30) Chiang, Y. M., Birnie, D. P. and Kingery, W. D. <u>Physical ceramics : Principles for</u> <u>ceramic science and engineering</u> New York: Wiley, 1997.
- (31) Thanngam, P. <u>Development of low cost Mg-PSZ with nanostructure and high</u> <u>mechanical strength</u>. Master's Thesis, Department of Materials Science, Graduate School, Chulalongkorn University, 2004.
- (32) Kelly, J. R. and Denry, I. Stabilized zirconia as a structural ceramic: An overview. <u>Dental Materials</u> 24 (2008): 289-298.
- (33) Stevens, R. Zirconia and zirconia ceramics. Leeds: Magnesium Elektron, n.d.
- (34) Dogan, C. P. and Hawk, J. A. Role of zirconia toughening in the abrasive wear of intermetallic and ceramic composites. <u>Wear</u> 212 (1997): 110-118.
- (35) Ravikiran, A., Subbanna, G. R. and Bai, B. N. P. Effect of interface layers formed during dry sliding of zirconia toughened alumina (ZTA) and monolithic alumina against steel. <u>Wear</u> 192 (1996): 56-65.

- (36) Kong, Y., Yang, Z., Zhang, G. and Yuan, Q. Friction and wear characteristics of mullite, ZTM and TZP ceramics. <u>Wear</u> 218 (1998): 159-166.
- (37) Barsoum, M. W. Fundamentals of ceramics. New York: Taylor & Francis, 2003.
- (38) Na Nakorn, P., Jinawath, S. and Wada, S. Mechanical strength and thermal conductivity of high purity Al₂O₃ ceramics using AKP-30 powder. <u>Journal of Scientific Research Chulalongkorn University</u> 30 (2005): 77-85.
- (39) American Society for Testing and Material (ASTM), Standard Test Methods for Apparent Porosity, Liquid Absorption, Apparent Specific Gravity, and Bulk Density of Refractory Shapes by Vaccuum Pressure, ASTM C830-93, United State: ASTM, 1998.
- (40) Na Nakorn, P. <u>Development of alumina substrate for peltier element</u>. Master's Thesis, Department of Materials Science, Graduate School, Chulalongkorn University, 2003.
- (41) Panmaung, K. <u>Development of alumina zirconia composite for milling ball</u>.
 Master's Thesis, Department of Materials Science, Graduate School, Chilalongkorn University, 2003.
- (42) American Society for Testing and Material (ASTM), Standard Test Methods for Vickers Indentation Hardness of Advanced Ceramics, ASTM C1327-03, United State: ASTM, 2005.
- (43) Sergejev, F. and Antonov, M. Comparative study on indentation fracture toughness measurements of cemented carbides. <u>Proceedings of the Estonian Academy of</u> <u>Sciences Engineers</u> 12 (2006): 388-398.
- (44) American Society for Testing and Material (ASTM), Standard Test Methods for Flexural Strength of Advanced Ceramics at Ambient Temperature, ASTM C1161-02c, United State: ASTM, 2005.
- (45) American Society for Testing and Material (ASTM), Standard Test Methods for Determining Average Grain Size, ASTM E112-96, United State: ASTM, 2004.
- (46) Acchar, W., Martinelli, A. E. and Cairo, C. A. A. Reinforcing Al₂O₃ with W-Ti mixed carbide. <u>Materials Letters</u> 46 (2000): 209-211.
- (47) Oliveira, F. A. C., Fernandes, J. C., Badie, J.-M., Granier, B., Rosa, L. G. and Shohoji, N. High meta-stability of tungsten sub-carbide W₂C formed from

tungsten/carbon powder mixture during eruptive heating in a solar furnace. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 25 (2007): 101-106.

- (48) Moskala, N. and Pyda, W. Thermal stability of tungsten carbide in 7 mol.% calciazirconia solid solution matrix heat treated in argon. <u>Journal of the European</u> <u>Ceramic Society</u> 26 (2006): 3845-3851.
- (49) Malek, O., Lauwers, B., Perez, Y., Baets, P. D. and Vleugels, J. Processing of ultrafine ZrO₂ toughened WC composites. <u>Journal of the European Ceramic Society</u> 29 (2009): 3371-3378.
- (50) Ye, Y., Li, J., Zhou, H. and Chen, J. Microstructure and mechanical properties of yttria-stabilized ZrO₂/Al₂O₃ nanocomposite ceramics. <u>Ceramics International</u> 34 (2008): 1797-1803.
- (51) Tai, W. P. and Watanabe, T. Fabrication and mechanical properties of Al₂O₃-WC-Co composites by vacuum hot pressing. <u>Journal of the American Ceramic Society</u> 81 (1998): 1673-1676.
- (52) Teng, X., Liu, H. and Huang, C. Effect of Al₂O₃ particle size on the mechanical properties of alumina-based ceramics. <u>Materials Science and Engineering A</u> 452-453 (2007): 545-551.
- (53) Guimarães, F. A. T., Silva, K. L., Trombini, V., Pierri, J. J., Rodrigues, J. A., Tomasi, R. and Pallone, E. M. J. A. Correlation between microstructure and mechanical properties of Al₂O₃/ZrO₂ nanocomposites. <u>Ceramics International</u> 35 (2009): 741-745.
- (54) Zhao, J., Yuan, X. and Zhou, Y. Cutting performance and failure mechanisms of an Al₂O₃/WC/TiC micro- nano-composite ceramic tool. <u>International Journal of</u> <u>Refractory Metals and Hard Materials</u> 28 (2010): 330-337.
- (55) Rong, S. F., Ji, Z. S., Zhu, Y. C. and Zhang, J. Q. Effect of rod-like grain on properties and toughening mechanism of 3Y-TZP/Al₂O₃ ceramics. <u>Transactions</u> <u>of Nonferrous Metals Society of China</u> 18 (2008): 388-392.

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<mark>ภาค</mark>ผนวก

ภาคผนวก ก

แสดงการกระจายขนาดอนุภาคด้วยเครื่อง Particle Size Analyzer รุ่น 2000 ผลิตโดยบริษัท Malvern โดยใช้เทคนิค Laser Light Scattering









รูปที่ ก - 3 การกระจายขนาดอนุภาคของ Mg-PSZ



รูปที่ ก - 4 การกระจายขนาดอนุภาคของ Ca-PSZ

ภาคผนวก ข

ตารางที่ ข - 1 แสดงค่า 20, intensity และ hkl ของ **α**-Al₂O₃ ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานจาก JCPDS (International Centre for Diffraction Data) หมายเลข 01-082-1467

Pattern : 01-082-146	7		Radiation =	1.5405	98			Quality : Alternate
α-Al ₂ O ₃			210	1	h	*	1	
Aluminum Oxide			20.576 36.151 37.777 41.678 43.354 46.179 52.552 57.501 59.742 61.131 61.131	680 999 461 5 955 15 470 917 23 33 84	01101201210	10101021121	24063246128	
Lattice : Rhombohed	irai	Mol. weight = 101.96	66.519 68.211 70.418 74.302	348 530 11	2312	1 0 2 0	4058	
S.G. / R-3c (167)		Volume [CD] = 254.81	76.876 77.238	147 86	1	0	10 9	
a = 4.75890 c = 12.99190	Z= 6	Dx = 3.997	80,420 80,700 83,218 84,358 86,142 86,353 86,505 89,000	8 58 6 46 34 27 63	22021310	1 23 23 1 22	7 0 6 3 1 2 8 10	
Data collection flag:	Ambient	ย่วิทยุง	ารัพ	2		3		
Sawada, H., Mater. R Calculated from ICSD	es. Buil., volume 2 using POWD-124	9, page 127 (1994) ++ (1997)	เหา?	01	1	2	1	ลัย
Radiation : CuKa1 Lambda : 1.54050		Filter : Not specified d-sp : Calculated spacings						

ตารางที่ ข - 2 แสดงค่า 20, intensity และ hkl ของ **α**-Al₂O₃ ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานจาก JCPDS (International Centre for Diffraction Data) หมายเลข 01-081-2267

Pattern : 01-081-226	7		Radiation =	1.540	598			Quality : Alternate
(λ-Al2O3 Aluminum Oxide Corundum			2th 25.601 35.182 37.818 41.711 43.399 46.228 52.006 57.556 59.809 61.200 61.358 66.593	/ 999 468 5 960 15 473 914 24 34 86 354	h 011012012102	* 101010211211	N406m046=084	
Lattice : Rhombohed S.G. : R-3c (167) a = 4.75400 c = 12.98200	z = 6	Mol. weight = 101.96 Volume [CD] = 254.09 Dx = 3.998 Mcor = 1.02	68.291 70.495 74.377 76.948 77.314 80.509 80.801 83.316 84.483 85.250 86.483 86.602 89.094	531 11 14 151 87 8 59 7 45 3 59 7 45 35 29 64	31211220021810	0200112023122	0580970631280	
ICSD collection code Temperature factor: Remarks from ICSD/ Additional pattern: S Data collection flag:	r: 073725 ATF CSD: REM DI ee PDF 43-1484 Ambient.	EN				0		
Maslen, E.N., Streitso Crystallogr., Sec. B. S Calculated from ICSD	v, V.A., Streitsov ructural Science using POWD-12	a, N.R., ishizawa, N., Satow, Y., Acta , volume 49, page 973 (1993) ++ (1997)	รัพ หา1	ย		ก	วิ	ลัย
Radiation : CuKa1 Lambda : 1.54060 SS/FOM : F25=1000(0.0003,25)	Filter : Not specified d-sp : Calculated spacings	_	0				

Pattern : 00-048-1467 Radiation = 1.540598 Quality ; Calculated CaO 2th i 1 h k 32.200 37.360 53.860 64.160 67.380 79.660 88.529 40 1 1001201021012 1001000001404 100 51 17 14 5 7 14 11 7 5 15 19 22224242445454 Calcium Oxide 91,470 103,340 112,621 129,859 142,641 147,792 Mol. weight = 56.08 Lattice : Face-centered cubic S.G. : Fm-3m (225) Volume [CD] = 111.33 a = 4.81059 Dx = 3.346 Z = l/lcor = 4.45 Additional pattern: See also 37-1497. Data collection flag: Ambient. Reardon, B., Hubbard, C., TM-11948., Oak Ridge Nati, Lab. Rep. ORNL (U.S.) (1992) Radiation : CuKa1 Filter : Not specified Lambda : 1.54060 d-sp : Calculated spacings SS/FOM : F13=411(0.0024,13)

ตารางที่ ข - 3 แสดงค่า 2θ, intensity และ hkl ของ CaO ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานจาก JCPDS (International Centre for Diffraction Data) หมายเลข 00-048-1467

Pattern : 00-045-1171		Radiation =	1.5405	98			Quality : Indexed
BN Boron Nitride		2th 26.717 42.620 45.566 55.065 56.074 63.189 75.955 80.417 02.122 87.671 91.237	/ 100 13 7 4 2 1 3 1 4 1 1	h 010010111100	* 00100110100	31264507391	
Lattice : Rhombohedral S.G. : R3m (160) a = 2.50400 c = 10.00000 Z = 3	Mol. weight = 24.82 Volume (CD) = 54.30 Dx = 2.277	93,232 100,623 135,662 141,147 144,545	19111	21121	01112	26912	
Color: Pure white Melting point: >2300d Sample preparation: Prepared from heating with KCN at 1050 C and hea after NaCl and KCN were removed b Unit cell. Rhombohedral cell, a=3.63 Data collection fling: Ambient.	Na B H4 and N H4 Cl crystalized by 4-roated at 2100 C in nitrogen atmosphere y water. 34. 0.=40.30, Z=1.				8		
Sato, T., National Inst. for Research Private Communication (1993)	in Inorganic Materials, Ibaraki, Japan.	รัพ หาใ	ย		้ ก ย	วี	ลัย
Radiation : CuKa1 Lambda : 1.54060 SS/FOM : F16= 24(0.0280,24)	Filter : Monochromator crystal d-sp : Diffractometer External standard : Si						

Quality : Deleted Pattern : 00-001-1203 Radiation = 1.540598 W 1 i 2th n k 40,416 58,357 73,329 86,907 100,761 115,662 132,969 154,355 100 63 75 63 75 38 63 25 50 50 0010001000 0 NNNNNNNN 404 Tungsten 2122032 Lattice : Body-centered cubic Mol. weight = 183.85 S.G. : Im-3m (229) Volume [CD] = 31.40 a = 3.15500 Dx = 19.442 Dm = 19.320 Z = 2 Deleted and rejected by: Deleted by NBS card. Color: Grayish black Melting point: 3410 Data collection flag: Ambient. Davey, Phys. Rev., volume 25, page 753 (1925) Radiation : MoKa Filter : Not specified Lambda : 0.70900 d-sp : Not given SS/FOM : F10= 7(0.1420,10)

ตารางที่ ข - 5 แสดงค่า 20, intensity และ hkl ของ W ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานจาก JCPDS (International Centre for Diffraction Data) หมายเลข 00-001-1203

ตารางที่ ข - 6 แสดงค่า 20, intensity และ hkl ของ **δ**-WB ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานจาก JCPDS (International Centre for Diffraction Data) หมายเลข 00-006-0635

Pattern : 00-006-0635		Radiation =	1.5405	98			Quality : Deleted
Õ-WB Boron Tungsten		2th 20.885 29.082 32.853 39.277 42.319 42.854 47.543 52.618 57.129	10 10 50 100 100 20 50 100 50 100 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	h 011110111	* 000010010	412528769	
Lattice : Body-centered tetragonal S.G. : 141/amd (141) a = 3.11500 c = 16.93000 Z = 0	Mal. weight = 194.65 Volume [CD] = 164.28 Dx = 15.741	50.388 66.176 67.417 67.861 69.465 70.050 73.528 75.788 79.314 79.710	50 5 10 10 20 50 50 50 50 10	~~~~~	00010111010	042113058713	
Deleted and rejected by: Deleted by Additional pattern: See ICSD 2-428 Data collection flag: Ambient.	(35-738. 1 (POF 73-1769)				5		
Klessling., Acta Chem. Scand., volun	te 1, page 803 (1947)	รัพ	2	1	ก	วั	
<u></u> A_16	งกรณม	N. I.	4		Ы		ଗଧ

ตารางที่ ข - 7 แสดงค่า 2θ, intensity และ hkl ของ γ-W₂B ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานจาก JCPDS (International Centre for Diffraction Data) หมายเลข 01-073-1767

Pattern : 01-073-1767		Radiation =	1.5405	98		(Quality : Alternate			
γ-W₂B Tungsten Boron		22582 32149 37934 40930 44597 46105 50551 51927 61180 63330	/ 105 249 273 999 44 29 138 102 16 1 70	h 12021223238	k 1001120122	1 0 0 2 1 2 0 2 0 2 1 2				
Lattice : Body-centered tetrago S.O. : 14/mcm (140) a = 5.56400 c = 4.74000 Z =	Mol. weight = 370.51 Volume [CD] = 146.74 Dx = 17.133 Dm = 16.000 4	66 084 67 253 70 552 71 940 72 812 76 506 79 808 81 089 84 334 85 513 88 493 88 735 89 910	70 13 142 58 145 6 16 20 69 3 1 5 15	3423444031342	1013120031220	2030102424324				
ICSD collection code: 024279 Test from ICSD: No R value gin Test from ICSD: At least one Ti Test from ICSD: Calle. density u Additional pattern: See FDF 6 Data collection flag: Ambient.	ven. F missing anusual but tolerable. -591 and 89-1991.				8					
Klessling, R., Acta Chem. Scant Calculated from ICSD using POI	z., volume 1, page 893 (1947) WD-12++ (1997)	รัพ หา ²	ย	n	' ก ยา	วี	ลัย			
Radiation : CuKa1	Filter : Not specified	1.1	1			1				
wc	tern : 03-065-4539			Radiation = 1.540598				Quality : Calculated		
--	--	--	------------------	----------------------	-------	--------------	----------	----------------------	--	--
			2th	1	h	k	1	I I		
			31.578	441	0	0	1			
Cartoo Turoaten			48.411	850	1	0	1			
Carbon Tungsten			65.938	53	ò	ò	2			
			73.292 75.675	177 85	2	0	1			
			77.316	158	1	0	2			
			99.016	88	1	1	2			
			108.482	10	0	0	3			
lattine - Havannal		Mod unight = 105 85	110.173	62 128	2	1	2 1			
Cannee : Hexagonal		Mor. Weight - 150.50	133,892	30	3	0	0			
S.G. : P-6m2 (187)		Volume [CD] = 20.82	147.285	49	3	0	3			
a = 2.90000		Dx = 15.774								
c = 2.83100										
9	Z = 1	Meor = 15.30								
	_	1 1 1 3.016.								
WST M&A collection of	de: L 50988	ST1364 0								
remperature factor: TF	Isotropic TF g	liven by author	14							
Sample preparation: Th	a comela una	prepared by carburizing the tungsten								
and the later of t	e annipe sea									
ilm under CO atmospher Remarks from ICSD/CS	re at 600-1000	ò.	42 3							
film under CO atmosphe Remarks from ICSD/CS Data collection flag: Am	re at 600-1000 D: thin films. nbient.	6. ·	120							
im under CO atmosphe. Remarks from ICSD/CS Data collection flag: An	re at 600-1000 D: thin films. nbient.									
im under CO atmosphe Remarks from ICSD/CS Data collection flag: An	re at 600-1000 D: thin films. nbient.									
ilm únder CO atmosphe Remarks from ICSDICS Data collection flag: An	re at 600-1000 Dr thin films, nbient,		6							
im under CO atmosphe Remarks from ICSD/CS Data collection flag: An	re at 600-1000 D: thin films, nbient,		R							
fim under CO atmospher Remarks from ICSD/CS Data collection flag: An	re at 600-1000 D: thin films. hbient.									
film under CO atmosphe Remarks from ICSD/CS Data collection flag: An	re at 600-1000 ID: thin films, Ibient,					0				
film under CO atmosphe Remarks from ICSDICS Data collection flag: An	re at 600-1000 ID: thin films. nbient.					8				
fim under CO atmosphe Remarks from ICSDICS Data collection flag: An	re at 600-1000 ID: thin films. hbient.					8				
fim under CO atmosphe Remarks from ICSDICS Data collection flag: An	re at 600-1000 ID: thin films. Iblent.					8				
fim under CO atmosphe Remarks from ICSDICS Data collection flag: An	re at 600-1000 ID: thin films. Iblent.				Cable	8				
fim under CO atmosphe Remarks from ICSDICS Data collection flag: An	re at 600-1000 ID: thin films. Iblent.				Cable	8				
fim under CO atmosphe Remarks from ICSDICS Data collection flag: An	re at 600-1000 ID: thin films. Iblent.					8				
fim Under CO atmosphe Remarks from ICSDICS Data collection flag: An	re at 600-1000 ID: thin firms. Tolent.			2		8	5			
Remarks from ICSDICS Data collection flag: An	e at 600-1000 ID: thin films. Iblent.	C.	5 W	2		8	<u>ر</u>			
Remarks from ICSDICS Data collection flag: An Butorina, L. N., Sov. Phy (1960)	e at 600-1000 ID: thin films. Iblent.	(Engl Transl.), volume 5, page 216	5 %	2		ล	5			
film Under CO atmosphe Remarks from ICSDICS Data collection flag: An Butorina, L. N., Sov. Phy (1960) Calculated from NIST us	e at 600-1000 ID: thin films. hbient.	Engl Transl.), volume 5, page 216	5 %	2		อ	ŝ	~		
Im under CO atmosphe Remarks from ICSDICS Data collection flag: An Butorina, L. N., Sov. Phy 1960) Calculated from NIST us	e at 600-1000 ID: thin films. hbient.	(Engl Transl.), volume 5, page 216	5 W	2		ล	ر م	ລັຍ		
Im under CO atmosphe Remarks from ICSDICS Data collection flag: An Butorina, L. N., Sov. Phy 1960) Calculated from NIST us	e at 600-1000 ID: thin films. hbient.	(Engl. Transl.), volume 5, page 216 +	รัพ	2		อ	ر م	ลัย		
Remarks from ICSDICS Data collection flag: An Butorina, L. N., Sov. Phy 1960) Salculated from NIST us	e at 600-1000 ID: thin films. hbient.	(Engl Transl.), volume 5, page 216	รัพ	21		ล ก ย	ري ا	ลัย		
Remarks from ICSDICS Data collection flag: An Butorina, L. N., Sov. Phys 1960) Salculated from NIST us	e at 600-1000 ID: thin films. hbient.	(Engl Transl.), volume 5, page 216	รัพ	21		ล ก ย	ر م	ลัย		
Remarks from ICSDICS Data collection flag: An Butorina, L. N., Sov. Phys (1960) Calculated from NIST us)	e at 600-1000 ID: thin films. hbient.	(Engl Transl.), volume 5, page 216	รัพ	2		ล ก ย	ر م	ลัย		
Remarks from ICSDICS Data collection flag: An Butorina, L. N., Sov. Phy (1960) Calculated from NIST usi	re at 600-1000 ID: thin films. hbient.	c. (Engl. Transl.), volume 5, page 216	รัพ	ย		ค ก ย'	ري	ลัย		
Remarks from ICSDICS Data collection flag: An Butorina, L. N., Sov. Phy (1960) Calculated from NIST usi Radiation : Cultor1	re at 600-1000 ID: thin films. hbient.	Engl Transl.), volume 5, page 216	รัพ	ยาวิท		ร 1 ยา	ر م	ลัย		
Remarks from ICSDICS Data collection flag: An Butorina, L. N., Sov. Phy (1960) Calculated from NIST usi Radiation : CuKa1	re at 600-1000 ID: thin films. hbient.	Engl. Transl.), volume 5, page 216	รัพ	21		ค ก ย	ر م	ลัย		
Rediation : CuKa1 Lambda : 1.54060	re at 600-1000 ID: thin films. hbient.	Engl. Transl.), volume 5, page 216	รัพ	2		ี ใ 1	ر م	ลัย		
Im Under CO atmosphe Remarks from ICSDICS Data collection flag: An Sutorina, L. N., Sov. Phy 1960) Dataculated from NIST usi Radiation : CuKa1 Lambda : 1.54060 SS/FOM : F17=1000(0.0	re at 600-1000 ID: thin films. hbient.	C. (Engl. Transl.), volume 5, page 216 + Filter : Not specified d-sp : Calculated specings	รัพ	2		ร ก ย	ري ا	ลัย		
Remarks from ICSDICS Data collection flag: An Butorina, L. N., Sov. Phy 1960) Dalculated from NIST us Radiation : CuKa1 Lambda : 1,54060 BS/FOM : F17=1000(0.0	re at 600-1000 ID: thin films. hbient.	(Engl. Transl.), volume 5, page 216 * Filter : Not specified d-sp : Calculated spacings	รัพ	2		ล ก ย	ر م	ลัย		

2 State 1990 at 21 Constants		Radiation =	1.5405	598			Quality : Calcu	lated
W ₂ C Tungsten Carbide		2th 18,779 19,771 27,400 34,596 38,087 39,653 40,164 43,271 44,686 52,394 54,030 56,545	2 3 1 226 235 999 1 1 152 1	# 01110101010N	* 000101000110	101021021000		
Lettice : Hexagonal S.G. : P-31m (162) a = 6.18090 c = 4.72160 Z = 3	Mol. weight = 379.71 Volume (CD) = 109.76 Dx = 17.234 Wear = 11.12	57,716 58,606 62,001 62,488 65,403 68,011 69,875 72,986 73,434 75,135 76,150 79,605 81,472 81,472 81,472 84,874 85,429 86,743	3 1 163 1 153 20 1 153 111 1 21 1 21 1 28	*****	00001100001000010			
NIST M&A collection code: N AL88 Temperature factor: IB=W.C Data collection flag: Ambient. B.Lonnberg, T.Lundstrom & R.Teligre	17 2271	89,785 90,592 91,836 95,020 96,894 99,977 100,748 103,764 104,207 105,328 106,927 109,449 112,473 112,938 114,978 116,799 118,277 120,507 121,800 123,993 124,513 126,272 126,807 120,507 121,800 123,933 124,513 126,272 126,807 120,505 133,365 134,733 135,809 138,025 142,655	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	destates bobenson a serve etholophone and en	201120061000001010000010000000000000000	1 -		
page 239-2 (1986) Calculated from NIST using POWD-1	ພາສາສາໂຍ	145.835 149.466 *149.466	1	5 -4	1 -2	0 5 2	ลัย	

ตารางที่ ข - 9 แสดงค่า 2θ, intensity และ hkl ของ W₂C ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานจาก JCPDS (International Centre for Diffraction Data) หมายเลข 03-065-3896

ตารางที่ ข - 10 แสดงค่า 20, intensity และ hkl ของ ZrO ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานจาก JCPDS (International Centre for Diffraction Data) หมายเลข 00-051-1149

200 C		Radiation =		598			Quality : High
ZrO Zirconium Oxide		2th 33.530 38.904 56.215 67.061 70.462 83.527 93.095 96.288 109.303	/ 100 91 48 35 13 9 12 18 14	h 100804344	k 102120322	100120102	
Lattice : Face-centered cubic S.G. : Fm-3m (225) a = 4.62580 Z = 4	Mol. weight = 107.22 Volume [CD] = 98.98 Dx = 7,195						
Sample preparation: A mixture of C and held for 0.5 hours under 7 M Additional pattern: See 20-684 fo Data collection flag: Ambient,	20 w1% Al and Zr O2 was heated to 1500 Pa pressure, r calculated intensities and d-values,						
					8		
Zhe, X., Hendry, A., J. Mater. Sci. I	Lett., volume 17, page 687 (1998)	รัพ	2		8	ĩ	

ตารางที่ ข - 11 แสดงค่า 20, intensity และ hkl ของ ZrO₂ ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานจาก JCPDS (International Centre for Diffraction Data) หมายเลข 01-089-9066

Pattern : 01-089-9066		Radiation =	1.5405	598			Quality : Ca	liculate	d		
ZrO2 Zirconium Oxide Zirconia, syn		2th 17,439 24,066 24,462 28,213 31,457 34,155 34,433 35,299 35,931 38,587 38,587 38,887 39,435	1 53 102 110 999 659 265 134 149 25 7 28 6 10	h 1011100210012	k 0 1 1 1 0 2 0 0 1 2 2 1	01011200000100	2th 83,750 83,872 84,024 84,241 84,872 86,250 *86,250 *86,250 *86,250 *86,250 86,088 87,478 88,133 88,411 *88,411	7 14 9 11 16 16 16 12 12 14 30 30	# + nn + nn + n + nn + nn	k 4332420244221	2121104421423
Lattice : Monoclinic S.G. : P21/c (14) a = 5.14600 b = 5.20500 beta = 99.10 c = 5.31300 a/b = 0.08866 Z = 4 c/b = 1.02075	Mol. weight = 123.22 Volume [CD] = 140.52 Dx = 5.824 Mcor = 4.97	40,011 40,766 41,114 41,428 44,708 45,573 49,284 50,139 50,616 51,246 54,031 54,677 55,274 55,380 55,639 55,761 55,975 55,761	2 129 51 29 60 58 123 207 111 35 77 77 9 41 86 535 47 73	191110901000100000000000000000000000000	11021022220022111331	21212220212021202100100	88,762 89,222 89,903	13 9 20	17 24	101	4 4 3
ICSD collection code: 089426 Remarks from ICSD/CSD: REM Temperature factor: ITF Data collection flag: Ambient.		57,942 58,346 59,827 60,109 61,320 62,296 62,296 64,342 64,342 64,342 65,450 65,661 68,951 69,044 70,284 70,284 70,270 71,148 71,309 71,2594 72,594 73,698 73,939 74,657	733 545 494 849 60 887 7222 522 60 811 2 4 1 1925 8 13 19 19 7 4 16	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	132301111123233223220200314110						
Wang, DN., Guo, YO., Liang, KM., Phys., Astron., volume 42, page 80 (199 Calculated from ICSD using POWD-12+	Tao, K., Sci. China, Ser. A: Math., 19) *	75, 165 75, 334 76, 468 77, 047 77, 426 77, 426 77, 426 77, 645 78, 007 78, 184 78, 750 78, 975 78, 975 80, 307 90, 561	34 18 17 25 9 12 12 8 6 6 20 20 3 2	0-4-4-4-4-4-04-4-0	441413300413321	-003342-40-34	ลัย				
Radiation : CuKa1 Lambda : 1.54060 SS/FOM : F30=375(0.0024,34)	Filter : Not specified d-sp : Calculated spacings	80.561 80.737 81.386 81.649 82.249 82.560 82.722 83.031 83.204 83.379	3 3 27 7 20 12 7 18 14	-401010492	122234134	4234432130					

1 57 164 118 999 999 122 219 122 228 1 11 6 148 67 67 17 168 67 17 168 214	# 101110001001011111	k 0111102001221101	1 010112002010020	2th *83,682 84,394 *84,394 84,516 84,668 84,801 85,139 85,391 85,590 86,200 87,766 87,768 87,768	/ 22 16 16 11 18 9 18 22 6 22 6	h 0342314	* 400404	1 2 1 1 0
57 164 118 999 999 122 157 28 11 6 51 21 148 67 67 67 67 17 168 224		0111102001221101	010112002210022	*83,682 84,394 *84,394 84,516 84,668 84,801 85,391 85,391 85,990 06,200 87,768 87,938	22 16 11 16 9 18 22 16	0342974	404404	2 1 1 0
164 118 999 897 219 122 157 28 11 51 21 148 44 17 67 67 17 168		111102001221101	10112002210022	84.394 84.394 84.516 84.668 84.801 85.139 85.391 85.990 85.200 87.766 87.938 87.938	16 16 11 16 9 18 22 16	342314	00404	1
118 999 897 122 157 28 11 6 148 44 4 167 67 168 214		11102001221101	0112002210022	*84.394 84.516 84.668 85.139 85.391 85.990 86.200 87.766 87.938 *87.938	16 11 16 9 18 22 16	4 1 4 1 4	1434	0
897 897 122 157 28 11 51 22 11 6 148 44 167 67 168 214		102001221101	1 20 0 2 2 1 0 0 2 6	84,668 84,668 84,801 85,139 85,391 85,990 86,200 87,766 87,938	16 9 18 22 16	-3 -1 4	3 4	· •
219 122 157 28 1 16 148 44 1 67 67 67 17 168 214		02001221101	2002210020	84.801 85.139 85.391 85.990 86.200 87.766 87.938 87.938	9 18 22 16	-1	4	5
122 157 28 1 51 28 11 6 148 44 1 67 67 67 17 168 214	021001211911	20012211010	0 0 2 2 1 0 0 2 2	85.139 85.391 85.990 86.200 87.766 87.938	18 22 16	- 4		2
157 28 11 148 148 44 167 67 67 168 214	110010110110	0012211010	02210022	85.391 85.990 86.200 87.766 87.938	16	1.0	2	0
51 211 148 44 67 67 17 168 214	001211211	1221101	210020	86.200 87.766 87.938	10	3	6	4
51 2 11 6 148 44 44 1 67 67 67 17 168 214	01211211	221101	10020	87.766 87.938 *87.938	12	-2	2	4
2 11 6 148 44 148 67 67 67 17 168 214	1211211	2 1 1 0 1	0 2 2	87.938	23	1	2	4
6 148 148 44 1 67 67 67 17 168 214	-1 -2 -1 -1	101	2		33	1	4	2
148 148 44 1 67 67 67 17 168 214	1211	0		88.523	26	2	4	1
148 44 1 67 67 67 17 168 214	-2 -1 1	1		*88.523	26	-3	1	4
1 67 67 17 168 214	1		1	89.947	26	-4	1	3
67 67 17 168 214		2	31		- 1			
67 67 17 168 214	11	1	2		- 1			
67 17 168 214	2	1	1		- 1			
168	-2	0	2		- 1			
214	ō	2	2					
	2	2	0					
122	-1	2	2					
52	-2	2	-					
14	3	ő	0					
8	1	2	2					
90	0	1	3					
72	-1	3	3		- 1			
71	1	3	ó					
39	2	1	2		- 1			
83	2	1	1		- 1			
68	-1	3	1					
65	-3	0	2					
83	1	3	1		- 1			
57	1	1	3					
101	3	1	1					
11	0	2	3					
17	-1	2	3					
50	2	3	2					
50	2	3	ô					
37	3	2	0					
37	-1	3	2					
23	1	3	2					
23	1	2	3					
1	2	3	1					
7	-43	ő	2					
36	-1	0	4					
14	0	0	4					
21	20	2	2					
12	2	3	2					
6	-3	1	3					
11	0	4	0					
41	8	4	1		- 1			
31	1	4	o					
31	-4	1	1	<i>w</i>				
13	4	1	0	0 01				
7	0	3	3	CI 21				
7	-1	3	3	01 LJ				
8	-1	4	1					
8	4	0	2					
3	2	3	2					
14	3	3	õ					
13	-3	3	1					
9	1	4	1					
	2	2	3					
5	3	2	2					
5 2	-1	2	4					
5 2 1 20	0	2	4					
5 2 1 20 6	1	1	3					
5 2 1 20 6 18 5	the second se	100	4					
	3 14 13 9 5 2 1 20 6 18 6	12 3 7 1 2 4 3 1 0 1 4 14 13 9 5 2 1 0 6 18 5	- 3 3 3 4 2 1 2 2 2 3 1 3 3 4 3 9 5 2 1 2 2 2 3 1 3 5 2 1 2 4 3 -1 0 1 4 2 5 2 1 20 6 18 5 2	3 14 13 3 1 2 2 2 4 13 3 3 1 2 2 2 4 1 2 2 4 3 1 4 3 3 1 2 2 2 4 1 2 2 4 4 1 3 2 6 1 1 3 20 6 1 4 3 1 3 5 2 1 2 2 4 4 1 8 5 2 1 3 1 2 0 1 1 1 3 2 2 4 4 1 8 5 2 1 3 1 1 3 2 0 1 1 1 3 2 2 4 4 1 8 5 2 1 3 1 1 3 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 2 3 2 14 3 13 3 14 3 14 3 15 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 4 1 1 3 2 1 2 2 4 1 1 3 5 4 1 1 5 4 1 3 2 2 3 3	3 2 3 2 14 3 3 0 13 -3 1 1 5 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 20 -1 2 4 18 1 3 3 5 4 3 3 20 -1 2 4 18 1 3 3 22 -2 3 3	3 2 3 2 14 3 3 0 13 -3 3 1 9 1 4 1 5 2 2 3 2 -4 1 2 1 3 2 2 20 -1 2 4 6 0 2 4 19 1 3 3 5 4 1 1 22 -2 3 3	3 2 3 2 14 3 3 0 13 -3 3 1 9 1 4 1 5 2 2 3 2 -4 1 2 1 3 2 2 20 -1 2 4 6 0 2 4 18 1 3 3 5 4 1 1 22 -2 3 3

ตารางที่ ข - 13 แสดงค่า 2θ, intensity และ hkl ของ ZrO₂ ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานจาก JCPDS (International Centre for Diffraction Data) หมายเลข 01-080-2155

Pattern : 01-080-2155		Radiation =	1.0.14	121		_		aiculated	
ZrO _{1.99}		2th 30.270 34.960	/ 999 85	h 1 0	* 00	1 1 2		1	[]
Zirconium Oxide		35,160 43,254 50,424 50,574 53,845 59,816 60,083 62,958 68,890 73,846 74,325	137 2 302 306 1 102 199 46 1 15	1112012200	10100010105	0000101010040			
Lattice : Tetragonal	Mol. weight = 123.06	79.222 82.076	1 58	1 2	0	4 3			
S.G. : P42/nmc (137)	Volume [CD] = 66.72	84.505 84.852	17	1 2	1 2	4 2			
a = 3.60670	Dx = 6.125	84.967	17	3	1	0			
c = 5.12900 Z = 2	Ncor = 9.72								
	2//12								
ICSD collection code: 070014 Temperature factor: ATF Remarks from ICSD/CSD: REM Remarks from ICSD/CSD: REM Remarks from ICSD/CSD: REM refinement of cub Test from ICSD: At least one TF In Temperature factor: ITF Additional pattern: See PDF 81-11 Data collection flag: Ambient.	TEM 296. RVP. F Interstitial-atom model - tetragonal nplausible. 545.				8				
ICSD collection code: 070014 Temperature factor: ATF Remarks from ICSD/CSD: REM Remarks from ICSD/CSD: REM Remarks from ICSD/CSD: REM refinement of cub Test from ICSD: At least one TF in Temperature factor: ITF Additional pattern: See PDF 81-1: Data collection flag: Ambient.	TEM 296. RVP. F Interstitial-atom model - tetragonal nplausible. 545. ta Crystallogr., Sec. B: Structural Science. h-12++ (1997)	E W	81		ล		~		
ICSD collection code: 070014 Temperature factor: ATF Remarks from ICSD/CSD: REM Remarks from ICSD/CSD: REM Remarks from ICSD/CSD: REM Temperature factor: ITF Additional pattern: See PDF 81-11 Data collection flag: Ambient.	TEM 296. RVP. F Interstitial-atom model - tetragonal aplautible. 545. ta Crystallogr., Sec. B: Structural Science. 1-12++ (1997)	รัพ	21		ล	ر ا	ลัย		
ICSD collection code: 070014 Temperature factor: ATF Remarks from ICSD/CSD: REM Remarks from ICSD/CSD: REM Remarks from ICSD/CSD: REM Test from ICSD: At least one TF in Temperature factor: ITF Additional pattern: See PDF 81-11 Data collection flag: Ambient.	TEM 296. RVP. F Interstitial-atom model - tetragonal aplautible. 545. ta Crystallogr., Sec. B: Structural Science. 1-12++ (1997)	รัพ	21		3 1 2 1	ر ا	ลัย		
ICSD collection code: 070014 Temperature factor: ATF Remarks from ICSD/CSD: REM Remarks from ICSD/CSD: REM Remarks from ICSD/CSD: REM Test from ICSD/CSD: REM Test from ICSD: At least one TF in Temperature factor: ITF Additional pattern: See PDF 81-1: Data collection flag: Ambient.	TEM 295. RVP. F Interstitial-atom model - tetragonal aplausible. 545. ta Crystallogr., Sec. B: Structural Science. 1-12++ (1997)	5 %	21		ลิ	ر ع	ลัย		

99

ตารางที่ ข - 14 แสดงค่า 2θ, intensity และ hkl ของ ZrO₂ ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานจาก

Pattern : 01-079-1769		Radiation =	1.540	598			Quality : Calculated
ZrO2 Zirconium Oxide		2th 30.223 34.570 35.271 42.975 50.219 50.219 50.739 53.935 59.274 60.203 62.852 68.623 72.919	/ 999 81 124 14 320 171 106 200 47 3 15	A 10111N010000	. 001010001010		
Lattice : Tetragonal S.G. : P42/nmc (137) a = 3.59570 c = 5.18500 Z = 2	Mol. weight = 123.22 Volume (CD) = 67.04 Dx = 6.104 Vicor = 9.87	74.591 78.350 01.733 82.544 83.676 84.886 85.289	37 3 64 31 24 17 15	Q = Q B = Q B	4010191	0431420	
ICSD collection code: 066707 Remarks from ICSD/CSD: REM Temperature factor: ITF Additional pattern: See PDF 79-177 Deta collection flag: Ambient.	RVP. 11 and PDF 88-1007.				8		
Bondars, B., Heldemane, G., Grabis, J., Frey, F., J. Mater, Sci., volume 30 Calculated from ICSD using POWD-1	J., Laschke, K., Boysen, H., Schneider, page 1621 (1995) 12++ (1997)	ว พ หาว่	ב ק	N	(1 ย) J	ลัย
Radiation : CuKa1 Lambda : 1.54060 SS/FOM : F19=1000(0.0002,20)	Filter : Not specified	-					

JCPDS (International Centre for Diffraction Data) หมายเลข 01-079-1769

ตารางที่ ข - 15 แสดงค่า 2θ, intensity และ hkl ของ ZrO₂ ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานจาก JCPDS (International Centre for Diffraction Data) หมายเลข 00-007-0337

all sheet	attern : 00-007-0337		Radiation = 1.540598			Quality : Deleted	
ZrO2 Zirconium Oxide		210 30.591 35.452 50.674 60.459 63.493 74.886 82.870 85.668 96.189 104.229 104.229 118.396	100 60 100 30 30 30 30 30 30 30 30	E 1 NO 304 544 54	K 10012010210		
Lattlee : Face-centered cubic S.G. : Fm-3m (225) a = 5.07000 Z = 4	Mol. weight = 123.22 Volume [CD] = 130.32 Dx = 6.280	127.873 131.454 147.575	30 20 20	0.00	3 1		
Deleted and rejected by: Deleted I Data collection flag: Amblent.	y 27-997.						
		all have					

ภาคผนวก ค

Temperature (°C)	Specimen Average grain size (µm)		Relative density (%TD)
	Al ₂ O ₃	-	94.82 ± 0.53
1400	Al ₂ O ₃ /WC	-	85.78 ± 0.44
	Al ₂ O ₃ /WC+6.0 wt% Ca-PSZ	-	75.18 ± 0.19
	Al ₂ O ₃	1.60 ± 0.28	97.61 ± 0.20
1500	Al ₂ O ₃ /WC	0.91 ± 0.13	93.18 ± 0.14
	Al ₂ O ₃ /WC+6.0 wt% Ca-PSZ	1.10 ± 0.15	83.08 ± 0.24
	Al ₂ O ₃	3.64 ± 0.71	99.21 ± 0.23
	Al ₂ O ₃ /WC	1.41 ± 0.24	99.03 ± 0.14
	Al ₂ O ₃ /WC+1.5 wt% Mg-PSZ	1.53 ± 0.39	96.08 ± 0.39
	Al ₂ O ₃ /WC+3.0 wt% Mg-PSZ	1.51 ± 0.24	98.75 ± 0.17
1600	Al ₂ O ₃ /WC+4.5 wt% Mg-PSZ	1.21 ± 0.24	95.84 ± 0.29
1000	Al ₂ O ₃ /WC+6.0 wt% Mg-PSZ	1.37 ± 0.32	95.55 ± 0.46
	Al ₂ O ₃ /WC+1.5 wt% Ca-PSZ	1.06 ± 0.56	96.83 ± 0.40
	Al ₂ O ₃ /WC+3.0 wt% Ca-PSZ	1.75 ± 0.58	97.54 ± 0.35
	Al ₂ O ₃ /WC+4.5 wt% Ca-PSZ	1.13 ± 0.28	97.75 ± 0.20
	Al ₂ O ₃ /WC+6.0 wt% Ca-PSZ	2.88 ± 0.75	98.20 ± 0.07

ตารางที่ ค - 1 ขนาดเกรนและความหนาแน่นของตัวอย่าง

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Temperature (°C)	Specimen	Vickers hardness (GPa)	Fracture toughness (MPa.m ^{1/2})	Flexural strength (MPa)
	Al ₂ O ₃	13.51 ± 0.45	4.64 ± 0.84	279.82 ± 68.74
1400	Al ₂ O ₃ /WC	8.98 ± 0.19	3.12 ± 0.26	192.58 ± 12.91
	Al ₂ O ₃ /WC+6.0 wt% Ca-PSZ	4.88 ± 0.16	2.77 ± 0.44	132.88 ± 11.13
	Al ₂ O ₃	15.18 ± 0.75	3.84 ± 0.58	325.70 ± 43.39
1500	Al ₂ O ₃ /WC	12.66 ± 0.54	3.19 ± 0.21	224.30 ± 37.03
	Al ₂ O ₃ /WC+6.0 wt% Ca-PSZ	7.64 ± 0.19	3.44 ± 0.20	244.91 ± 32.60
	Al ₂ O ₃	16.85 ± 0.80	3.78 ± 0.76	202.38 ± 31.45
	Al ₂ O ₃ /WC	19.05 ± 0.79	3.86 ± 0.42	324.45 ± 34.21
	Al ₂ O ₃ /WC+1.5 wt% Mg-PSZ	17.11 ±0.37	4.77 ± 0.33	224.42 ± 15.86
	Al ₂ O ₃ /WC+3.0 wt% Mg-PSZ	17.84 ± 0.53	4.60 ± 1.00	202.11 ± 32.92
1600	Al ₂ O ₃ /WC+4.5 wt% Mg-PSZ	17.00 ± 0.44	4.29 ± 0.46	213.35 ± 39.96
1000	Al ₂ O ₃ /WC+6.0 wt% Mg-PSZ	16.71 ± 0.32	5.07 ± 0.49	294.03 ± 23.11
	Al ₂ O ₃ /WC+1.5 wt% Ca-PSZ	16.36 ± 0.31	4.25 ± 0.58	336.22 ± 12.07
	Al ₂ O ₃ /WC+3.0 wt% Ca-PSZ	14.85 ± 0.57	5.10 ± 0.66	283.75 ± 13.29
	Al ₂ O ₃ /WC+4.5 wt% Ca-PSZ	15.98 ± 0.28	5.14 ± 1.04	339.60 ± 21.40
	Al ₂ O ₃ /WC+6.0 wt% Ca-PSZ	14.49 ± 0.27	5.67 ± 1.90	270.71 ± 17.49

ตารางที่ ค - 2 สมบัติทางกลของตัวอย่าง



ุ คูนยวทยทรพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวจิราพร บุญพอ เกิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2528 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2550 หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเซรามิก ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2553

<u>การนำเสนอผลงานทางวิชาการ</u>

"Effect of Mg-PSZ addition on hardness and toughness of Al₂O₃/WC composites" การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

2 "Characteristics and properties of Al₂O₃/WC toughened by Ca-PSZ". The 1st National Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals and Advanced Materials. Montien Hotel, Bangkok. วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

<u>การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ</u>

1. "Effect of a Mg-PSZ additive on hardness and fracture toughness of the Al₂O₃/WC composites". The 5th Mathematics and Physical Sciences Graduate Congress (MPSGC). Chulalongkorn University, Bangkok. ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

"The influence of Mg-PSZ addition on microstructure and mechanical properties of the Al₂O₃/WC composites". Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2010). Sunce Grand Hotel and Convention Center, Ubonratchathani. ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม พ.ศ. 2553 และในการนำเสนอผลงานครั้งนี้ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานแบบ Proceeding